СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ	2
Понижающий (Buck) преобразователь мощностью до нескольких киловатт	. 2
Повышающий (Boost) преобразователь мощностью до нескольких киловатт	3
Инвертирующий (Buck-Boost) преобразователь	4
Обратноходовой (Flyback) преобразователь мощностью до 200 Вт	. 5
Прямоходовой (Forward) преобразователь	. 7
Прямоходовой двухтранзисторный (Two-Transistor Forward) преобразователь	8
Полумостовой (Half-Bridge) преобразователь	9
Мостовой (Full-Bridge) преобразователь	. 10
Корректоры коэффициента мощности (PFC)	
Сравнение схемных решений	14
РАЗНОВИДНОСТИ ПРЯМОХОДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	15
Классическая схема	15
Прямоходовой преобразователь с RCD-демпфирующей цепочкой	15
Прямоходовой преобразователь с LCDD-демпфирующей цепочкой	15
Прямоходовой преобразователь с резонансной схемой размагничивания трансформатора	16
Прямоходовой преобразователь с двумя ключами	16
Прямоходовой преобразователь с активной ограничивающей цепью	. 16
Прямо-обратноходовой преобразователь	
Двойной прямоходовой преобразователь	17
Сравнение различных схем прямоходовых преобразователей	18
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КВАЗИРЕЗОНАНСНЫХ И РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	19
Описание принципов работы мостового (Phase-Shift) преобразователя на примере контроллера	
Renesas HA16163	
Описание принципов работы квазирезонансных обратноходовых (Flyback) преобразователей	21
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ	
Проектирование обратноходового трансформатора	
Проектирование прямоходового трансформатора	22
Проектирование прямоходового дросселя	. 23
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБРАТНОХОДОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА COOLSET INFINEON	. 24
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ	. 28
Понижающие (Buck) преобразователи со встроенным ключом National Semiconductor	. 28
Понижающие (Buck) контроллеры в том числе и многоканальные National Semiconductor	. 31
Повышающие (Boost) преобразователи со встроенным ключом National Semiconductor	. 33
Сдвоенные преобразователи National Semiconductor	33
Повышающие (Boost) контроллеры National Semiconductor	34
Микросхемы для синхронного выпрямления International Rectifier	34
Микросхемы International Rectifier для построения низковольтных высокоэффективных	
Виск-преобразователей	34
N-канальные транзисторы Infineon OptiMOS®2&3 85 V и 100 V для DC/DC-преобразователей	. პ/
N-канальные транзисторы Infineon OptiMOS®2&3 25-40V DC/DC-преобразователей	
Транзисторы Infineon CoolMOS на рабочее напряжение 500, 600, 650, 800 В	41 7.7
Диоды NXP для корректоров коэффициента мощности	
диоды Infineon для корректоров коэффициента мощности на основе карбида кремния (sic)	
диоды пппеоп для корректоров коэффициента мощности на основе кароида кремния (sic) Микросхемы управления AC/DC источником питания со встроенным ключом CoolSet Infineon	
Микросхемы управления AC/DC Infineon	. 44
Микросхемы управления DC/DC Vishay	
Трансформаторы Wurth Elektronik для построения DC/DC-преобразователей серии WE-FLEX	. 4 5
Трансформаторы Wurth Elektronik для построения Flyback DC/DC-преобразователей серии WE-PoE	,
и WE-PoE Plus	. 48
Трансформаторы Wurth Elektronik для построения Flyback AC/DC-преобразователей	. 3
серии WE-UNIT	49
Дроссели Wurth Elektronik для построения маломощных DC/DC-преобразователей серии WE-PD4	49
серии WE-PD3	51
серии WE-PD2	
серии WE-PD	
Дроссели для подавления помех Wurth Elektronik	
Дроссели для подавления помех Murata	
Оптопары Vishay	
Список рекомендуемой литературы	ၓՍ

■ Понижающий (Buck) преобразователь мощностью до нескольких киловатт

Понижающий (buck) преобразователь (рис. 1) относится к разряду прямоходовых схем. Он позволяет получать выходную мощность в несколько киловатт. Предназначен для использования в тех случаях, когда не нужна изоляция между первичной и вторичной сторонами.

В момент, когда ключ замкнут, входное напряжение подаётся через LC-фильтр на нагрузку. Ток через индуктор линейно повышается:

$$\dot{\boldsymbol{i}}_{Lon} = \frac{(\boldsymbol{V}_{in} - \boldsymbol{V}_{out})\boldsymbol{t}_{on}}{L} + \dot{\boldsymbol{i}}_{0}$$

Энергия, запасённая в индукторе в течение периода, равна:

$$E = \frac{L(i_{\text{max}} - i_{\text{min}})^2}{2}$$

В момент размыкания ключа ток через индуктор продолжает протекать в том же направлении (напряжение на индукторе сменило полярность), диод смещается в прямом направлении, образуется токовый контур: диод — индуктор — нагрузка. Энергия, запасённая в индукторе, частично отдаётся в нагрузку. В момент выключения ток через индуктор линейно снижается.

$$i_{Loff} = i_{max} - \frac{V_{out} t_{off}}{L}$$

Когда ключ замыкается, диод запирается, и ток через индуктор начинает расти.

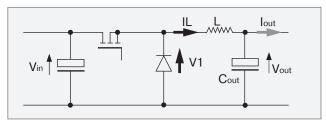


Рис.1. Схема понижающего (buck) преобразователя.

Индуктор может работать как в режиме непрерывных токов (рис. 2), так и в прерывистом режиме (рис. 3). Использование прерывистого режима на больших мощностях нежелательно, поскольку в этом режиме через ключ протекает большой ток и велик уровень пульсаций тока в выходном конденсаторе.

Индуктивность дросселя вычисляется по следующей формуле:

$$L = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(V_{in_max} - V_{out}\right) \left(\frac{V_{out} + V_F}{V_{in_max} + V_F}\right) \cdot \left(\frac{1}{\Delta L_L}\right)$$

Для режима непрерывных токов $\Delta I_L \le 2I_{out}$

$$\Delta I_{L} = \left(\frac{1}{L}\right) \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot t_{on}$$

$$t_{on} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_{F}}{V_{in} + V_{F}}\right)$$

$$I_{max} = I_{out} + \frac{1}{2}\Delta I_{L} \quad \text{fige}$$

 $V_{\scriptscriptstyle F}$ — прямое падение на диоде, $I_{\scriptscriptstyle max}$ — максимальный ток через ключ.

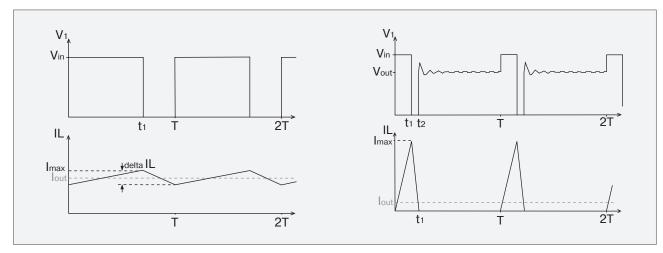


Рис. 2. Диаграммы напряжения и тока для режима непрерывного тока в индукторе.

Рис. 3. Диаграммы напряжения и тока для прерывистого режима.

Для прерывистого режима $\Delta I_{L} > 2I_{out}$

$$t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L \cdot \left(\frac{V_{out} + V_F}{f(V_{in} - V_{out}) \cdot (V_{in} + V_F)}\right)}$$

$$t_{off} = t_{on} \left(\frac{V_{in} + V_F}{V_{out} + V_F}\right)I_{max} = \frac{1}{L} \cdot (V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}$$

Для повышения эффективности вместо диода может также использоваться транзистор с дополнительной схемой управления, связанной с ШИМ-контроллером (синхронный выпрямитель). Применение синхронного выпрямителя позволяет существенно повысить КПД преобразователя. Так, например, в типовом случае понижающий преобразователь без

синхронного выпрямителя имеет КПД, равный 86%, а с ним — 95%. В устройствах, рассчитанных на большие токи потребления (например, в схемах питания процессоров), часто используется многофазное преобразование, что позволяет снизить токи пульсаций и тем самым снизить нагрузку на выходные ёмкости и уменьшить габариты индуктора (суммарный объём, занимаемый им на монтажной плате).

Компания National Semiconductor предлагает целый ряд специализированных микросхем, предназначенных для построения понижающих (buck) преобразователей. Имеются контроллеры для управления внешними ключами, в том числе и с синхронным выпрямителем, а также конвертеры со встроенными ключами и сдвоенные понижающие конвертеры/контроллеры (см. раздел «Компоненты для построения источников питания»).

■ Повышающий (Boost) преобразователь мощностью до нескольких киловатт

Повышающий (Boost) преобразователь (рис.4.) относится к типу обратноходовых схем. Его особенность — выходное напряжение всегда больше входного. Выходная мощность может составлять сотни ватт в прерывистом режиме и до нескольких киловатт в непрерывном режиме.

Когда ключ замкнут, ток через индуктор линейно нарастает, диод заперт.

$$i_L(t_{on}) = \frac{V_{in} \cdot t_{oi}}{L}$$

Энергия, запасённая в индукторе, равна

$$E = \frac{Li_{\text{max}}^2}{2}$$

В момент размыкания ключа ток через индуктор продолжает течь. Напряжение на индукторе увеличивается. Когда оно достигает значения V_{in} , диод открывается, напряжение на индукторе увеличивается до напряжения V_{out} и фиксируется. Этот уровень называется напряжением обратного хода. Индуктор на обратном ходу отдаёт накопленную энергию в нагрузку. При этом ток в нём линейно уменьшается:

$$i_L(t_{off}) = i_{\max(on)} - \frac{(V_{out} - V_{in})t_{off}}{L}$$

Энергия, отданная индуктором в секунду, должна быть достаточной для питания нагрузки:

$$P_{load} < f\left(\frac{L\,\dot{i}_{max}^2}{2}\right)$$

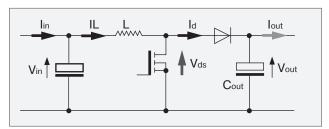


Рис. 4. Схема повышающего (boost) преобразователя.

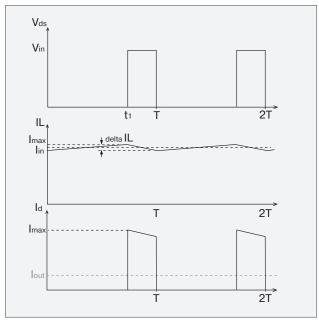


Рис. 5. Диаграммы напряжения и токов в непрерывном режиме.

Индуктор может работать как в режиме непрерывных токов (рис. 5), так и в прерывистом режиме (рис. 6).

Для расчёта преобразователя необходимо знать величины следующих параметров: V_{in_min} , $V_{in_}$, V_{out} , I_{out} , f .

$$L = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(V_{out} + V_F - V_{in_min}\right) \cdot \left(\frac{V_{in_min}}{V_{out} + V_F}\right) \cdot \left(\frac{1}{\Delta I_L}\right)$$

Для режима непрерывных токов $\Delta I_L < 2I_{in}$.

$$t_{on} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_{F} - V_{in}}{V_{out}}\right)$$

$$\Delta I_{L} = \frac{1}{L} \cdot V_{in} \cdot t_{on} \qquad I_{max} = I_{in} + \frac{1}{2} \Delta I_{L}$$

Для прерывистого режима $\Delta I_L > 2I_{out}$.

$$t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L \cdot \left(\frac{V_{out} + V_F - V_{in}}{f \cdot V_{in}^2}\right)}$$

$$t_{off} = t_{on} \cdot \left(\frac{V_{out} + V_F}{V_{out} + V_F - V_{in}}\right) I_{max} = \frac{1}{L}V_{in} \cdot t_{on}$$

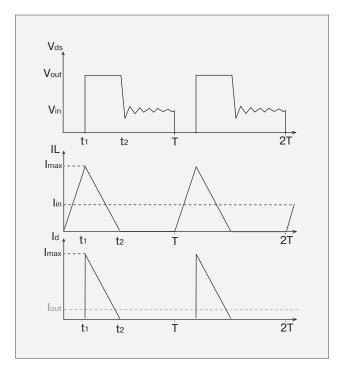


Рис. 6. Диаграммы напряжения и токов для прерывистого режима.

В разделе «Компоненты для построения источников питания» приведены схемы повышающих (Boost) преобразователей со встроенным ключом и повышающих контроллеров National Semiconductor.

Инвертирующий (Buck-Boost) преобразователь

Этот преобразователь также относится к обратноходовым схемам. Его особенность: выходное напряжение преобразователя имеет отрицательную полярность относительно земли.

Когда ключ замкнут, ток через индуктор линейно растёт и в нем запасается энергия. В момент размыкания ключа напряжение на индукторе меняет знак, ток продолжает течь через диод, заряжая конденсатор.

Как и рассмотренные выше преобразователи, инвертирующая схема также может работать в режиме непрерывного тока в индукторе (рис. 8) и в прерывистом режиме (рис. 9).

Выходное напряжение на выходе преобра-

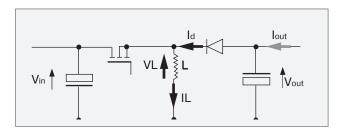


Рис. 7. Схема инвертирующего (Buck-Boost) преобразователя.

зователя в непрерывном режиме пропорционально входному напряжению V_{in} и рабочему циклу t_{on}/T , в прерывистом режиме — входному напряжению V_{in} и отношению времени нахождения во включённом состоянии и в выключенном.

Для расчёта схемы необходимо знать следующие параметры $V_{in\ min}$, $V_{in\ max}$, V_{out} , I_{out} , f .

$$\Delta I_{L} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(\frac{1}{L}\right) \cdot \left(V_{out} + V_{F}\right) \cdot \left(\frac{V_{in}}{V_{out} + V_{F} + V_{in}}\right)$$

$$I_{L} = I_{out} \cdot \left(\frac{V_{in} + V_{out} + V_{F}}{V_{in}}\right)$$

Для режима непрерывных токов $\Delta I_I < 2I_{in}$

$$t_{on} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_{F}}{V_{out} + V_{F} + V_{in}}\right)$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{L} \cdot V_{in} \cdot t_{on}$$
 $I_{max} = I_L + \frac{1}{2} \Delta I_L$

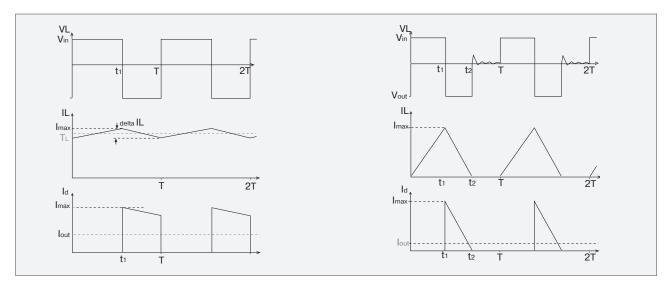


Рис. 8. Диаграммы напряжения и токов в режиме непрерывных токов.

Рис. 9. Диаграммы напряжения и токов для прерывистого режима.

Для прерывистого режима $\Delta I_L > 2I_{out}$

$$t_{on} = \sqrt{2 I_{out} \cdot L \cdot \left(\frac{V_{out} + V_F}{f \cdot V_{in}^2} \right)}$$

$$t_{off} = t_{on} \left(\frac{V_{out} + V_F + V_{in}}{V_{out} + V_F} \right) \quad I_{max} = \frac{1}{L} \cdot V_{in} \cdot t_{on}$$

Oбратноходовой преобразователь (Flyback converter) мощностью до 200 Вт

Обратноходовой (Flyback) преобразователь (рис. 10) по принципу работы аналогичен повышающему преобразователю (когда ключ находится в открытом состоянии (замкнут), энергия запасается в трансформаторе/индукторе, при разомкнутом ключе энергия передаётся в нагрузку).

Для расчёта преобразователя необходимо знать исходные данные $V_{in\ min}$, $V_{in\ max}$, V_{out} , I_{out} $u\ f.$

Индуктивность первичной обмотки $L_1 = \frac{V_{in_avg}^2}{8 \cdot \left(V_{out} + V_F\right) \cdot I_{out} \cdot f}$, где V_{In_avg} — среднее входное напряжение,

$$V_{In_avg} = \frac{\left(V_{in_\min} + V_{in_\max}\right)}{2}$$

Коэффициент трансформации равен:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_{in_avg}}{V_{out} + V_F}$$

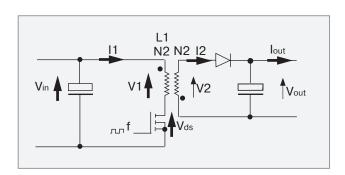


Рис.10. Схема обратноходового (Flyback) преобразователя.

Ток через первичную обмотку равен:

$$I_{L1} = I_{out} \cdot \left(\frac{1}{N_1/N_2}\right) \cdot \frac{V_{in} + (V_{out} + V_F) \cdot (N_1/N_2)}{V_{in}}$$

$$\Delta I_{L1} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(\frac{1}{L_1}\right) \cdot (V_{out} + V_F) \cdot \left(\frac{N_1}{N_2}\right) \cdot \frac{V_{in}}{(V_{out} + V_F) \cdot (N_1/N_2) + V_{in}}$$

Обратноходовой преобразователь может работать как в режиме непрерывного тока в трансформаторе (индукторе) (рис. 11), так и в прерывистом режиме (рис. 12). Следует отметить, что в непрерывном режиме схема очень нестабильна и склонна к автогенерации, поэтому преобразователи этого типа в основном проектируют для работы в прерывистом режиме.

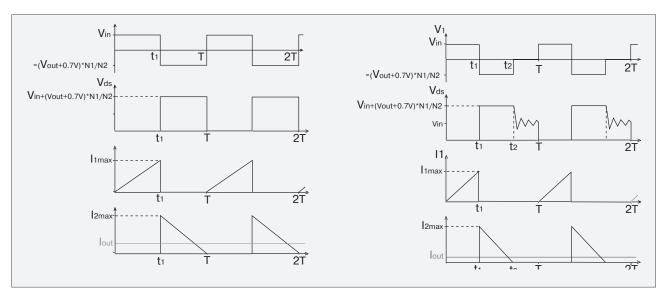


Рис. 11. Диаграммы напряжения и токов в режиме непрерывных токов.

Рис. 12. Диаграммы напряжения и токов для прерывистого режима.

Для режима непрерывных токов $\Delta I_{LI} < 2I'_{LI}$:

$$t_{on} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(V_{out} + V_{F}\right) \cdot \frac{\left(N_{1}/N_{2}\right)}{\left(V_{out} + V_{F}\right) \cdot \left(N_{1}/N_{2}\right) + V_{in}}$$

$$\Delta I_{L1} = \frac{1}{L_{1}} \cdot V_{in} \cdot t_{1} \qquad I_{1 \max} = I_{L1} + \frac{1}{2} \Delta I_{L1} \qquad I_{2 \max} = I_{1 \max} \cdot \frac{N_{1}}{N_{2}}$$

Для прерывистого режима $\Delta I_{LI} > 2I'_{LI}$:

$$t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L_1 \cdot \left(\frac{V_{out} + V_F}{f \cdot V_{in}^2}\right)}$$

$$t_{off} = t_{on} \cdot \left(\frac{\left(V_{out} + V_F\right) \cdot \left(N_1/N_2\right) + V_{in}}{\left(V_{out} + V_F\right) \cdot \left(N_1/N_2\right)}\right) \qquad I_{1 \max} = \frac{1}{L_1} V_{in} \cdot t_{on} \qquad I_{2 \max} = I_{1 \max} \cdot \frac{N_1}{N_2}$$

Прямоходовой (Forward) преобразователь

В отличие от обратноходовой схемы, в трансформаторе прямоходового преобразователя (рис. 3) энергия не запасается. Когда ключ открыт, к первичной обмотке прикладывается напряжение питания V_{in} . На обмотке N2 появляется напряжение, открывается диод D2, ток протекает через индуктор LC-фильтр в нагрузку. Когда ключ размыкается, открывается диод D3, энергия, запасённая в индукторе L, поступает в нагрузку. Размагничивание трансформатора происходит через дополнительную обмотку и диод D1.

Схема может работать как в режиме непрерывного тока в индукторе L (рис.14), так и в прерывистом режиме (рис.15).

Для расчёта необходимо знать следующие исходные данные $V_{_{in\ min}},\,V_{_{in\ max}},\,V_{_{out}},\,I_{_{out}}$ и f .

Коэффициент трансформации равен:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{in_min}}{V_{out} + V_F} \right) \cdot 0.95$$

Индуктивность дросселя:

$$L = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(V_{in_max}^{'} - V_{out}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_{F}}{V_{in_max}^{'} + V_{F}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\Delta I_{L}}\right)$$
где
$$V_{in_max}^{'} = \frac{V_{in_max}}{\left(N_{1}/N_{2}\right) - V_{F}}$$

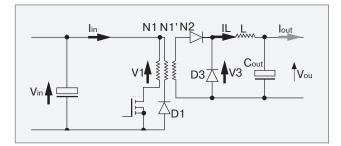


Рис. 13. Схема прямоходового (Forward) преобразователя.

Для режима непрерывных токов $\Delta I_{I} < 2I_{out}$:

$$t_{on} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_{F}}{V_{in} + V_{F}}\right)$$

$$\Delta I_{L} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot t_{on} \qquad I_{max} = I_{out} + \frac{1}{2} \Delta I_{L}$$

Для прерывистого режима $\Delta I_I > 2I_{out}$:

$$L = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(V_{in_max} - V_{out}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_F}{V_{in_max} + V_F}\right) \cdot \left(\frac{1}{\Delta I_L}\right) \qquad t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L \cdot \frac{\left(V_{out} + V_F\right)}{\left(f \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot \left(V_{in} + V_F\right)\right)}}$$

$$\text{где} \quad V_{in_max}' = \frac{V_{in_max}}{\left(N_1/N_2\right) - V_F} \qquad t_{off} = t_{on} \cdot \left(\frac{V_{in} + V_F}{V_{out} + V_F}\right) \quad I_{max} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot t_{on}$$

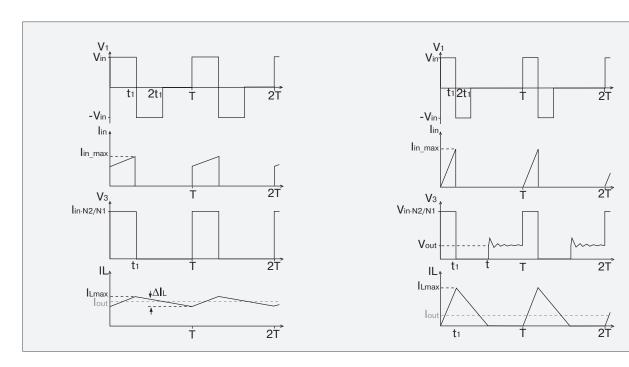


Рис. 14. Диаграммы напряжения и токов в режиме непрерывных токов.

Рис.15. Диаграммы напряжения и токов для прерывистого режима.

■ Прямоходовой двухтранзисторный (Two-Transistor Forward) преобразователь

Схема прямоходового двухтранзисторного преобразователя (рис. 16) по принципу работы аналогична однотранзисторной, иногда ее называют «косой мост». Наличие второго транзистора требует применения драйвера (дополнительного усилительного каскада) верхнего плеча. В отличие от однотранзисторной схемы «косой мост» позволяет использовать менее высоковольтные транзисторы $V_{\rm ds} = V_{\rm in}$.

Когда оба ключа замкнуты, напряжение V_{in} поступает на первичную обмотку N1. На вторичной обмотке N2 появляется напряжение, открывается диод D2. Ток через LC фильтр поступает в нагрузку. После размыкания ключей индуктор L продолжает отдавать накопленную энергию в нагрузку. Режим работы индуктора может быть непрерывным (рис. 17) и прерывистым (рис. 18).

Когда ключи разомкнуты, первичная обмотка через диоды подключена к напряжению питания, происходит автоматическое размагничивание трансформатора; выброс энергии, связанный с наличием индуктивности рассеивания, возвращается в шину питания.

Выходное напряжение преобразователя зависит от коэффициента трансформации, входного напряжения и коэффициента заполнения цикла (50% max):

$$V_{out} = V_{in} \cdot \left(\frac{N_2}{N_1}\right) \cdot \left(\frac{t_{on}}{T}\right)$$

Коэффициент трансформации $\frac{N_1}{N_2}$ рассчитывается, исходя из минимального входного напряжения $V_{in\ min}$ и заданного выходного напряжения:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{in_min}}{V_{out} + V_F} \right) \cdot 0.95$$

$$L = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(V_{in_max} - V_{out}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_F}{V_{in_max} + V_F}\right) \cdot \left(\frac{1}{\Delta I_L}\right)$$
,где

$$V_{in_{-}\max} = \frac{V_{in_{-}\max}}{(N_1/N_2) - V_F}$$

$$\Delta I_{L} = \left(\frac{1}{L}\right) \left(V_{in} \cdot \left(\frac{N_{2}}{N_{1}}\right) - V_{out}\right) \left(\frac{V_{out}}{V_{in} \cdot \left(N_{2}/N_{1}\right)}\right) \left(\frac{1}{f}\right)$$

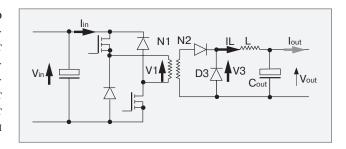


Рис. 16. Схема прямоходового двухтранзисторного преобразователя.

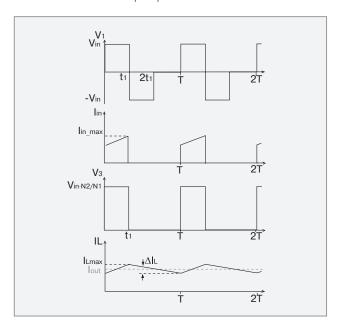


Рис. 17. Диаграммы напряжения и токов в режиме непрерывных токов.

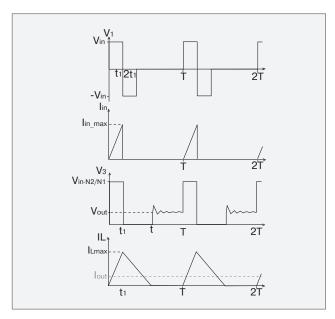


Рис. 18. Диаграммы напряжения и токов для прерывистого режима.

Для режима непрерывных токов $\Delta I_{I} < 2I_{out}$:

Для прерывистого режима $\Delta I_{\rm L} > 2I_{\rm out}$:

$$t_{on} = \left(\frac{1}{f}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + V_{F}}{V_{in} + V_{F}}\right)$$

$$t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L \cdot \frac{\left(V_{out} + V_{F}\right)}{\left(f \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot \left(V_{in} + V_{F}\right)\right)}}$$

$$\Delta I_{L} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot t_{on}$$

$$I_{max} = I_{out} + \frac{1}{2}\Delta I_{L}$$

$$t_{off} = t_{on} \cdot \left(\frac{V_{in} + V_{F}}{V_{out} + V_{F}}\right)$$

$$I_{max} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot t_{on}$$

■ Полумостовой (Half-Bridge) преобразователь

Полумостовой (Half-Bridge) преобразователь (рис. 19) относится к двухтактным схемам. Энергия передаётся в нагрузку в течение двух полупериодов цикла. Схема позволяет получать большие выходные мощности. Когда замкнут верхний ключ Т1, на первичную обмотку N1 подаётся положительное напряжение, равное $V_{in}/2$ (напряжение на конденсаторах делится ровно пополам). На вторичной обмотке появляется положительное напряжение, кратное коэффициенту трансформации, напряжение через диагональ диодного моста поступает на LC- фильтр в нагрузку. Далее выдерживается пауза («мёртвое время») до полного закрытия верхнего транзистора и открывается нижний транзистор. На первичную обмотку поступает отрицательное напряжение, на вторичной обмотке появляется напряжение также отрицательной полярности и через вторую диагональ поступает через LC-фильтр в нагрузку.

Когда ни один из ключей не замкнут («мёртвое время»), индуктор отдаёт в нагрузку накопленную

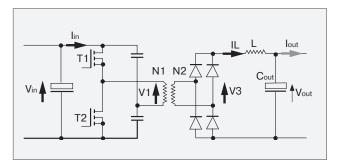


Рис. 19. Схема полумостового (Half-Bridge) преобразователя.

энергию. Если ток в индукторе не падает до нуля, то такой режим работы называется непрерывным (рис. 20), если ток падает до нуля, то это прерывистый режим (рис. 21). Прерывистый режим характеризуется большими токами, что приводит к повышенным потерям мощности в ключах и выходных диодах.

При расчёте схемы необходимо знать следующие параметры: $V_{in_min}, V_{in_max}, V_{out}, I_{out}$ и f .

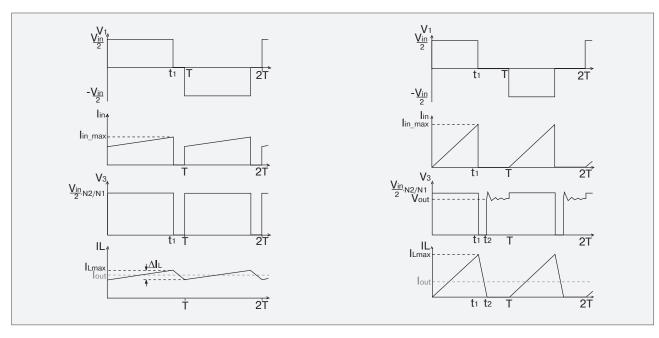


Рис. 20. Диаграммы напряжения и токов в режиме непрерывных токов.

Рис. 21. Диаграммы напряжения и токов для прерывистого режима.

Коэффициент трансформации равен:

$$\frac{N_{1}}{N_{2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{in_min}}{V_{out} + 2V_{F}} \right) \cdot 0,95$$

$$t_{on} = \left(\frac{1}{2f} \right) \cdot \left(\frac{V_{out} + 2V_{F}}{V_{in} + 2V_{F}} \right)$$

$$L = \left(\frac{1}{2f} \right) \cdot \left(V_{in_max} - V_{out} \right) \cdot \left(\frac{V_{out} + 2V_{F}}{V_{in_max} + 2V_{F}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\Delta I_{L}} \right), \quad \Delta I_{L} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out} \right) \cdot t_{on} \quad I_{max} = I_{out} + \frac{1}{2} \Delta I_{L}$$

$$\text{При прерывистого режима } \Delta I_{L} > 2I_{out} :$$

$$\Delta I_{L} = \left(\frac{1}{2f} \right) \cdot \left(V_{in} - V_{out} \right) \cdot \left(\frac{V_{out} + 2V_{F}}{V_{in} + 2V_{F}} \right) \cdot \left(\frac{1}{L} \right), \quad t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L \cdot \frac{\left(V_{out} + 2V_{F} \right)}{\left(2f \cdot \left(V_{in} - V_{out} \right) \cdot \left(V_{in} + 2V_{F} \right) \right)}}$$

$$\text{ГДЕ } V_{in} = \frac{V_{in}}{2\left(N_{1}/N_{2} \right) - 2V_{F}} \quad t_{off} = t_{on} \cdot \left(\frac{V_{in} + 2V_{F}}{V_{out} + 2V_{F}} \right) I_{max} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out} \right) \cdot t_{on}$$

Для режима непрерывных токов $\Delta I_{\rm L} < 2I_{\rm out}$:

$$t_{on} = \left(\frac{1}{2f}\right) \cdot \left(\frac{V_{out} + 2V_{F}}{V_{in} + 2V_{F}}\right)$$

$$\Delta I_{L} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot t_{on} \quad I_{max} = I_{out} + \frac{1}{2}\Delta I_{D}$$

Для прерывистого режима $\Delta I_{\rm L} > 2I_{\rm out}$:

$$t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L \cdot \frac{\left(V_{out} + 2V_F\right)}{\left(2f \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot \left(V_{in} + 2V_F\right)\right)}}$$

где
$$V_{in} = \frac{V_{in}}{2(N_1/N_2)-2V_F}$$
 $t_{off} = t_{on} \cdot \left(\frac{V_{in}^{'}+2V_F}{V_{out}+2V_F}\right) I_{max} = \frac{1}{L} \cdot (V_{in}^{'}-V_{out}) \cdot t_{on}$

Moстовой (Full-Bridge) преобразователь

Мостовой преобразователь (рис. 22) также представляет собой двухтактную схему. В отличие от полумостовой схемы здесь используются четыре транзистора. Мостовой преобразователь применяется в мощных схемах от единиц до десятков киловатт, что позволяет снизить токи в первичной цепи в два раза по сравнению с полумостовой схемой.

Когда замкрунта пара ключей Т1 и Т4, к первичной обмотке N1 прикладывается напряжение питания V_{in} . На вторичной обмотке N2 появляется напряжение, которое через LC фильтр поступает на нагрузку. Затем пара ключей Т1 и Т4 размыкается, после паузы замыкаются ключи Т2 и Т3, на первичную обмотку подаётся напряжение питания V_{in} отрицательной полярности.

Как и полумостовая, мостовая схема может работать в непрерывном режиме (рис. 23) или в прерывистом (рис. 24).

Для её расчёта необходимо знать исходные данные: $V_{in\ min}$, $V_{in\ max}$, V_{out} , I_{out} и f.

Коэффициент трансформации равен:

$$\begin{split} \frac{N_1}{N_2} = & \left(\frac{V_{in_\min}}{V_{out} + 2 V_F} \right) \cdot 0,95 \\ L = & \left(\frac{1}{2f} \right) \cdot \left(V_{in_\max}' - V_{out} \right) \cdot \left(\frac{V_{out} + 2 V_F}{V_{in_\max}' + 2 V_F} \right) \cdot \left(\frac{1}{\Delta I_L} \right), \end{split}$$
 где $V_{in_\max}' = \frac{V_{in_\max}}{\left(N_1 / N_2 \right) - 2 V_F}$

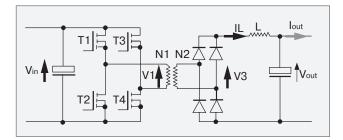


Рис. 22. Схема мостового (Full-Bridge) преобразователя.

$$\Delta I_{L} = \left(\frac{1}{2f}\right) \cdot \left(\overrightarrow{V_{in}} - \overrightarrow{V_{out}}\right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{V_{out}} + 2\overrightarrow{V_{F}}}{\overrightarrow{V_{in}} + 2\overrightarrow{V_{F}}}\right) \cdot \left(\frac{1}{L}\right),$$

$$\overrightarrow{V_{in}} = \frac{\overrightarrow{V_{in}}}{\left(N_{1}/N_{2}\right) - 2\overrightarrow{V_{F}}}$$

Для непрерывного режима $\Delta I_{\perp} < 2I_{\text{out}}$:

$$V'_{in} = \frac{V_{in}}{(N_1/N_2) - 2V_F}$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{L} \cdot (V'_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}$$

$$I_{max} = I_{out} + \frac{1}{2} \Delta I_L$$

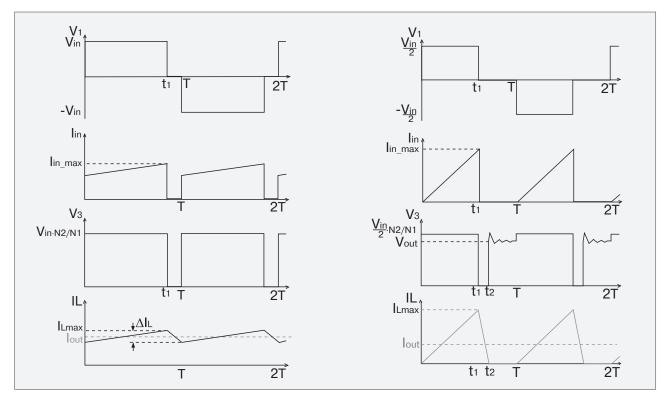


Рис. 23. Диаграммы напряжения и токов в режиме непрерывных токов.

Для прерывистого режима $\Delta I_{\rm L} > 2I_{\rm out}$:

$$t_{on} = \sqrt{2I_{out} \cdot L \cdot \frac{\left(V_{out} + 2V_{F}\right)}{\left(2f \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot \left(V_{in} + 2V_{F}\right)\right)}}$$

$$t_{off} = t_{on} \cdot \left(\frac{V_{in} + 2V_{F}}{V_{out} + 2V_{F}}\right)$$

$$I_{max} = \frac{1}{L} \cdot \left(V_{in} - V_{out}\right) \cdot t_{on}$$

■ Корректоры коэффициента мощности (PFC)

Форма тока, потребляемого от сети выпрямителем с фильтрующим конденсатором (рис. 25), отличается от синусоидальной. Это связано с тем, что ток выпрямителя течет только в случае, когда напряжение в сети больше напряжения на конденсаторе. На практике зона проводимости выпрямителя ограничена примерно 15° в области пика напряжения. Следствием этого являются большие импульсы потребляемого тока (рис. 26) с амплитудой, в несколько раз превышающей номинальное значение тока.

Наличие пиков потребляемого от сети тока означает генерацию нечётных гармоник (рис. 27), появляется реактивная составляющая мощности.

Рис. 24. Диаграммы напряжения и токов для прерывистого режима.

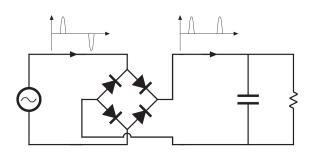


Рис. 25. Классический однофазный выпрямитель с фильтрующим конденсатором.

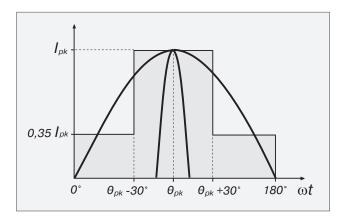


Рис. 26. Форма напряжения и тока в сети при использовании классического выпрямителя.

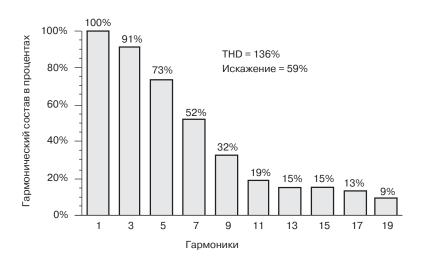


Рис. 27. Гармонический состав тока, потребляемого от сети классическим выпрямителем с фильтрующим конденсатором.

Это приводит к дополнительному нагреву и потерям в линиях электропередач. Также происходит искажение формы напряжения в питающей сети (обрезаются «верхушки»), что может привести к «перекосу» фаз (в трёхфазной сети при неравномерной нагрузке) и появлению напряжения на нейтрали.

Допустимый уровень эмиссии гармонических составляющих тока источником питания регламентируется ГОСТом Р 51317.3.2-2006 (до 16 А в фазе и до 600 Вт). Гармонический состав потребляемого тока может не удовлетворять требованиям данного ГОСТа. В этом случае применяется пассивный корректор (дроссель на входе выпрямителя), либо

активный ВЧ-корректор. Пассивный корректор (дроссель) имеет большие габариты и уместен в устройствах небольшой мощности, где критична цена устройства и не важны габариты. Также существуют другие пассивные схемы, но они работают в узком диапазоне напряжения.

Схемотехника ВЧ-корректора может быть различной — Виск, Вооst, Виск-Вооst. Наиболее распространённая — Вооst — позволяет получить максимально близкое к единице значение созф, повысить напряжение питания источника и тем самым снизить потребляемые токи (снижается нагрев в первичной обмотке, уменьшаются статические потери в ключах на первичной сто-

роне). На рис. 28 представлена классическая схема корректора коэффициента мощности (ККМ).

ККМ разделяются по режиму работы индуктора на ККМ с прерывистым (discontinuous) режимом работы (рис. 29) и на ККМ с непрерывным (continuous) режимом работы (рис. 30). Прерывистый режим работы в основном используется в схемах мощностью до 300 Вт из-за наличия больших токов, протекающих через ключ, и хорош тем, что отсутствуют потери на обратное восстановление бустерного диода. Непрерывный режим используется в схемах мощностью до единиц киловатт, но следует применять диод с малым временем восстановления, например: FEXFRED,

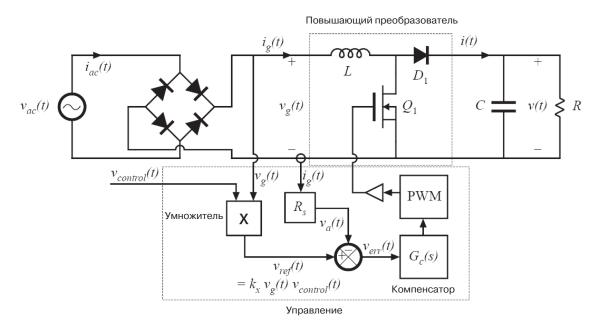


Рис. 28. Схема корректора коэффициента мощности.

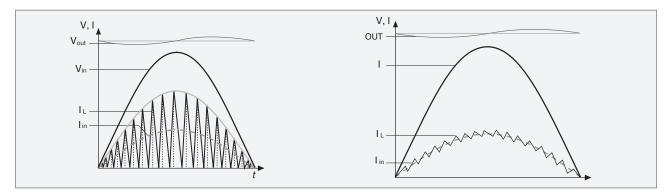


Рис. 29. Прерывистый режим индуктора.

Рис. 30. Непрерывный режим индуктора.

HIPERFAST или диоды на основе карбида кремния. При выборе транзистора необходимо просчитать статические и динамические потери мощности в них и выбрать наиболее подходящие. В лучшей степени подходят транзисторы Infineon CoolMos, которые характеризуются очень малым временем переключения.

В настоящий момент распространены следующие типы управляющих контроллеров ККМ:

- CCM (continuous conduction mode): ICE2PCS01(2) Infineon, IR1150 International Rectifier, HA16174 и R2A20111 Renesas. Эти приборы, как правило, имеют свой встроенный драйвер и обеспечивают ток до $\pm 1,5$ A.
- DCM (discontinuous conduction mode): TDA4863 Infineon, R2A20112 Renesas.

Корректор коэффициента мощности должен выполнять следующие функции:

- Придание потребляемому от сети току синусоидальной формы.
 - Ограничение выходной мощности.
 - Защита от короткого замыкания.
- Зашита от пониженного и повышенного напряжения.

На рис. 31 представлена классическая схема ККМ ССМ на основе микросхемы ICE2PCS01 Infineon.

ICE2PCS01 отличается от ICE2PCS02 возможностью регулировки частоты преобразования (50-250 кГц), в то время как ICE2PCS02 работает на фиксированной частоте $65\ \mathrm{k\Gamma}\mathrm{L}$.

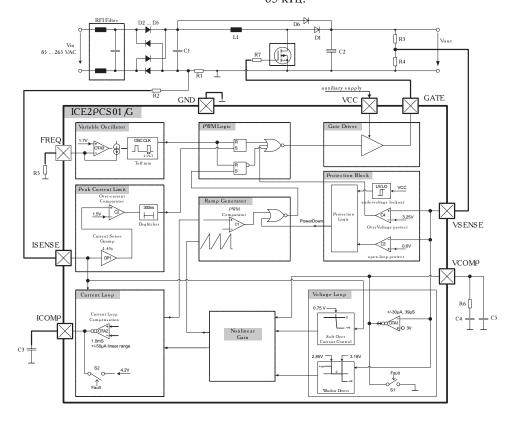


Рис. 31. Схема корректора коэффициента мощности ССМ на ICE2PCS01.

Сравнение схемных решений

При выборе схемы импульсного преобразователя необходимо знать входные и выходные напряжения, учитывать, должна ли быть вторичная сторона источника гальванически развязана от первичной, а также учитывать требуемую удельную мощность (Вт/дм³). Маломощные неизолирующие повышающие и понижающие преобразователи нашли широкое применение в питании низковольтных схем 1.1...5 В (процессоров, работа от аккумуляторов). Очень широкий ассортимент всевозможных контроллеров выпускает NSC (см. в приложении). Также в приложении приведены параметры дросселей стандартных номиналов Wurth Elektronik. В качестве низковольтных ключей можно использовать транзисторы Optimos Infineon или IRF (см. приложение).

Обратноходовые источники питания, благодаря своей простоте, нашли широкое применение в АС/DC, DC/DC-источниках. Однако. они имеют не очень высокие показатели удельной мощности. Infineon выпускает контроллеры для управления АС/DC-источником, а также серию Coolset со встроенным ключом. CoolSet позволяет строить простые обратноходовые источники с минимальной «обвеской» мощностью до 240 Вт.

Прямоходовые схемы имеют энергетические показатели на порядок более высокие, чем обратноходовой схемы. Однотранзисторная схема часто применяется в DC/DC-модулях, но не нашла широкого применения в сетевых AC/DC-источниках из-за свойственных ей высоких перенапряжений на ключе. В сетевых AC/DC-источниках повсеместно применяется двухтранзисторная схема.

Полумостовые и мостовые схемы применяются там, где требуется большая выходная мощность. В качестве ключей удачно подойдут транзисторы CoolMos Infineon и IGBT IRF Warp2.

РАЗНОВИДНОСТИ ПРЯМОХОДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

В настоящее время существует много разновидностей прямоходовых схем, причём каждая имеет свои преимущества и недостатки.

Классическая схема

Классическая схема прямоходового преобразователя уже рассматривалась в главе «Прямоходовой (Forward) преобразователь» (см. стр. 7, рис. 13).

Если транзисторный ключ V1 замкнут, входное напряжение прикладывается к первичной обмотке трансформатора. На вторичной обмотке трансформатора появляется напряжение, открывается диод D2. Низкочастотный LC-фильтр сглаживает пульсации выходного напряжения и отдаёт энергию в нагрузку через диод D3, когда транзистор VT закрыт (ключ разомкнут).

В то время, когда транзистор V1 закрыт, трансформатор размагничивается через дополнительную

обмотку и диод D1. При одинаковом количестве витков коэффициент заполнения d<0.5. Коэффициент передачи равен $n\cdot d$, где d — коэффициент заполнения, $n=N_1/N_2$ — коэффициент трансформации.

Типовое значение перенапряжения на транзисторе равно 2.6 $V_{\text{in_max}}$. При таком уровне перенапряжения существенно возрастает стоимость силовых транзисторов с низким сопротивлением R_{dson} , особенно для сетевых (220 B) источников питания.

Недостатком данной схемы является наличие дополнительной обмотки, которая усложняет трансформатор и увеличивает его стоимость.

■ Прямоходовой преобразователь с RCD-демпфирующей цепочкой

Появление данной модификации прямоходовой схемы — это одна из первых попыток упростить и улучшить процесс размагничивания трансформатора. Прямоходовой преобразователь с RCD-демпфирующей цепочкой (рис. 32) используется, в основном, если необходимо построить недорогой источник питания.

Коэффициент передачи, как и в классической прямоходовой схеме, равен произведению $n \cdot d$.

Когда транзистор VT разомкнут, диод VD и конденсатор C ограничивают напряжение на нем до уровня, определяемого входным напряжением и коэффициентом заполнения. Резистор R предназначен для разряда конденсатора. Типовое значение перенапряжения на транзисторе составляет $2.0\,\mathrm{V}_{\mathrm{in}}$ мах.

Основной недостаток схемы — дополни-

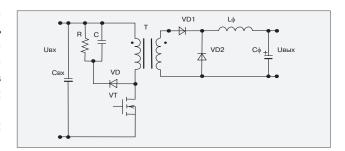


Рис. 32. Схема прямоходового преобразователя с RCD-демпфирующей цепочкой.

тельные потери мощности, которая рассеивается в резисторе R, что приводит к снижению $K\Pi Д$ и увеличению массогабаритных показателей источника питания.

■ Прямоходовой преобразователь с LCDD-демпфирующей цепочкой

В данном случае предпринята попытка размагничивания трансформатора с помощью демпфирующей цепочки без дополнительных потерь мощности (рис. 33).

Коэффициент передачи, как и в предыдущих схемах, определяется как $n \cdot d$.

Когда транзистор VT разомкнут, диод и конденсатор ограничивают напряжение на стоке транзистора, аналогично варианту схемы с RCD-демпфирующей цепочкой. Резонансный контур, состоящий из Lr, Cr, и VDcl, обеспечивает разряд конденсатора. Типовое значение перенапряжения на транзисторе равно $2.0\,\mathrm{V}_{\mathrm{in}\ \mathrm{max}}$.

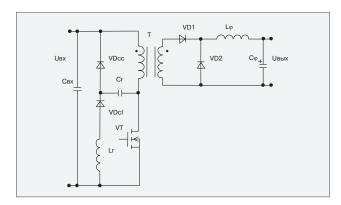


Рис. 33. Схема прямоходового преобразователя с LCDD-демпфирующей цепочкой.

РАЗНОВИДНОСТИ ПРЯМОХОДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Но, ввиду сложности и неоднозначности резонансных процессов для различных режимов работы схемы, для того, чтобы обеспечить правильную работу схемы во всем диапазоне изменения нагрузки и входного напряжения, необходима не одна итерация при выборе параметров контура. В случае не оптимальных

параметров резонансного контура потери мощности могут даже превосходить потери мощности в резисторе R, присущие схеме, изображенной на рис. 32.

Еще одним недостатком схемы являются существенные габаритные размеры дросселя L, особенно для высоких входных напряжений.

■ Прямоходовой преобразователь с резонансной схемой размагничивания трансформатора

Для размагничивания трансформатора используется паразитная емкость транзистора (иногда необходима дополнительная внешняя емкость). Это очень простая и удобная в применении схема, не требующая большого числа дополнительных компонентов (рис. 34).

Коэффициент передачи, как и в классической прямоходовой схеме, равен $n \cdot d$.

При выключении транзистора возникают колебания в резонансном контуре, образованном индуктивностью намагничивания трансформатора и паразитной емкостью транзистора, благодаря чему перемагничивание трансформатора происходит автоматически. Типовое значение перенапряжения на транзисторе равно $2.0\ V_{\rm in\ max}$.

Недостатком любой резонансной схемы является сложность обеспечения оптимальных условий

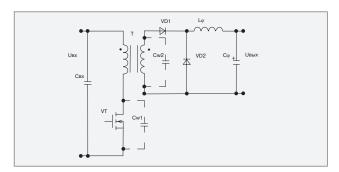


Рис. 34. Схема прямоходового преобразователя с резонансной схемой размагничивания трансформатора.

перемагничивания во всем диапазоне изменения нагрузки и входного напряжения.

Прямоходовой преобразователь с двумя ключами

Схема прямоходового преобразователя с двумя ключами была рассмотрена выше в разделе «Прямоходовой двухтранзисторный (Two-Transistor Forward) преобразователь» (см. рис. 16). Процесс передачи энергии аналогичен классической схеме, коэффициент передачи равен n·d. В момент выключения транзисторов первичная обмотка через диоды подключается ко входному источнику на-

пряжения в обратной полярности, перемагничивание трансформатора происходит автоматически. Поэтому максимальное значение перенапряжения на транзисторе — $1.0~{\rm V}_{\rm in~max}$.

Недостатком схемы является применение дополнительного полевого транзистора и необходимость использования «отвязанного от земли» драйвера для управления транзистором V2.

Прямоходовой преобразователь с активной ограничивающей цепью

В данной схеме (рис. 35) для перемагничивания трансформатора используется дополнительный транзистор и конденсатор Cr; коэффициент передачи равен $n \cdot d$.

При выключении силового транзистора с некоторой временной задержкой открывается вспомогательный транзистор и перезаряжает ёмкость Cr, типовое значение перенапряжения на транзисторе составляет $1.3\ V_{\rm in\ max}$.

Временная задержка необходима для перезаряда выходных ёмкостей транзисторов энергией, накопленной в индуктивности рассеяния трансфор-

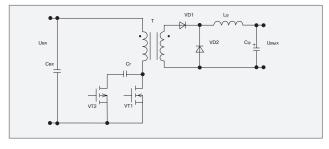


Рис. 35. Схема прямоходового преобразователя с активной ограничивающей цепью.

РАЗНОВИДНОСТИ ПРЯМОХОДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

матора. Важным преимуществом этой схемы является то, что переключение транзисторов происходит при нулевом напряжении на них (ZVS).

К недостаткам схемы можно отнести наличие дополнительного транзистора и схемы управления,

обеспечивающей временную задержку при переключении транзисторов, а также увеличение потерь проводимости ввиду использования небольшой индуктивности намагничивания.

■ Прямо-обратноходовой (Forward/Flyback) преобразователь

Отличие схемы, представленной на рис. 36, от прямоходового преобразователя с активной ограничивающей цепью (рис. 35) состоит в том, что в сердечник трансформатора вводится дополнительный зазор.

При открытом транзисторе VT1 передача энергии от источника в нагрузку осуществляется через диод VD1. При выключении транзистора VT1 энергия, накопленная в сердечнике за счёт наличия дополнительного зазора, передается в нагрузку через диод VD2.

Выгодным отличием этой схемы от рассмотренных выше является коэффициент передачи, равный 2nd, чем обеспечивается сравнительно высокий КПД преобразователя. Типовое значение перенапряжения на транзисторе, как и для прямоходового преобразователя с активной ограничивающей цепью, составляет $1.3 \ V_{\rm in\ max}$.

Uex Cr VD2 Usbax

Рис. 36. Схема прямо-обратноходового преобразователя.

К недостаткам данного решения следует отнести необходимость использования дополнительного транзистора и сложность схемы управления, а также существенные перенапряжения на выходных диодах, обусловленные процессами их обратного восстановления.

Двойной прямоходовой преобразователь

Двойной прямоходовой преобразователь представляет собой модернизацию предыдущей схемы (рис.37).

Проблемы, обусловленные обратным восстановлением диодов, решаются путем введения насыщающихся дросселей SR1 и SR2 и диода VD3.

Диод VD3 препятствует короткому замыканию трансформатора при изменении напряжения стокисток транзистора, поэтому для обеспечения «мягкого переключения» может быть использована полная энергия намагничивания, следовательно, требуемый ток намагничивания может быть уменьшен. Это позволяет расширить диапазон нагрузок, для которого выполняются условия «мягкого переключения».

Коэффициент передачи схемы равен 2nd, перенапряжение на транзисторе составляет 1.3 $V_{\rm in\ max}$.

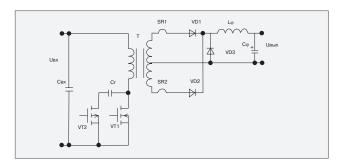


Рис. 37. Схема двойного прямоходового преобразователя.

Недостатком схемы является большое количество дополнительных элементов: транзистор и схема управления, диод VD3, два насыщающихся дросселя.

Сравнение различных схем прямоходовых преобразователей

Основные параметры схем преобразователей сведены в таблицу:

	кпд	Напряжение на ключе	Уровень помех	Дополнительные компоненты
Прямоходовой преобразователь с обмоткой размагничивания	Низкий	2.6 V _{in_max}	Высокий	Дополнительная обмотка трансформатора
Прямоходовой преобразователь с RCD-демпфирующей цепочкой	Низкий	2.0 V _{in_max}	Высокий	R, C, VD
Прямоходовой преобразователь с LCDD-демпфирующей цепочкой	Низкий	2.0 V _{in_max}	Высокий	UC, VD, VD
Прямоходовой преобразователь с резонансной схемой размагничивания трансформатора	Средний	2.0 V _{in_max}	Средний	С

Рассмотрим подробнее представленные в таблице характеристики.

Эффективность. Для источников питания, в которых основными параметрами являются высокая удельная мощность и КПД, оптимальными будут «прямо-обратноходовая» схема или схема двойного прямоходового преобразователя. В случае, если решающее значение имеет стоимость источника питания, целесообразно применить схемы, представленные на рис. 32 и рис. 34.

Уровень перенапряжений на транзисторах. С точки зрения минимизации уровня перенапряжения на силовых транзисторах, оптимальной является схема, изображенная на рис. 16. Такая топология удобна для сетевых источников питания. Например, при сетевом входном напряжении 220 В выпрямленное напряжение составляет 220×1.41=310 В. Это максимальное перенапряжение на транзисторе. С учетом коэффициента загрузки 0.7 выбирается транзистор с максимальным рабочим напряжением 500 В. Если используется классическая схема прямоходового преобразователя, то даже при коэффициенте загрузки 0.8 необходим транзистор с максимальным рабочим напряжением 1000 В.

Шумы, электромагнитная совместимость. Среди восьми рассмотренных выше типов преобразователей наименьшим уровнем помех обладает двойной прямоходовой преобразователь (см. рис. 37). В данном случае, помимо переключения транзисторов при нулевом напряжении, решена также проблема обратного восстановления диодов.

«Прямо-обратноходовой» преобразователь и прямоходовой преобразователь с активной огра-

ничивающей цепью занимают следующее место в списке предпочтений, т. к. в основе работы данных схем также заложен принцип «мягкого переключения» транзисторов.

Остальные преобразователи имеют примерно одинаковый уровень помех на выходе и уступают схемам с «мягким переключением».

Возможность применения синхронного выпрямителя. В схемах с синхронным выпрямлением ток в полевых транзисторах протекает в обратном направлении (от истока к стоку). При этом полевые транзисторы работают в третьем квадранте вольтамперной характеристики. Но в указанном направлении проводит и антипараллельный диод транзистора. Поэтому основная сложность при использовании синхронного выпрямителя заключается в построении правильной схемы управления синхронными транзисторами так, чтобы исключить возможность проводимости антипараллельного диода.

В связи с этим, наиболее просто применять синхронный выпрямитель в схемах, представленных на рис. 36 и рис. 37. Затворами транзисторов можно управлять непосредственно со вторичной обмотки трансформатора, т. к. интервалы времени, когда напряжение на обмотке равно нулю, чрезвынайно малы

В остальных схемах использование синхронного выпрямителя требует значительного количества дополнительных элементов, т. к. необходимо реализовать управление синхронными транзисторами при нулевом напряжении на вторичной обмотке трансформатора. Прежде всего, это касается схем, представленных на рис. 13, рис. 32 и рис. 33.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КВАЗИРЕЗОНАНСНЫХ И РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Описание принципов работы мостового (Phase-Shift) преобразователя на примере контроллера Renesas HA16163

Мостовые Phase-Shift-конверторы относятся к особому классу преобразователей с фазовым управлением. Особенность заключается в том, что переключение всех четырёх ключей происходит при нуле напряжения. Это позволяет практически исключить динамические потери в транзисторах и существенно снизить уровень излучаемых помех, что очень важно для питания телекоммуникационного оборудования. Такие схемы позволяют получать мощности в несколько десятков киловатт.

Рассмотрим схему квазирезонансного преобразователя с синхронным выпрямлением на примере контроллера HA16163 Renesas. На рис 44. приведена временная диаграмма, поясняющая работу преобразователя.

Момент времени 1 (рис. 38). В момент t0 транзисторы S3 и S6 открыты, напряжение питания Vin подключено через дроссель Lr к первичной обмотке трансформатора, на вторичной обмотке появляется напряжение, пропорциональное напряжению в первичной обмотке. Ключи синхронного выпрямителя S14S15 разомкнуты, S16S17 — замкнуты. Напряжение с первичной обмотки через дроссель L1 поступает на нагрузку.

Момент времени 2 (рис. 39). В момент t1 транзистор S3 включён. При выключении транзистора S6, на резонансном дросселе Lr происходит выброс напряжения самоиндукции. Ключи S14S15 и S16S17 выходного выпрямителя замкнуты, тем самым шунтируя выходную обмотку, энергия, запасённая в резонансном дросселе Lr, переходит в выходную ёмкость транзистора S6 - C_{12} , C_{12} заряжается со скоростью

$$\frac{dV12}{dt} = \frac{I_{\text{\tiny Harp}}}{2N * C12} ,$$

где $N=N_1/N_2$ — коэффициент трансформации, $I_{\text{нагр}}$ — ток нагрузки, C_{12} — выходная ёмкость транзистора. $C12=\frac{1}{V}\int\limits_0^V Coss(V)\,dv$

$$C12 = \frac{1}{V} \int_{0}^{V} Coss(V) dv$$

Момент времени 3 (рис. 40). В момент t2 происходит включение транзистора S4. К этому времени выходная ёмкость транзистора S6-C₁₂ заряжается до напряжения питания Vin (чтобы переключение происходило при нулевом напряжении с минимальными потерями).

Задержка включения транзистора S4:

$$t = \frac{C12 * N * Vin}{0.5 I_{\text{Happ}}}$$

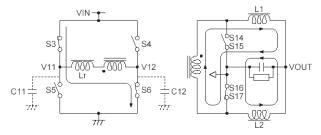


Рис. 38.

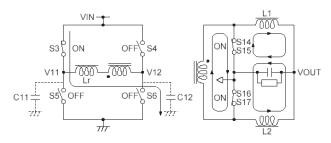


Рис. 39.

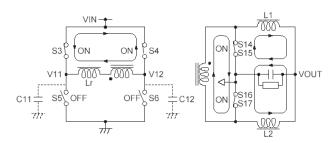


Рис. 40.

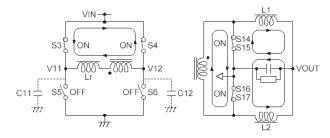


Рис. 41.

Момент времени 4 (рис. 41). В момент времени t3 транзистор S3 выключается, начинается разряд выходной ёмкости транзистора S5- C_{11} . Происходит переход энергии из конденсатора $\mathbf{C}_{_{11}}$ в резонансный дроссель Lr. В контуре генерируются свободные гармонические колебания. Собственная резонансная частота контура:

$$fr = \frac{1}{2\pi\sqrt{LrC11}}$$

Момент времени 5 (рис. 42). В момент времени t4 выключается транзистор синхронного выпрямителя, ток, протекающий через ключ, продолжает протекать через паразитный диод транзистора, тем самым закорачивая выходную обмотку и удержи-

вая энергию внутри контура. Через момент времени $t_{\rm зад} = \frac{1}{4} * \frac{1}{fr}$ напряжение на ёмкости $C_{\rm 11}$ будет равно 0.

Момент времени 6 (рис. 43). В момент времени t5 при достижении нулевого напряжения на ёмкости C_{11} включается транзистор S5. Ток в выходной обмотке меняет своё направление, напряжение вторичной обмотки подключается к нагрузке через дроссель L2.

Отметим важные моменты, которые необходимо учесть при проектировании квазирезонансного преобразователя:

 $V_{res} = \frac{I_{\text{нагр}}}{2N} \sqrt{\frac{L_r}{C11}} \ \text{должно быть больше или равно}$ напряжению питания $V_{res} \geq V_{in}$. Необходимо

выбирать транзисторы с наименьшим значением выходной ёмкости, а индуктивность выбирать на-ибольшую. Это позволит уменьшить минимальную

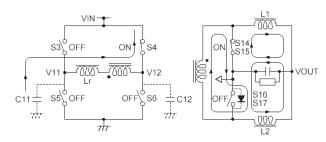


Рис. 42.

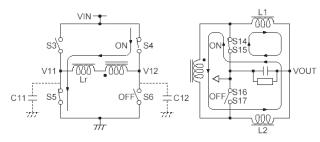


Рис. 43.

мощность нагрузки, при которой схема работает в режиме «мягкого» переключения. Граничное условие, при котором схема всё ещё работает в режиме «мягкого» переключения:

$$V_{in} = \frac{I_{\text{\tiny Harp}}}{2N} \sqrt{\frac{L_r}{C11}}.$$

2. В качестве резонансного дросселя можно использовать индуктивность рассеяния трансформатора или применить внешний дроссель. Дроссель может стоять как в первичной обмотке, так и во вторичной.

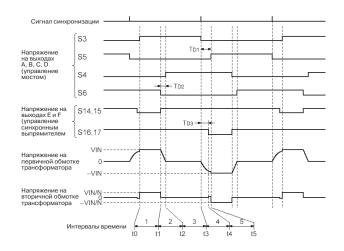


Рис. 44. Временная диаграмма, поясняющая работу мостового Phase-Shift преобразователя.

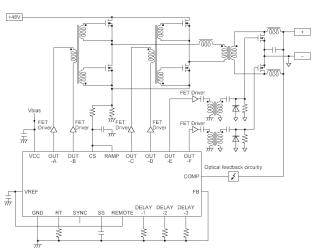


Рис. 45. Схема мостового Phase-Shift преобразователя на HA16163 Renesas.

Описание принципов работы квазирезонансных обратноходовых (Flyback) преобразователей

В момент, когда ток во вторичной обмотке падает до нуля, в первичной обмотке возникают своболные колебания, обусловленные паразитными характеристиками трансформатора — индуктивностью рассеяния и паразитной ёмкостью. В случае, если включение транзистора произойдёт в момент, когда напряжение на стоке минимально, динамические потери будут существенно ниже. Чем ниже будет напряжение, при котором будет

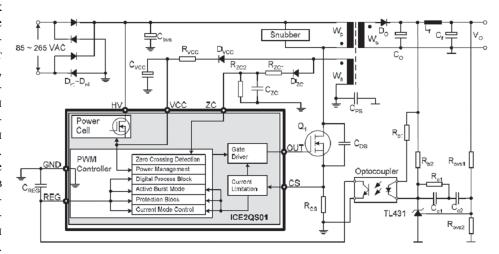


Рис. 46. Схема включения микросхемы ICE2QS01.

происходить переключение, тем меньше будут динамические потери. Теоретически минимальное напряжение колебаний может снижаться до нуля, но в этом случае максимальное напряжение на стоке будет как минимум в два раза больше номинального входного напряжения. Этот факт, как правило, ограничивает разработчика, так как потребуются более высоковольтные (800...900 В) ключи, которые существенно дороже, имеют высокое сопротивление Rdson и высокое значение Qtg. Ещё одно преимущество данного типа обратноходовых преобразователей — меньший уровень помех, благодаря этому источники данного типа нашли широкое применение в телевизионной технике.

В настоящий момент компания Infineon производит линейку контроллеров для управления квазирезонансными обратноходовыми источниками питания — TDA4605, TDA16846, ICE2QS01. На рис. 46 представлена типичная схема источника питания на основе микросхемы ICE2QS01. Функционально схема не отличается от классического обратноходового преобразователя ничем, кроме наличия вывода ZC (контроль перехода через «0»).

При проектировании трансформатора необходимо задаться минимальной рабочей частотой при требуемой выходной мощности. А уже исходя из этой минимальной рабочей частоты, рассчитывать импульсный трансформатор.

При снижении выходной мощности контроллер переходит в режим низкого энергопотребления и выдаёт пачки импульсов. Ранние версии данных ИС могли отслеживать только момент первого перехода через «0», более современные способны включаться в любой N-й момент перехода через «0» (диаграммы переключения приведены на рис. 47).

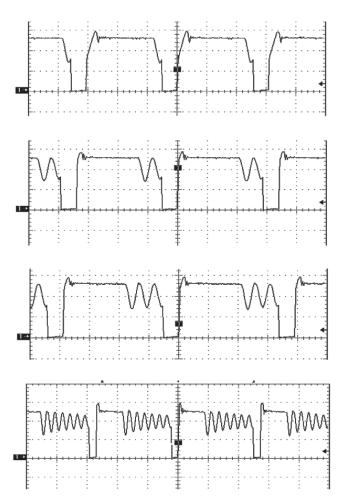


Рис. 47. Диаграммы переключения силового транзистора.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Проектирование обратноходового трансформатора

Обратноходовой трансформатор имеет свойство, характерное только для этого типа трансформаторов, — способность за время прямого хода запасать энергию, на обратном ходу отдавая энергию в нагрузку. По сути, его можно назвать дросселем.

При проектировании обратноходового трансформатора необходимо задать максимальный пиковый ток в первичной обмотке \mathbf{I}_{pk} , который влияет на потери в ключе. Кроме того, пропорционально току в первичной обмотке возрастает ток во вторичной обмотке, и это приводит к увеличению потерь в выпрямителе.

Пиковый ток равен
$$I_{pk} = \frac{V_{in} \cdot T_{on}}{L_1}$$
, где

 $L_{_{1}}$ — индуктивность первичной обмотки,

$$T_{on} = \frac{\widehat{O}_{\max}}{f}$$
 — время, в течение которого ключ находится в проводящем состоянии, $V_{\rm in}$ — входное напряжение.

Индуктивность первичной обмотки:

$$L_1 = \frac{V_{in} \cdot \partial_{\max}}{I_{pik} \cdot f}$$

Энергия, запасённая в трансформаторе:

$$E_{stored} = \frac{L_1 \cdot I_{pik}^2}{2}$$

Необходимо проверить, удовлетворяется ли $_{\text{условие}} E_{\textit{stored}} \cdot f > P_{\textit{out}}$.

Требуемая величина воздушного зазора

$$I_{gap} = rac{0.4\pi L_1 I_{pik}^2}{A_C B_{
m max}^2}$$
 , где

 ${f A}_{\!\scriptscriptstyle C}$ — площадь поперечного сечения сердечника (м²), ${f B}_{\!\scriptscriptstyle {
m max}}$ — максимальная индукция.

Количество витков в первичной обмотке:

$$N_{pri} = \frac{B_{\text{max}} L_{gap}}{0.4 \pi I_{pic}}$$

Производитель ферритов обычно указывает в документации параметр A_L — индуктивность на один виток, н Γ /вит (для данного феррита с заданным зазором); зная этот параметр, можно вычислить количество витков:

$$N_{pri} = \sqrt{\frac{L_{pri}}{A_L}}$$

Количество витков во вторичной обмотке:

$$N_{\rm sec} = \frac{N_{pri} \left(U_{\rm bblx} + U_{fwd} \right)}{U_{\rm min_bx}} \cdot \frac{1 - \partial_{\rm max}}{\partial_{\rm max}},$$

где ${\rm U_{fwd}}$ — прямое падение на диоде, ${\rm \,U_{min_BX}}$ — минимальное входное напряжение.

Проектирование прямоходового трансформатора

В отличие от обратноходового, прямоходовой трансформатор не накапливает энергии. Вся энергия на прямом ходу передаётся в нагрузку.

Главный критерий, по которому рассчитывается прямоходовой трансформатор — максимальная индукция B_{max} (Тл).

Количество витков в первичной обмотке:

$$N_{pri} = \frac{V_{in_max}}{4 B_{max} \cdot f \cdot A_C}$$
, где

 A_{C} — площадь поперечного сечения сердечника (м²), B_{max} — максимальная индукция, $V_{\text{in_max}}$ — максимальное выходное напряжение.

Количество витков во вторичной обмотке:

$$N_{\rm sec} = \frac{1.1 \left(U_{\scriptscriptstyle
m Bbtx} + U_{fwd} \right)}{U_{\scriptscriptstyle
m min \ Bx} \cdot N_{\scriptscriptstyle Dri} \cdot \Delta} \; ,$$

где Δ — максимальный рабочий цикл.

■ Проектирование прямоходового дросселя

Функция выходного дросселя в прямоходовом источнике — сохранение энергии на прямом ходу и передача энергии в нагрузку в режиме, когда все ключи разомкнуты. Таким образом выходные импульсы сглаживаются, и на выходе получается постоянный ток с некоторыми пульсациями. Выходной дроссель может работать как в режиме прерывистого тока, так и в режиме непрерывного тока, последний используется чаще из-за меньшего уровня пиковых токов в ключах и диодах и меньших пульсаций на конденсаторе. Дроссель для двухтактных схем рассчитывается по аналогии с дросселем для однотактного преобразователя.

Минимальное значение индуктивности дросселя:

$$L_{\min} = \frac{\left(V_{in_\max} - V_{out}\right) \cdot T_{on}}{1,4 \ I_{out_\min}}$$
, где

 $I_{
m out_min}$ — минимальный выходной ток, $T_{
m on}$ — время, в течение которого ключи замкнуты, $V_{
m in_max}$ — максимальное напряжение на выходе выпрямителя, $V_{
m out}$ — напряжение на нагрузке. Проектируя двуполярный источник питания, выходные дроссели можно объединять и мотать бифилярно на одном сердечнике. Начальный вывод обмотки первого дросселя подключается к выпрямителю, начальный вывод обмотки второго — к выходному конденсатору.

Входной помехоподавляющий фильтр может быть выполнен по различным схемам (рис.48 — Побразный одноступенчатый, рис. 49 — Побразный двухступенчатый).

Задача входного сетевого фильтра — подавить помехи, вызванные коммутацией силовых тран-

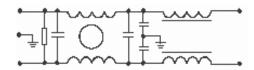


Рис. 48. Одноступенчатый П-образный фильтр.

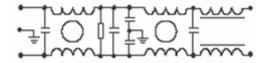


Рис. 49. Двуступенчатый П-образный фильтр.

зисторов. Помехи бывают двух типов — синфазная помеха и дифференциальная. Синфазная помеха помеха, присутствующая на двух сетевых проводах одновременно. Дифференциальная помеха — помеха, которая появляется на нейтрали. Для подавления синфазной помехи используется П-образный LC-фильтр, состоящий из плёночных конденсаторов X1-X2 Hitano, Epcos, Vishay и сдвоенного фильтра. Сдвоенные фильтры выпускает Wuert Electronik (we-online.com), Ерсоѕ и Murata. В приложении приведена более подробная информация по данным дросселям. Murata изготавливает дроссели с секционной намоткой, это позволяет снизить межвитковую ёмкость. Благодаря снижению межвитковой ёмкости достигается лучшее подавление помех на высоких частотах.

Дифференциальная помеха подавляется небольшими раздельными дросселями (на каждый сетевой провод свой) и конденсаторами Y1 (Hitano, Murata, Epcos), включенными между сетевыми выводами и нейтралью. Существуют комбинированные дроссели для подавления синфазной и дифференциальной помехи.

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБРАТНОХОДОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ HA MUKPOCXEME COOLSET INFINEON

Coolset — это высоковольтный силовой полевой транзистор, выполненный по технологии CoolMos, и схема аналогового и цифрового контроля в едином корпусе. Микросхема используется для построения гальванически развязанного, регулируемого преобразователя напряжения со всем комплексом необходимых защит (защита по току, защита от перегрева, защита от пониженного и повышенного напряжения питания). При этом требуется минимум внешних компонентов. Рабочая частота схемы 67 и 100 кГц. Схема Coolset может применяться как для DC/DC так и для AC/DC преобразователей напряжения мощностью до 120 Вт при переменном (50 Гц) входном напряжении 85...265 В или до 240 Вт при напряжении 195...265 В. Работа от более низкого входного напряжения возможна при снижении мощности источника питания. Схема обратноходового преобразователя напряжения с использованием Coolset представлена на рис. 47.

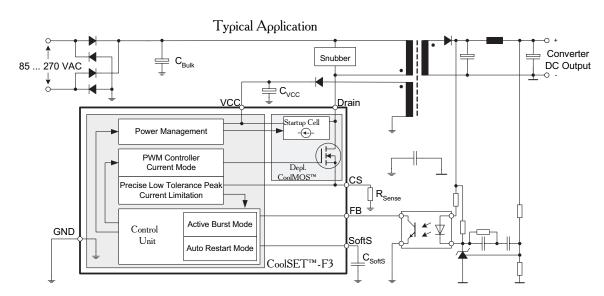


Рис. 47. Схема AC/DC источника питания на основе CoolSet.

Для построения источника питания по схеме, показанной на рис. 47, необходимо в первую очередь решить следующие вопросы:

- Определить основные параметры источни-
- Подобрать ИС CoolSet, наиболее подходящую для решения поставленной задачи.
- Для выбранной ИС CoolSet спроектировать силовой трансформатор.
- Рассчитать остальные (см. рис. 47) элементы схемы.

Определение основных параметров U_{ACmax} ,

 U_{ACmin} , f_{Cemu} , f_{K} , $U_{{\scriptscriptstyle 6blX}}$, $P_{{\scriptscriptstyle 6blX}}$, $\eta\cdot U_{ACmax}$: U_{ACmin} — максимальное и минимальное сетевое входное напряжение, соответственно; f_{cemu} — частота сети 50 или 60 Гц; $f_{\scriptscriptstyle K}$ — коммутационная рабочая частота преобразования; $U_{_{\theta b l X}}$, $P_{_{\theta b l X}}$ — выходное напряжение и выходная мощность; η — коэффициент полезного действия. Для CoolSet возможны несколько вариантов входного напряжения: 195...265 В, и универсальный вход 85...265 В.

Выбор ИС CoolSet сводится к выбору из таблицы («Микросхемы управления AC/DC источником

питания со встроенным ключом CoolSet Infineon») исходя из рекомендаций выходной мощности (при заданном входном диапазоне напряжений). Если необходимо повысить эффективность преобразователя выбирается прибор с меньшим сопротивлением $\mathbf{R}_{\mathrm{DSon}}$ ключа.

Определение входной ёмкости $C_{\it bulk}$, минимального постоянного входного напряжения $U_{\scriptscriptstyle min}$ и коэффициента пульсаций. Входная ёмкость $C_{\scriptscriptstyle bulk}$ фильтрует пульсации 100...120 Гц. Значение входной ёмкости влияет на минимальное входное постоянное напряжение и на коэффициент пульсаций. В среднем, при входном напряжении ~230 В ±15% необходимо обеспечить 1 мкФ на 1 Вт, при входном напряжении ~ 115 В \pm 15% — 2 мк Φ на 1 Вт выходной мощности. Значение U_{min} для заданной C_{bulk} :

$$U_{\min} = \sqrt{2U_{AC\min}^2 - \frac{2P_{\text{Bux}} \cdot \left(\frac{1}{2f_{\text{cct it}}} - t_{C}\right)}{\eta \cdot C_{Bulk}}}$$

где t_{\cdot} — время, в течение которого выпрямитель открыт (2...3 мс).

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБРАТНОХОДОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ HA MUKPOCXEME COOLSET INFINEON

Коэффициент пульсаций входного напряжения:

$$K_{puls} = \frac{2 \cdot \left(\sqrt{2} U_{AC \min} - U_{\min}\right)}{\sqrt{2} U_{AC \min} + U_{\min}}$$

Расчёт трансформатора. Источник питания может работать как в прерывистом режиме, так и в непрерывном, последний используется редко из-за неустойчивости. Рассмотрим прерывистый режим.

Пиковый ток через первичную обмотку ра-

вен

$$I_{pik} = \frac{V_{in} \cdot T_{on}}{L_{pri}}$$

$$T_{on} = \frac{\widehat{\mathcal{O}}_{\max}}{f_{K}}$$
 где $\widehat{\mathcal{O}}_{\max} = 0.5 \ (50\%) -$ максимальный рабочий цикл.

симальный рабочий цикл.
$$L_{\mathit{pri}} = \frac{U_{\mathit{min}} \cdot \partial_{\mathit{max}}}{I_{\mathit{pik}} \cdot f_{\mathit{K}}} \text{, проверяем вы-}$$
 полнение условия:
$$\frac{L_{\mathit{pri}} I_{\mathit{pik}}^2}{2} \cdot f_{\mathit{K}} \triangleright P_{\mathit{bbx}}$$
 .
$$0.4\pi I I^2$$

$$l_{gap} = \frac{0.4\pi L_{pri} I_{pik}^2}{A_C B_{max}^2}$$

Рассчитаем зазор

где $A_{\scriptscriptstyle C}$ — площадь поперечного сечения сердечника _т — максимальная индукция (до 100 кГц – $0,2...0,\overline{25}$ Тл; до 500 кГц -0,1 Тл; до 1 МГц -0,05 Тл). Выберем сердечник из ассортимента Ерсоѕ, исходя из A_{C} , зазор l_{gap} , исходя из допустимых излучаемых помех, должен быть минимален (не более 1...15 мм).

Рассчитаем количество витков в трансфор-

$$N_{\it pri} = \sqrt{\frac{L_{\it pri}}{A_{\it L}}}$$
 , где $A_{\it L}$ — индуктивность на один виток (приводится производителем на феррит при заданном зазоре нГ/вит). Рассчитаем число витков во вторичной обмотке:

$$N_{\text{sec}} = \frac{N_{pri} \left(U_{\text{Bblx}} + U_{fwd} \right)}{U_{\text{min}}} \cdot \frac{1 - \partial_{\text{max}}}{\partial_{\text{max}}}$$

где $U_{\scriptscriptstyle \mathrm{fwd}}$ — прямое падение на диоде. Коэффициент трансформации равен:

$$K_{\text{\tiny T} \rho} = \frac{N_{pri}}{N_{\text{\tiny SCO}}}$$

Выбор схемы демпфирующего устройства (снаббера). Возможно применение двух вариантов — RCD снаббер и D+TVS (диод + TVS диод), последняя схема требует особого внимания и тщательного выбора напряжения срабатывания стабилитрона, так как неправильный выбор может привести к выходу стабилитрона из строя. Определим максимальное напряжение на ключе:

$$U_{DS} = \sqrt{2}U_{4C_{\text{max}}} + K_{T\rho} \cdot U_{\text{Bbix}}$$

К этому напряжению добавляется напряжение «шпильки», связанное с выбросом на индуктивности рассеяния. Напряжение на снаббере равно $K_{{}^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}{}^{\mathrm{\scriptscriptstyle \rho}}}\cdot U_{{}^{\mathrm{\scriptscriptstyle BMX}}}$

При проектировании снаббера с использованием TVS-диода необходимо, чтобы пробивное напряжение диода было больше, чем напряжение на снаббере, так как напряжение пробоя не стабильно и сильно зависит от температуры. В случае, если напряжение пробоя достигнет величины $K_{{}^{\mathrm{T}}{}^{\mathrm{\rho}}}\cdot U_{{}^{\mathrm{вых}}}$, то TVS-диод выйдет из строя. Также необходимо учитывать, чтобы напряжение $U_{DS} = \sqrt{2}U_{AC\, ext{max}} + K_{\text{т}\,\rho} \cdot U_{\text{вых}} + \text{«шпилька»}$

не превысило максимально допустимого значения $U_{ds\ max} = 650\ B$. При использовании RCD-снаббера желательно использовать диод с малым временем прямого включения (это позволит снизить уровень «шпильки» в момент включения диода), однако это приведёт к небольшому нагреву диода.

$$C_{\textit{Clamp}} = \frac{I_{\textit{pik}}^2 L_{\textit{LK}}}{\left(K_{^{\text{T}}\,^{\circ}} \cdot U_{^{\text{Bbix}}} + V_{\textit{Clamp}}\right) V_{\textit{Clamp}}},_{\text{rde}}$$
 $V_{\textit{Clamp}} = 650V - \sqrt{2}U_{\textit{ACMAX}} - K_{^{\text{T}}\,^{\circ}} \cdot U_{^{\text{Bbix}}}$

 $L_{\scriptscriptstyle LK}$ — индуктивность рассеяния трансформа-

$$R_{Clamp} = \frac{\left(V_{Clamp} + K_{\text{T} \text{ p}} \cdot U_{\text{Bbix}}\right)^{2} - \left(K_{\text{T} \text{ p}} \cdot U_{\text{Bbix}}\right)^{2}}{0.5 L_{LK} I_{pik}^{2} f_{K}}$$

Расчёт схемы защиты от короткого замыкания и схемы поциклового ограничения тока заключается в расчёте резистора — датчика тока R_{sense} .

$$R_{sense} = \frac{U_{\text{orp}}}{1,1I_{nik}}$$

где U_{an} — напряжение компаратора, при котором начинается ограничение тока — 1 В, 1.1 — коэффициент запаса, чтобы предотвратить ограничение выходной мощности в номинальном режиме.

Расчёт схемы мягкого старта:

$$t_{\it SofrStart}$$
 = 0,79 \cdot $C_{\it SStart}$ \cdot $R_{\it Sstart}$ где RS $_{\it start}$ =50 кОм.

Расчёт схемы выходного выпрямителя. Максимальное допустимое обратное наряжение, которое должен выдерживать выходной диод:

$$V_{RDiode} = U_{\text{вых}} + \sqrt{2} V_{ACMAX} / K_{\text{т p}}$$

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБРАТНОХОДОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ HA MUKPOCXEME COOLSET INFINEON

Пиковый ток, который должен выдерживать диод:

$$I_{SDiode} = I_{pik} \cdot K_{\tau \rho}$$

Средний ток через выходной диод:

$$I_{SRMS} = I_{SDiode} \sqrt{\frac{\partial_{\text{max}}}{3}}$$

Минимальное значение выходной ёмкости

$$C_{\textit{out}\,\text{min}} = \frac{I_{\textit{вых_max}}\widehat{O}_{\textit{max}}}{V_{\textit{puls}}}, \text{ где } V_{\textit{plus}} - \text{ напряже-}$$
ние пульсаций на выходе, $I_{\textit{вых_max}} - \text{ максимальный}$

ток нагрузки. Ток пульсаций, который должен выдерживать

$$C_{out\, ext{min}} = rac{I_{ ext{Bbix}_ ext{max}} \widehat{\mathcal{O}}_{ ext{max}}}{V_{ ext{puls}}} \qquad I_{ ext{Bbix}_ ext{max}} = rac{P_{ ext{Bbix}}}{U_{ ext{Bbix}}}$$

Расчёт встроенной схемы питания преобразователя. В ИС CoolSet входит встроенный источник тока, соединённый через стоковую цепь силового когда напряжение на конденсаторе C_{vcc}^{∞} достигает 5 В, включается цифровая часть ИС; при возрастании этого напряжения питания до 15 В включается схема управления выходным транзистором.

Ёмкость
$$C_{_{\!V\!C\!C}}$$
 рассчитывается как $I_{_{\!V\!C\!C\!S\!up2}} t_{_{\!softStsrt}}$

V $_{start}$, где V_{start} — напряжение, при котором происходит запуск микросхемы; $I_{VCCSup2}$ — ток потребления микросхемы в рабочем режиме (8 мА); $t_{softStart}$ — время запуска. При проектировании необходимо так рассчитывать обмотку трансформатора, предназначенную для питания микросхемы, чтобы при минимальном входном напряжении напряжение на её выходе всегда было больше, чем $V_{\scriptscriptstyle VCC\text{-}ON}$ + V_{F} , где $V_{VCC\text{-}ON}$ — напряжение запуска микросхемы (15,8 В), V_{F} — прямое падение на диоде. Также необходимо ввести в схему дополнительный параметрический стабилизатор, который будет ограничивать максимальное напряжение питания на допустимом уровне (22 В).

К выпрямительному диоду схемы питания ИС не предъявляется особых требований, по напряжению он рассчитывается так же, как и диод для выходного выпрямителя, ток потребления до 10 мА.

Расчёт схемы обратной связи. Возможны различные схемы построения обратной связи по напряжению, от самых простых — с использованием оптопары и стабилитрона (применяется там, где не предъявляется особых требований к стабильности выходного напряжения) до схемы на основе интегрального прецизионного источника опорного напряжения LMV431 (NSC). Эта схема обладает

высокой точностью регулировки выходного напряжения и применима для любой мощности и любого выходного напряжения.

Для LMV431 (NSC) $V_{RFF} = 2.5 \text{ B}; I_{KAMIN} = 1 \text{ MA};$ $I_{FMAX} = 20 \text{ MA}.$

Оптопару, к примеру, выберем Vishay SFH617-3 (Gc = 1 ...2, коэффициент передачи тока CTR 100...200%, $V_{FD} = 1.2 \text{ B}$).

Максимальный ток через транзистор оптопары, когда она полностью открыта, $I_{\it FBMAX} = 1.75~{\rm MA},$ минимальный ток $I_{\it FBMIN} = 0.5 \, {\rm MA}, \,\,$ эти токи заданы внутренними элементами ИС.

Делитель рассчитывается следующим образом:

$$R_1 = R_2 \cdot \left(rac{U_{_{
m BMX}}}{V_{_{REF}}} - 1
ight)$$
 , где $R_1 + R_2 >> R_{_{
m Harp}}$ $R_2 \le R_{_{
m BX}_{LMV}431}$

$$R_3 \ge \frac{\left(U_{\scriptscriptstyle
m Bbix} - \left(V_{\scriptscriptstyle FD} + V_{\scriptscriptstyle REF}
ight)}{I_{\scriptscriptstyle FMAX}}$$

Резистор

(включённый последовательно с оптопарой) ограничивает максимальный ток через LMV431.

op
$$R_4 \le \frac{\left(U_{\text{вых}} - V_{\text{REF}}\right)}{I_{\text{REF}_{min}}}$$
 (включ

(включённый Резистор параллельно оптопаре и R3) задаёт начальный ток через LMV431.

Коэффициент портоворовен ошибки и оптопары равен $K_{\mathit{FB}} = \frac{\mathit{Gc} \cdot 3700 \; \mathit{Om}}{R_3}$ Коэффициент передачи усилителя сигнала

$$K_{FB} = \frac{Gc \cdot 3700 \ Om}{R_3}$$

Коэффициент передачи делителя равен

$$K_{VD} = \frac{V_{REF}}{U_{BMX}}$$

Коэффициент нестабильности равен

$$\alpha = \frac{1}{K_{VD} \cdot K_{FB} \cdot K_{LMV431}} \cdot 100\%$$

$$K_{LMV431} = \frac{R_5}{R_3 / / R_4}$$
 — коэффициент пере-

дачи по переменному току LMV431.

Коэффициент передачи KLMV431 задаётся, исходя из требуемой нестабильности. Также от петли обратной связи требуется определенное быстродействие, граничная частота усиления LMV431

$$f=rac{1}{2\pi\,R_{\mathrm{5}}C_{\mathrm{2}}}$$
 , и выбирается по графику, в зависимости от рассчитанного коэффициента передачи.

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОБРАТНОХОДОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА MUKPOCXEME COOLSET INFINEON

Цепь C1, R5 компенсирует наклон AЧX петли обратной связи:

$$f = \frac{1}{2\pi R_{\text{\tiny HATP}} C_{\text{\tiny BMX}}}$$

Выбор входного диодного моста. Максимально допустимое напряжение, которое должен выдерживать диодный мост:

$$U_{R} \ge 1, 2 \cdot \sqrt{2} \, U_{AC\, \text{max}}$$

$$I_{F} = \frac{P_{\text{вых}}}{\eta \, U_{ACMIN} \cdot \phi} \; , \; \text{где } \phi \; -$$
 коэффициент мощности = 0.5...0.7

Рекомендации по проектированию трансформатора. Потери, вызванные влиянием паразитных эффектов, складываются из:

- потерь в снаббере, связанных с индуктивностью рассеяния $P1 \sim P_{_{\text{вых}}}$ LLK.
- потерь, связанных с межобмоточной и межвитковой ёмкостью $P2\sim\Sigma C(Uin-Uout)^2*fk$.

$$P = P1 + P2$$

Потери, связанные с межвитковой и межобмоточной ёмкостью, проявляются в виде дополнительной мощности, которая выделяется на транзисторе (ИС CoolSet, Topswich, Viper).

Потери, связанные с индуктивностью рассеяния, выделяются в виде тепла в демпфирующей схеме (снаббере).

1. Необходимо добиваться снижения индуктивности рассеяния трансформатора! Это достигается за счёт улучшения магнитной связи между первичной и вторичной обмотками. Например, можно разбить первичную и вторичную обмотки на несколько частей и намотку выполнить с чередованием: «первичная-вторичная-первичная». Предпочтительнее эти части обмоток соединять после-

довательно! (Вследствие того, что в разных слоях намотки из-за разной магнитной связи, ЭДС будет немного отличаться, могут возникнуть дополнительные потери в виде дополнительного нагрева в проводе).

2. Необходимо добиваться снижения межвитковой и межобмоточной ёмкости трансформатора! Межвитковая ёмкость уменьшается путём правильной укладки провода. Межобмоточная ёмкость уменьшается за счёт увеличения толщины изоляции, уменьшения площади намотки и правильного выведения начала и конца обмотки.

Пункты «1» и «2» противоречат друг другу! При уменьшении индуктивности рассеяния вследствие улучшения магнитной связи обмоток увеличивается паразитная ёмкость! Необходимо взаимно оптимизировать индуктивность рассеяния трансформатора и паразитную ёмкость. Оптимизация проводится в каждом конкретном случае в зависимости от мощности импульсного источника питания (ИИП).

В случае, когда микросхема управления, интегрированная с ключом, выполнена в корпусе DIP или SOIC (мощность ИИП <50...60 Вт) и мощность рассеяния микросхемы <1 Вт, необходимо снижать P2 (потери, связанные с паразитными емкостями)! То есть уменьшать паразитные ёмкости.

В случае, когда микросхема управления, интегрированная с ключом, выполнена в корпусе ТО220, ТО247 (мощность ИИП >50...60 Вт) и мощность рассеивания этой микросхемы (достаточно большая) определяется характеристиками радиатора, необходимо снижать Р1 (потери, связанные с индуктивностью рассеяния)! То есть уменьшать индуктивность рассеяния.

компоненты для построения источников питания

Понижающие (Buck) преобразователи со встроенным ключом National Semiconductor

Возможности: CS — возможность синхронизации, EB — демонстрационная плата, PG — флаг исправности питания, SD — блокировка, SR — синхронное выпрямление, SS — мягкий запуск, EF — вывод флага ошибки, LLC — цепь исключения сквозных токов.

Исполнение: C (Commercial) = 0...+70°C; I (Industrial) = -40...+85°C; E (Extended) = -40...+125°C; M (Military) = -55...+125°C.

Наимен.	VIN [B]	VOUT [B]	FSW [кГц]	Опции	TA [°C]	Особенности	Корпус		
					Выходн	ой ток 150 мА			
LM5009	9100	рег. от 2,5 В	50800	SD	Е	Встроенный ключ 100 В, 0,25 А	MSOP-8, LLP-8		
				E	Выходной	ток 300/400 мА			
LM2608	2,85,5	1,3, 1,5, 1,8	5001000	SD, SS, SR, CS, EB	-25/85	Аналог LM2612, но с режимом линейного стабилизатора при микротоковых нагрузках	μSMD-10		
LM2612	2,85,5	1,05, 1,3, 1,5, 1,8	5001000	SD, SS, SR, CS, EB	-25/85	Выбор режима ШИМ или ЧИМ, ток потребления в режиме блокировки 3 мкА, погрешность выходного напряжения 2%	μSMD-10		
LM2614	2,85.5	1,53,6	5001000	SD, SS, SR, CS, EB	-25/85	Выбор режима ШИМ или ЧИМ, ток потребления в режиме блокировки 3 мкА, погрешность выходного напряжения 2%	μSMD-10		
LM2618	2,85,5	1,8, 1,83, 1,87, 1,92	5001000	SD, SS, SR, CS, EB	-25/85	Аналог LM2612, но с синхронным выпрямлением в режиме ШИМ	μSMD-10		
LM3670	2,55,5	1,2, 1,5, 1,6, 1,8, 1,875, 2,5, 3,3, per. 0,72,5	1000	SD, SS, SR, EB	E	IQ=15 мкА, ШИМ/ЧИМ, рабочий цикл до 100%, только 3 внешних элемента, внутренняя компенсация, стабильная работа с керамическими конденсаторами	S0T23-5		
LM3673	2,75,5	1,2, 1,5, 1,8, 1,875, per.	2000	SR	-30/85	Выбор режима ШИМ или ЧИМ, IQ=16 мкА	μSMD-5		
LM5008	9100	от 2,5	50800	SD, EB	Е	Встроенный п-канальный МОП-ключ 100 В/0.5 А	MSOP-8, LLP-8		
Выходной ток 450 мА									
LM3661	2,75,5	1,25, 1,35, 1,4	600	SD, SS, SR, EB	-30/85	Понижающий преобразователь + линейный LDO-ста- билизатор	μSMD-10		
					Выходн	ой ток 500 мА			
LM2619	2,85,5	1,53,6	5001000	SD, SS, SR, CS, EB	-25/85	Выбор режима ШИМ или ЧИМ, ток потребления в режиме блокировки 3 мкА, погрешность выходного напряжения 2%	TSS0P-14, μSMD-10		
LM2671	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260400	SD, SS, CS	E	Погрешность выходного напряжения 1.5%, семейство SIMPLE SWITCHER®	SO-8, DIP-8, LLP-16, D, W		
LM2674	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260	SD	Е	Погрешность выходного напряжения 1.5%, семейство SIMPLE SWITCHER®	SO-8, DIP-8, LLP-16, D, W		
LM2594	4,540	3,3, 5, 12, 1,2337	150	SD, EB	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	SO-8, DIP-8, D, W		
LM2594HV	4,560	3,3, 5, 12, 1,2357	150	SD	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	SO-8, DIP-8, D, W		
LM2597	4,540	3,3, 5, 12, 1,2337	150	SD, SS, PG	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®, задержка сигнала на выходе «флаг ошибки» при включении преобразова- теля	SO-8, DIP-8, D, W		
LM2597HV	4,560	3,3, 5, 12, 1,2357	150	SD, SS, PG	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®, задержка сигнала на выходе «флаг ошибки» при включении преобразова- теля	S0-8, DIP-8, D, W		
LM2574	4,7540	3,3, 5, 12, 1,2337	52	SD	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	S0-14, DIP-8, D, W		
LM2574HV	4,7560	3,3, 5, 12, 1,2357	52	SD	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	S0-14, DIP-8, D, W		
LM5007	975	рег. до 2,5	50800	SD, EB	Е	Встроенный п-канальный МОП	CERDIP-8		
LM25007	942	рег. от 2,5 В	50800	SD	Е	Встроенный ключ 42 В, 0,7 А	MSOP-8, LLP-8		

Понижающие (Buck) преобразователи со встроенным ключом National Semiconductor (продолжение)

Наимен.	VIN [B]	VOUT [B]	FSW [кГц]	Опции	TA [°C]	Особенности	Корпус		
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ой ток 600 мA	,		
LM3671	2,75,5	1,2, 1,25, 1,375, 1,5, 1,6, 1,8, 1,875, 2,5, 2,8, 3,3, per. 0,73,3	2000	SD, SS, SR, EB	-30/125	IQ=15 мкА, ШИМ/ЧИМ, рабочий цикл до 100%, только 3 внешних элемента, внутренняя компенсация, ста- бильная работа с керамическими конденсаторами	μSMD-5, S0T23-5		
LM3674	2,75,5	1,2, 1,25, 1,375, 1,5, 1,6, 1,8, 1,875, 2,5, 2,8, 3,3, per.	2000		-30/125	ШИМ, IQ=15 мкА	μSMD-5, S0T23-5		
LM2694	830	от 2,5 В	50800	SD, SS	E	Сверхбыстродействующий, не требуется частотной коррекции, тепловая защита	eTSS0P-14, LLP-10		
					Выходн	ой ток 750 мА			
LM2736	3,018	1,2516	550, 1600, 3000	SD, SS, EB	Е	Защита от повышенного напряжения и тепловая защита	S0T23-6		
LM3578A	240	от 1,0	1100	SD, CS	С	Для применения в индустриальном температурном диапазоне используется LM2578A	SO-8, DIP-8, D, W		
LM2695	830	от 2,5 В	50800	SD, SS	Е	Сверхбыстродействующий, не требуется частотной коррекции, тепловая защита	eTSS0P-14, LLP-10		
LM2575	4,7540	3,3, 5, 12, 1,2337	52	SD	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®, версия военного назначения LM1575	SOIC-24, DIP-16, T0263/T0220-5, D, W		
LM2575HV	4,7560	3,3, 5, 12, 1,2357	52	SD	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®, версия военного назначения LM1575HV	SOIC-24, DIP-16, T0263/T0220-5, D, W		
LM2590HV	4,560	3,3, 5, 12, 1,2357	150	SD, SS, PG	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®, задержка сигнала на выходе «флаг ошибки» при включении преобразова- теля	T0263/T0220-7, D, W		
					Выходн	ной ток 1,0 А			
LM2734	320	0,818	550, 1600, 3000	SD, SS, EB	Е	Защита от повышенного напряжения и тепловая защита, ток потребления в режиме блокировки 30 мкА	S0T23-6, LLP-6		
LM2672	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260400	SD, SS, CS, EB	Е	Погрешность выходного напряжения 1,5%, семейство SIMPLE SWITCHER®	SO-8, DIP-8, LLP-16, D, W		
LM2675	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260	SD, EB	Е	Погрешность выходного напряжения 1,5%, семейство SIMPLE SWITCHER®	SO-8, DIP-8, LLP-16, D, W		
LM2591HV	4,560	3,3, 5, 12, 1,2357	150	SD	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-7, D, W		
LM2595	4,540	3.3, 5, 12, 1.2337	150	SD, EB	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-5, D, W		
LM2598	4,540	3,3, 5, 12, 1,2337	150	SD, SS, EF, EB	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®, задержка сигнала на выходе «флаг ошибки» при включении преобразова- теля	T0263-5, T0220-5		
LM2825	4,540	3,3, 5, 12, 1,238	150	SD, SS	E	Полностью интегрированный преобразователь, не требует внешних элементов	DIP-24		
LM2825H	940	715	150	SD, SS	E	Полностью интегрированный преобразователь, не требует внешних элементов	DIP-24		
LM5010A	675	от 2,5	50800	SD, SS, EB	E	Сверхбыстродействующий, не требует компенсации, тепловая защита	TSS0P-14, LLP-10		
LM25010	642	1,2357	501000	SD, SS	E	Сверхбыстродействующий, тепловая защита	TSS0P-14, LLP-10		
LM2830	35,5	0,64,5	1600, 3000	SS	Е	IQ=3,3 MA	S0T23-5, LLP-6		
	Выходной ток 1,5 А								
LM1572	8,516	3,3, 5, 2,45	500	SD, SS, EB	Е	Погрешность выходного напряжения 2%	TSSOP-16		
LM2651	414	1,8, 2,5, 3,3, 1,2413	300	SD, SS, SR, EB	E	Максимальный ток потребления в режиме блокировки во всем температурном диапазоне 20 мкА, типовое значение 7 мкА	TSSOP-16, D, W		

Понижающие (Buck) преобразователи со встроенным ключом National Semiconductor (продолжение)

Наимен.	VIN [B]	VOUT [B]	FSW [кГц]	Опции	TA [°C]	Особенности	Корпус
LM2653	414	1,245,0	300	SD, SS, SR, EF, EB	E	Максимальный ток потребления в режиме блокировки во всем температурном диапазоне 20 мкА, типовое значение 7 мкА	TSSOP-16
LM78S40	2,540	от 1,25	0,1100		Е	Встроенный диод на 1,5 A, доступны версии для ком- мерческого, промышленного и военного применений	DIP-16, D, W
LM3100	4,536	от 0,8 В	рег. до 1 МГц	SD, SS	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	ETSSOP-20
LM26001	338	от 1,25 В	1501000	CS, SD, SS, PG	Е	IQ=40 мкА, погрешность выходного напряжения 1,5%	ETSSOP-16
LM2831	35.5	0,64,5	550, 1600, 3000	SS	Е	IQ=3,3 мА	S0T23-5, LLP-6
					Выходн	ной ток 2,0 А	
LM2592HV	4,560	3,3, 5, 1,2357	150	SD	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-5, D, W
LM2593HV	4,560	3,3, 5, 1,2357	150	SD, SS, EF, EB	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®, задержка сигнала на выходе «флаг ошибки» при включении преобразова- теля	T0263/T0220-7, D, W
LM2852	2,95,5	3,3, 2,5, 1,8, 1,5, 1,2, 1	500, 1500	SD, SS, EB	E	Тепловая защита, встроенная компенсация, малый ток потребления в режиме блокировки	ETSSOP-14
LM2832	35,5	0,64,5	550, 1600, 3000	SS	E	IQ=3,3 мА	LLP-6, EMSOP-
					Выходн	ной ток 2,5 А	
LM2655	414	3,3, 1,2413	300	SD, SS, SR	E	Максимальный ток потребления в режиме блокировки во всем температурном диапазоне 20 мкА	TSS0P-16, D
LM5005	775	1,22563	50500	SD, SS, CS, EB	Е	Режим управления по току, тепловая защита, погрешность 1,5%	ETSSOP-20
LM25005	742	1,22537	50500	SD,SS, CS	E	Режим управления по току, тепловая защита, погрешность 1,5%	TSSOP-20
					Выходн	ной ток 3,0 А	
LM2670	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260400	SD, CS, EB	Е	Погрешность выходного напряжения 2%, семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-7, LLP-14, D, W
LM2673	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260	SS, EB	E	Погрешность выходного напряжения 2%, программируемый порог ограничения тока, семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263-7, T0220-7, LLP-14
LM2676	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260	SD, EB	E	Погрешность выходного напряжения 2%, семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/ T0220-7, LLP-14, D, W
LM2650	4,518	рег. 1,2516	90300	SD, SS, SR, CS, EB	E	Максимальный ток потребления в режиме блокировки во всем температурном диапазоне 25 мкА	SO-24
LM2596	4,540	3,3, 5, 12, 1,2337	150	SD, EB	Е	Семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-5, D, W
LM2599	4,540	3,3, 5, 12, 1,2337	150	SD, SS, EF, EB	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®, задержка сигнала на выходе «флаг ошибки» при включении преобразова- теля	T0263/T0220-5, D, W
LM2576	4,7540	3,3, 5, 12, 1,2337	52	SD	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-5, D, W
LM2576HV	4,7560	3,3, 5, 12, 1,2357	52	SD	E	Семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-5, D, W
LM2650	4,524	от 1,25	100500	SD, SS, PG	E	Сверхбыстродействующий, не требуется частотная коррекция, тепловая защита	ETSSOP-16
Выходной ток 5,0 А							
LM2678	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260	SD, EB	Е	Погрешность выходного напряжения 2%, семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-7, LLP-14
LM2679	840	3,3, 5, 12, 1,2137	260	SS, EB	E	Погрешность выходного напряжения 2%, программиремый порог ограничения тока, семейство SIMPLE SWITCHER®	T0263/T0220-7, LLP-14

Понижающие (Buck) контроллеры, в том числе и многоканальные National Semiconductor

COT-c фиксированным временем включенного состояния, C- управление по току, V- управление по напряжению. IOUT[A]- выходной ток зависит от используемых ключей.

Наиме- нование	VIN [B]	VOUT [B]	Δ VOUT [%]	TUOI [A]	FSW [кГц]	Ре- жим	Число кана- лов	Опции	Особенности	TA [°C]	Корпус
LM1770	2,85	от 0,8	2	4	3001400	СОТ	1	SD, SS, SR, EB	Не требует частотной компенсации	Е	S0T23-5
LM1771	2,85,5	от 0,8	2	6	3001000	СОТ	1	SD, SS, SR	Не требует частотной компен- сации	E	S0T23-5
LM3477/ A	2,9535	от 1,3	1,5	6	500	С	1	SD, SS, EB	Программируемый порог ограничения тока с гистерезисом 36% или 12% в версии с суффиксом А, защита от перенапряжений на выходе	Е	MSOP-8
LM2636	4,514	1,33,5	1,5	20	501000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC	5-разрядное цифровое управление выходным напряжением	0/ 125	TSSOP- 20, SO-20, D, W
LM27241	5,528	от 0,6	1,5	16	200500	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Наличие режима с про- пуском рабочих тактов при малых нагрузках	–5/ 125	TSSOP- 20
LM27262	4,65 5,5	0,8375 1,6	0,9	100	300	V	1	SD, SR, EF	Соответствует спецификации Intel VRD10. 6 разрядный VID код, работа с 2, 3 или 4 фаза- ми, мягкое выключение	40/ 110	TSSOP- 48, LLP-48
LM2727	2,216	от 0,6	1,5	20	502000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC	ИОН 0,6 В, защита от по- вышенного и пониженного напряжения	E	TSSOP- 14
LM2737	2,216	от 0,6	1,5	20	502000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC,EB	ИОН 0,6 В	Е	TSSOP- 14
LM2742	116	от 0,6	1,5	20	502000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC	Защита от пониженного напряжения, третье состояние на выходе при блокировке, TRI-STATE®, минимальное время включенного состояния 40 нс	E	TSS0P- 14
LM2743	116	от 0,6	2	25	501000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC,EB	Защита от пониженного на- пряжения, третье состояние на выходе при блокировке	Е	TSSOP- 14
LM2744	116	от 0,5	0,5	25	501000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC	Версия LM2743 с внешним ИОН для обеспечения высокой точности выходного напряжения	E	TSSOP- 14
LM2745	114	0,6 0,8Vin	1,5	25	501000	V	1	SD, SS, SR, EF, CS, LLC,EB	Возможность запуска с предварительной подачей напряжения смещения на нагрузку, минимальное время включенного состояния 40 нс	E	TSS0P- 14
LM2746	114	0,6 0,8Vin	1	25	501000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Возможность запуска с предварительной подачей напряжения смещения на нагрузку, минимальное время включенного состояния 40 нс	E	TSSOP- 14
LM2748	114	0,6 0,8Vin	1,5	25	501000	V	1	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Возможность запуска с предварительной подачей напряжения смещения на нагрузку, минимальное вре- мя включенного состояния 40 нс	E	TSSOP- 14
LM3475	2,710	0,8 10	1,5	5	до 2000	Н	1	SD, SS, LLC, EB	Быстрый отклик, высокий КПД, широкий диапазон входных напряжений, возмжность работы с рабочим циклом 100%	E	S0T23-5

Понижающие (Buck) контроллеры, в том числе и многоканальные National Semiconductor (продолжение)

Наиме- нование	VIN [B]	VOUT [B]	Δ VOUT [%]	TUOI [A]	FSW [кГц]	Ре- жим	Число кана- лов	Опции	Особенности	TA [°C]	Корпус
LM3485	4,535	от 1,27	2	4	до 1400	Н	1	SD, LLC, EB	Не требует частотной ком- пенсации, ограничение тока, управление Р-канальным ключом	E	MSOP-8
LM3578A	240	от 1,0	7	5	1100	V	1	CS	Доступные пользователю инвертирующий и неинвертирующий входы цепи ОС,встроенный ИОН 1.0 В, для индустриального температурного диапазона предназначена LM2578A	Е	SO-8, DIP-8, D, W
LM5115	4,575	0,7512	1,7	20	1001000	V/CI	1	SD, SS, SR, CS, LLC,EB	Работа при постоянном и переменном входном напря- жении	E	TSSOP- 16, LLP-16
LM3075	4,536	от 1,3	2	20	200, 300	С	1	SD, SS, SR, PG, LLC	Выбираемые пользователем режимы ШИМ/ЧИМ и про- пуска тактов, ограничение тока, защита от пониженного и повышенного напряжения питания	E	TSS0P- 20
LM3489	4,535	от 1,239	2	4	01400	Н	1	SD, LLC	Не требует частотной ком- пенсации, ограничение тока, управление Р-канальным транзистором	E	MSOP-8
LM25115	4,542	0,7512	1,7	20	1001000	V/CI	1	CS, SD, SS, SR, PG, LLC	Версия LM5115 с входным напряжением до 42 В	Е	TSSOP- 16, LLP-16
LM2633	4,530	0,9252 и 1,256	1,5	20	250	С	3	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Сдвиг по фазе между каналами 180°, 5 разрядное цифровое управление выходным напряжением по одному каналу + линейный стабилизатор	E	TSSOP- 48
LM2640	5,530	2,26,0	2	20	200400	С	3	SD, SS, SR, CS	ЧШИМ, раздельный мягкий запуск обеспечивает последовательное включение каналов + линейный стабилизатор 5 В, 50 мА	0/ 125	TSSOP- 28
LM2641	5,530	2,26,0	2	20	300400	С	3	SD, SS, SR, CS	ЧШИМ, раздельный мягкий запуск обеспечивает последовательное включение каналов + линейный стабилизатор 5 В, 50 мА	0/ 125	TSSOP- 28
LM2642	4,530	1,3 13,5	2	20	300	С	2	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Сдвиг по фазе между ка- налами 180°, раздельный мягкий запуск обеспечивает последовательное включе- ние каналов	E	TSSOP- 28
LM2645	4,530	1,35,5	1,5	20	200, 300	С	4	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Сдвиг по фазе между каналами 180°, линей- ный стабилизатор 3.3 В + линейный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением	0/ 125	TSSOP- 48
LM2647	5,528	0,65	1,5	25	200500	V	2	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Режимы ШИМ и ШИМ с пропуском тактов, мягкая блокировка, сдвиг по фазе между каналами 180°	5/ 125	TSSOP- 28, LLP-28
LM2657	4,528	от 0,6	1,5	25	200500	V	2	SD, SS, SR, EF, LLC	Аналог LM2647, но с более низким входным напряжением и перезапуском после перегрузки	E	TSSOP- 28
LM5642/ X	4,536	1,3 32,5	1,5	25	150250/ 200500	С	2	SD, SS, SR, EF, LLC, EB	Сдвиг по фазе между каналами 180°, раздельный мягкий запуск обеспечивает последовательное включение каналов	E	TSSOP- 28
LM2648	4,518	от 1,26	1	40/ 20/ 20	300	СиV	3	SD, SS, SR, EB	Последовательное включение каналов, защита от пониженного и повышенного напряжения, один канал двухфазный, два канала однофазные	0/ 125	TSSOP- 56

Повышающие (Boost) преобразователи со встроенным ключом National Semiconductor

Наиме- нование	VIN [B]	VOUT [B]	ISW [MA]	FSW [кГц]	Оп- ции	Особенности	TA [°C]	Корпус
LM2705	2,27	рег. до 20	150	фикс. время выключен- ного состояния 400 нс	CE	Фиксированное время выключенного состояния, ограничение по току	Е	S0T23-5
LM2703	2,27	рег. до 20	350	фикс. время выключен- ного состояния 400 нс	CE, EB	Фиксированное время выключенного состояния, ограничение по току	Е	S0T23-5
LM2704	2,27	рег. до 20	550	фикс. время выключен- ного состояния 400 нс	CE, EB	Фиксированное время выключенного состояния, ограничение по току	Е	S0T23-5
LM3578A	240	рег. до 50	750	1100		Для индустриального температурного диапазона используется LM2578A	E, C	SO-8, DIP- 8, D, W
LM2698	212	до 18	1350	600, 1250	CE, EB	Погрешность выходного напряжения 2,5%	Е	MSOP-8
LM78S40	2.540	рег. до 40	1500	0.1100		Встроенный диод на 1,5 А	E, C, M	DIP-16, D, W
LM2622	212	рег. до 17,5	1650	600, 1300	CE, EB	ШИМ-преобразователь	Е	MSOP-8, D, W
LM3310	2,57	20	2000	600, 1250	SS, EB	ШИМ-преобразователь + операционный усили- тель + модулятор с двухтактным выходом	Е	LLP-24
LM3311	2,57	20	2000, LDO =350	600, 1250	SS, EB	ШИМ-преобразователь + LDO стабилизатор + операционный усилитель + модулятор с двухтактным выходом	Е	LLP-24
LM5000	3,140	рег. до 80	2000	300, 600, 700, 1250	CE, SS, EB	Встроенный ключ на 80 В, тепловая защита	Е	TSSOP-16, LLP-14
LM2623A	0,814	рег. до 14	2200	3002000	CE, EB	ШИМ-преобразователь с широким спектром применений	Е	MSOP-8, LLP-14
LM2700	2,212	рег. до 17.5	2500	600, 1250	CE	ШИМ-преобразователь	Е	TSSOP-14, LLP-14
LM3224	2,77	рег. до 17	2600	600, 1250	CE, SS, EB	Вывод для подключения внешней цепи частотной компенсации, что позволяет использовать керамические конденсаторы на выходе	Е	MSOP-8
LM2621	1,214	до 14	2850	3002, 000	CE, EB	Постоянное значение рабочего цикла 70%	Е	MSOP-8, D, W
LM2577	3,540	12, 15 рег. до 60	3000	52	SS	Семейство SIMPLE SWITCHER®, версия военного назначения в корпусе ТОЗ-4 LM1577	Е, М	SO-24, DIP-16, T0263-5, T0220-5, D, W
LM2585	440	3,3, 5, 12 рег. до 60	3000	100	SS, EB	Семейство SIMPLE SWITCHER®	Е	T0263-5, T0220-5, D, W
LM2586	440	3,3, 5, 12 рег. до 60	3000	100200	CE, SS, SR, EB	Семейство SIMPLE SWITCHER®	E	T0263-5, T0220-5, D, W
LM2587	440	3,3, 5, 12 рег. до 60	5000	100	SS, EB	Семейство SIMPLE SWITCHER®	Е	T0263-5, T0220-5, D, W
LM2588	440	3,3, 5, 12 рег. до 60	5000	100200	CE, SS, SR, EB	Семейство SIMPLE SWITCHER®	E	T0263-5, T0220-5, D, W

Сдвоенные преобразователи National Semiconductor

Наиме- нов.	Особенности	VIN [B]	VOUT по каналу 1 [B]	VOUT по каналу 2 [B]	FSW [кГц]	RDSON [OM]	Опции	TA [°C]	Корпус
LM2716	Один понижающий и один повышающий пре- образователи в одном корпусе, раздельная по каналам блокировка и мягкий запуск	420	3,3 при 1,8 А	рег. до 20 при 3,6 А	300600	0,12 (повышающий канал), 0,16 (пони- жающий канал)	CE, SS, EB	Е	TSSOP- 24
LM2717	Двухканальный понижающий преобразователь	420	3,3 при 2,2 А	рег. при 3,2 A	300600	0,16	CE, SS, EB	E	TSSOP- 24
LM3370	Двухканальный понижающий преобразователь с синхронным выпрямлением и программированием пр шине I2C	2,75,5	12 при 600 мА	1,83,3 при 600 мА	2000	PFET 0,4, NFET 0,25	CE, SS	-30/125	LLP-16

Повышающие (Boost) контроллеры National Semiconductor

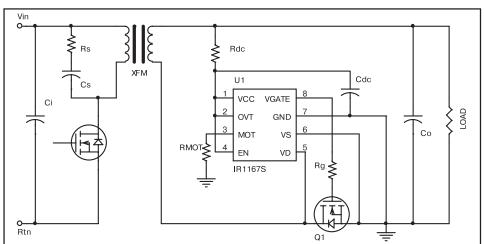
Наиме- нование	VIN [B]	VOUT [B]	FSW [кГц]	Опции	Особенности		Корпус
LM3478	2,9540	Рег.	1001000	SD, SS, EB		Е	MSOP-8
LM3488	2,9540	Рег.	1001000	SD, SS, CS		Е	MSOP-8
LM2578A	240	Рег.	1100	CS	Для применения в коммерческом температурном диапазоне используется LM3578A	Е	SO-8, DIP-8, D, W
LM5020	8100	Рег.	501000	SD, SS, CS, EB	Рабочий цикл до 80% и 50% для LM5020%1 и LM5020%2 соот- ветственно	Е	MS0P-10, LLP-10
LM5021	830	Рег.	501000	SD, SS, CS	Рабочий цикл до 80% и 50% для LM5021-1 и LM5021-2 соот- ветственно	E	MSOP-8, MDIP-8

Микросхемы для синхронного выпрямления International Rectifier

Достоинства синхронного выпрямления очевидны в источниках питания с низким выходным напряжением и большим выходным током. International Rectifier производит серию контроллеров управления синхронным выпрямителем, которые могут работать в любых схемах: Flyback, Forvard, 2-тактных.

Наименова- ние	Корпус	Минимальное напряжение питания, В	напряжение		ный ток драй-	тота преобра-	Ток потребле- ния в ждущем режиме, мкА	управления
IR1167ASPBF	8-Pin SOIC(NB)	11.3	20	200	+2 / -7	до 500	200	10.7
IR1167BSPBF	8-Pin SOIC(NB)	11.3	20	200	+2 / -7	до 500	200	14.5
IR1166SPBF	8-Pin SOIC(NB)	11.3	20	200	+1/-3.5	до 500	200	10.7

Схема включения синхронного выпрямителя на примере Flyback преобразователя:



Микросхемы International Rectifier для построения низковольтных высокоэффективных Buck-преобразователей

Микросхемы управления многофазным понижающим Buck-преобразователем

Наимено- вание	Группа	Максимальный ток драйвера	Частота преоб- разования
IR3507M	XPhase IC		
IR3514M	XPhase IC		250 кГц до 1.5 МГц
IR3502M	XPhase IC		250 кГц до 9.0 МГц
IR3088A	XPhase IC	2.5 А интегрирован- ный драйвер	150 кГц до 1.0 МГц
IR3084M	XPhase IC		150 кГц до 1.0 МГц
IR3084AM	XPhase IC		150 кГц до 1.0 МГц
IR3505M	XPhase IC	2.5 A интегрирован- ный драйвер	250 кГц до 9.0 МГц
IR3500M	XPhase IC		250 кГц до 9.0 МГц

Наимено- вание	Группа	Максимальный ток драйвера	Частота преоб- разования
IR3082AM	XPhase IC		150 кГц до 1.0 МГц
IR3081AM	XPhase IC		150 кГц до 1.0 МГц
IR3084UM	XPhase IC		150 кГц до 1.0 МГц
IR3087	XPhase IC	2.5 А интегрирован-	150 кГц до 1.0 МГц
IR3082M	XPhase IC		150 кГц до 1.0 МГц
IR3080	XPhase IC		150 кГц до 1.0 МГц
IR3086AM	XPhase IC	2.5 A интегрирован- ный драйвер	150 кГц до 1.0 МГц

Микросхемы управления однофазным Buck-преобразователем

Наименование	Корпус	Минимальное напряжение питания, В	Максимальное напряжение питания, В	Минимальное выходное на- пряжение, В	Максимальное выходное на- пряжение, В	Выходной ток преобразова- теля (оценоч- но), А	Частота преоб- разования, кГц
IR3651S	14-Pin SOIC (NB)	4.5	13.2			25	Программиру- ется до 400
IR3624M	10-Lead MLPD	4.0	14	0.6	Vcc * 0.71	10	Фиксирован- ная 600
IR3629	12-Lead MLPD	4.0	30				Фиксирован- ная 300
IR3637S	8-Pin SOIC(NB)	4.0	25	0.8	Vcc * 0.85	15	Фиксирован- ная 400
IRU3037CS	8-Pin SOIC(NB)	4.0	25	1.25	Vcc * 0.96	16	200
IR3638S	14-Pin SOIC (NB)	4.0	25				Фиксирован- ная 400
IRU3037CF	8-Pin TSSOP	4.0	25	1.25	Vcc * 0.96	16	200
IR3628M	12-Lead MLPD	4.0	14	0.6	Vcc * 0.71		Фиксирован- ная I 600
IR3629A	12-Lead MLPD	4.0	30				Фиксирован- ная 600
IRU3037ACS	8-Pin SOIC(NB)	4.0	25	0.8	Vcc * 0.95	15	400
IRU3037ACF	8-Pin TSSOP	4.0	25	0.8	Vcc * 0.95	15	400
IR3637AS	8-Pin SOIC(NB)	4.0	25	0.8	Vcc * 0.85	15	Фиксирован- ная 600

Микросхемы управления 2- и 3-фазными Buck-преобразователем со встроенными драйверами

Наименова- ние	Корпус	Особенности	Мини- мальное напряжение питания, В	Макси- мальное на- пряжение питания, В	Мини- мальное выходное напряже- ние, В	Максималь- ное выход- ное напря- жение, В	Выход- ной ток преобра- зователя (оценоч- но), А	Частота пре- образования, кГц
IR3622AM	32-Lead MLPQ	2-канальный или 2-фазный ШИМ- контроллер	6.7	16	0.8	Vcc * 0.84	80	Программи- руется до 600
IR3621F	28-Pin TSSOP	2-канальный или 2-фазный ШИМ- контроллер	4.7	16	0.8	Vcc * 0.90	60	Программи- руется до 500
IR3622M	32-Lead MLPQ	2-канальный или 2-фазный ШИМ- контроллер	6.7	16	0.8	Vcc * 0.84	80	Программи- руется до 600
IR3623M	32-Lead MLPQ	2-канальный или 2-фазный ШИМ- контроллер	8.5	14.5				200 - 1200
IR3621M	32-Lead MLPQ	2-канальный или 2-фазный ШИМ- контроллер	4.7	16	0.8	Vcc * 0.90	60	Программи- руется до 500
IR3094M	48-Lead MLPQ	3-фазный ШИМ- контроллер						

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ Komпoнeнты International Rectifier

Функционально законченные Buck-преобразователи (со встроенными ключами)

OCP – защита от перегрузки по току, OCT – защита от перегрева, OVP – защита от перенапряжения, Soft Start – мягкий старт

Наименование	Корпус	Особенности	Диапазон входного на- пряжения	Диапазон выходного на- пряжения, В	Выходной ток преобра- зователя, А	Частота пре- образования, кГц	Дополнительные функции
IR3822AM	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	6	300	OCP + OCT and PGood
IR3811M	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	7	600	OCP + OCT and Tracking
IP1001	BGA - 14 x 14 x 3 мм	Один выход	2.5 - 12	0.9 - 3.3	20	200 - 300	OVP + OCP and 5 bit DAC
IP1203	LGA - 9 x 9 x 2.6 мм	Один выход	5.5 - 13.2	0.8 - 8.0	15	200 - 400	OVP + OCP + OTP and Soft Start
IR3822M	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	4	600	OCP + OCT and PGood
IR3821AM	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	9	300	OCP + OCT and PGood
IP1201	BGA - 15.5 х 9.25 х 2.6 мм	2 фазы и один выход либо 2 выхода	3.14 - 5.5	0.9 - 3.3	30	200 - 400	OVP + OCP + OTP and Soft Start
IP1202	BGA - 15.5 х 9.25 х 2.6 мм	2 фазы и один выход либо 2 выхода	5.5 - 13.2	0.8 - 5.0	30	200 - 400	OVP + OCP + OTP and Soft Start
IR3810M	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	12	600	OCP + OCT and Tracking
IR3821M	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	7	600	OCP + OCT and PGood
IR3820AM	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	14	300	OCP + OCT and PGood
IP1206	LGA - 15.5 х 9.25 х 1.97 мм	2 фазы и один выход либо 2 выхода	7.5 - 14.5	0.8 - 5.5	30	200 - 600	OVP + OCP + OTP + Pre-Bias Ext Sync tracking and Sequencing
IR3820M	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	12	600	OCP + OCT and PGood
IR3812M	5 x 6 мм QFN	Один выход	2.5 - 21	0.6 - 12	4	600	OCP + OCT and Tracking

Силовые микросборки (драйвер + ключи) для построения многофазного Buck-преобразователя

Наименование	Корпус	Диапазон входного напряжения	Диапазон выходного напряжения, В	Выходной ток пре- образователя, А	Частота преобразо- вания, кГц
IP2002	BGA - 11 х 11 х 2.6 мм	2.5 - 12	0.9 - 3.3	30	250-1000
IP2003A	LGA - 11 х 9 х 2.2 мм	3 - 13.2	0.8 - 3.3	40	300-1000
IP2005A	LGA - 7.7 x 7.7 x 1.7	6.5 - 13.2	0.8 - 5.5	40	250-1500
IP2003	LGA - 11 x 11 x 2.2 мм	3 - 13.2	0.8 - 3.3	40	300-1000
IP2001	BGA - 11 x 11 x 3 мм	5 - 12	0.9 - 3.3	20	250-1000

N-канальные транзисторы Infineon OptiMOS®2&3 85 V и 100 V для DC/DC-преобразователей

Наименование	Корпус	VDS (max), B	RDS (on) (max) (10V), мОм	ID (max), A	IDpuls (max), A
IPD12CNE8N G	PG-T0252-3	85,0	12,4	67,0	268,0
IPD16CNE8N G	PG-T0252-3	85,0	16,0	53,0	212,0
IPD25CNE8N G	PG-T0252-3	85,0	25,0	35,0	140,0
IPB051NE8N G	PG-T0263-3	85,0	5,1	100,0	400,0
IPB06CNE8N G	PG-T0263-3	85,0	6,2	100,0	400,0
IPB08CNE8N G	PG-T0263-3	85,0	8,2	95,0	380.0
IPB12CNE8N G	PG-T0263-3	85,0	12,9	67,0	268,0
IPB16CNE8N G	PG-T0263-3	85,0	16,2	53,0	212,0
IPB26CNE8N G	PG-T0263-3	85,0	26,0	35,0	140,0
IPB04CNE8N G	PG-T0263-3	85,0	3,9	100,0	400,0
IPI05CNE8N G	PG-T0262-3	85,0	5,4	100,0	400,0
IPI06CNE8N G	PG-T0262-3	85,0	6,5	100,0	400,0
IPI08CNE8N G	PG-T0262-3	85,0	8,5	95,0	380,0
IPI12CNE8N G	PG-T0262-3	85,0	12,6	67,0	268,0
IPI16CNE8N G	PG-T0262-3	85,0	16,5	53,0	212,0
IPI26CNE8N G	PG-T0262-3	85,0	26,0	35,0	140,0
IPP054NE8N G	PG-T0220-3	85,0	5,4	100,0	400,0
IPP06CNE8N G	PG-T0220-3	85,0	6,5	100,0	400,0
IPP08CNE8N G	PG-T0220-3	85,0	8,5	95,0	380,0
IPP12CNE8N G	PG-T0220-3	85,0	12,9	67,0	268,0
IPP16CNE8N G	PG-T0220-3	85,0	16,5	53,0	212,0
IPP26CNE8N G	PG-T0220-3	85,0	26,0	35,0	140,0
IPP04CNE8N G	PG-T0220-3	85,0	4,2	100,0	400,0
IPD12CN10N G	PG-T0252-3	100,0	12,4	67,0	268,0
IPD12CN10N G	PG-T0252-3	100,0	16,0	53,0	212,0
IPD10CN10N G	PG-T0252-3	100,0	25,0	35,0	140,0
IPD33CN10N G	PG-10252-3 PG-T0252-3	100,0	33,0		108,0
IPD33CN10N G	PG-T0252-3	100,0	49,0	27,0	80,0
IPD49CN10N G		· · ·		20,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	PG-T0252-3	100,0	64,0	17,0	68,0
IPD78CN10N G	PG-T0252-3	100,0	78,0	13,0	52,0
IPB04CN10N G	PG-T0263-3	100,0	3,9	100,0	400,0
IPB05CN10N G	PG-T0263-3	100,0	5,4	100,0	400,0
IPB06CN10N G	PG-T0263-3	100,0	6,5	100,0	400,0
IPB08CN10N G	PG-T0263-3	100,0	8,5	95,0	380,0
IPB12CN10N G	PG-T0263-3	100,0	12,9	67,0	268,0
IPB16CN10N G	PG-T0263-3	100,0	16,0	53,0	212,0
IPB26CN10N G	PG-T0263-3	100,0	26,0	35,0	140,0
IPI05CN10N G	PG-T0262-3	100,0	5,4	100,0	400,0
IPI06CN10N G	PG-T0262-3	100,0	6,5	100,0	400,0
IPI08CN10N G	PG-T0262-3	100,0	8,5	95,0	380,0
IPI12CN10N G	PG-T0262-3	100,0	12,9	67,0	268,0
IPI16CN10N G	PG-T0262-3	100,0	16,5	53,0	212,0
IPI26CN10N G	PG-T0262-3	100,0	26,0	35,0	140,0
IPI35CN10N G	PG-T0262-3	100,0	35,0	27,0	108,0
IPI50CN10N G	PG-T0262-3	100,0	50,0	20,0	80,0
IPI80CN10N G	PG-T0262-3	100,0	78,0 8,2	13,0	52,0
BSC082N10LS G	PG-TDSON-8	100,0		100,0	400,0
BSC118N10NS G BSC196N10NS G	PG-TDSON-8 PG-TDSON-8	100,0 100,0	11,8 19,6	71,0 45,0	280,0 164,0
		1	7,9		
BSC079N10NS G BSC750N10ND G	PG-TDSON-8 PG-TDSON-8	100,0	7,9	100,0	400,0
IPP04CN10N G	PG-TDSUN-8 PG-T0220-3	100,0 100,0	3,9	13,0 100,0	52,0 400,0
IPP04CN10N G	PG-10220-3 PG-T0220-3	100,0	5,4	100,0	400,0
IPP05CN10N G	PG-10220-3 PG-T0220-3	100,0	5,1	100,0	400,0
IPP05CN10L G		-	·		400,0
IFFUOCINIUIN G	PG-T0220-3	100,0	6,5	100,0	400,0

N-канальные транзисторы Infineon OptiMOS®2&3 85 V и 100 V для DC/DC-преобразователей (продолжение)

Наименование	Корпус	VDS (max), B	RDS (on) (max) (10V), мОм	ID (max), A	IDpuls (max), A
IPP06CN10L G	PG-T0220-3	100,0	6,2	100,0	400,0
IPP08CN10N G	PG-T0220-3	100,0	8,5	95,0	380,0
IPP08CN10L G	PG-T0220-3	100,0	8,0	98,0	392,0
IPP12CN10N G	PG-T0220-3	100,0	12,9	67,0	268,0
IPP12CN10L G	PG-T0220-3	100,0	12,0	69,0	276,0
IPP16CN10N G	PG-T0220-3	100,0	16,5	53,0	212,0
IPP16CN10L G	PG-T0220-3	100,0	15,7	54,0	216,0
IPP26CN10N G	PG-T0220-3	100,0	26,0	35,0	140,0
IPP35CN10N G	PG-T0220-3	100,0	35,0	27,0	108,0
IPP50CN10N G	PG-T0220-3	100,0	50,0	20,0	80,0
IPP80CN10N G	PG-T0220-3	100,0	78,0	13,0	52,0

N-канальные транзисторы Infineon OptiMOS®2&3 25-40V для DC/DC-преобразователей

Наименование	Корпус	Тип	VDS (max), B	RDS (on) (max) (10V)	RDS (on) (max) (4.5V)
BSC026N02KS G	PG-TDSON-8	n-channel single	20,0		2,6 m0hm
BSC046N02KS G	PG-TDSON-8	n-channel single	20,0		4,6 m0hm
BSC019N02KS G	PG-TDSON-8	n-channel single	20,0		1,95 m0hm
IPD13N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	12,8 Ohm	21,9 Ohm
IPD04N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	3,8 m0hm	5,7 m0hm
IPDH4N03LA G	P-T0252-3	n-channel single	25,0	4,2 m0hm	7,4 m0hm
IPD05N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	5,1 m0hm	8,4 m0hm
IPDH5N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	5,2 m0hm	8,5 m0hm
IPD06N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	5,7 m0hm	9,4 m0hm
IPDH6N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	6,0 m0hm	10,0 m0hm
IPD09N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	8,6 m0hm	14,8 m0hm
IPDH9N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	9,2 m0hm	16,6 m0hm
IPD03N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	3,2 m0hm	5,1 m0hm
IPD10N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	10,4 m0hm	17,4 m0hm
IPB03N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	2,7 m0hm	4,1 m0hm
IPB04N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	3,9 m0hm	6,4 m0hm
IPB05N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	4,6 Ohm	7,8 0hm
IPB06N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	5,9 m0hm	9,5 m0hm
IPBH6N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	6,2 Ohm	10,2 Ohm
IPB09N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	8,9 m0hm	15,1 m0hm
IPB11N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	11,2 m0hm	18,2 m0hm
IPB14N03LA G	PG-T0263-3	n-channel single	25,0	13,6 Ohm	22,7 Ohm
IPU04N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	4,0 m0hm	5,9 m0hm
IPU05N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	5,3 m0hm	8,6 m0hm
IPU06N03LA G	P-T0251-3	n-channel single	25,0	5,9 m0hm	9,6 m0hm
IPUH6N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	6,2 m0hm	10,2 m0hm
IPU09N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	8,8 m0hm	15,0 m0hm
IPU10N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	10,4 m0hm	17,4 m0hm
IPU13N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	12,8 m0hm	21,9 m0hm
IPS03N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	3,4 m0hm	5,3 m0hm
IPS10N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	10,4 m0hm	17,4 m0hm
IPS13N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	12,8 m0hm	21,9 m0hm
IPS04N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	4,0 m0hm	5,9 m0hm
IPSH4N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	4,4 m0hm	7,6 m0hm
IPS05N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	5,3 m0hm	8,6 m0hm
IPSH5N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	5,4 m0hm	8,7 m0hm
IPS06N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	5,9 m0hm	9,6 m0hm
IPSH6N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	6,2 m0hm	10,2 m0hm
IPS09N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	8,8 m0hm	15,0 m0hm
IPSH9N03LA G	PG-T0251-3	n-channel single	25,0	9,4 m0hm	16,8 m0hm
IPI03N03LA	PG-T0262-3	n-channel single	25,0	3,0 m0hm	4,4 m0hm

N-канальные транзисторы Infineon OptiMOS®2&3 25-40V для DC/DC-преобразователей (продолжение)

Наименование	Корпус	Тип	VDS (max), B	RDS (on) (max) (10V)	RDS (on) (max) (4.5V)
IPI04N03LA	P-T0262-3	n-channel single	25,0	4,2 m0hm	6,7 m0hm
IPI05N03LA	P-T0262-3	n-channel single	25,0	4,9 m0hm	8,1 m0hm
IPI06N03LA	P-T0262-3	n-channel single	25,0	6,2 m0hm	9,9 m0hm
IPI09N03LA	PG-T0262-3	n-channel single	25,0	9,2 m0hm	15,5 m0hm
IPI11N03LA	PG-T0262-3	n-channel single	25,0	11,5 m0hm	18,5 m0hm
IPI14N03LA	P-T0262-3	n-channel single	25,0	13,9 m0hm	23,1 m0hm
IPF04N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	4,0 m0hm	5,9 m0hm
IPF05N03LA G	PG-T0252-3		25,0	5,3 m0hm	8,6 m0hm
IPF06N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single n-channel single	25,0	5,9 m0hm	9,6 m0hm
				*	
IPFH6N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	6,2 m0hm	10,2 m0hm
IPF09N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	8,8 m0hm	15,0 m0hm
IPF10N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	10,4 m0hm	17,4 m0hm
IPF13N03LA G	PG-T0252-3	n-channel single	25,0	12,8 m0hm	21,9 m0hm
BSC020N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	2,0 m0hm	3,0 m0hm
BSC024N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	2,4 m0hm	3,7 m0hm
BSC029N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	2,9 m0hm	4,5 m0hm
BSC037N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	3,7 m0hm	6,0 m0hm
BSC048N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	4,8 Ohm	7,9 Ohm
BSC072N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	7,2 Ohm	10,9 Ohm
BSC085N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	8,5 Ohm	13,1 Ohm
BSC106N025S G	PG-TDSON-8	n-channel single	25,0	10,6 Ohm	16,7 Ohm
IPP03N03LA	PG-T0220-3	n-channel single	25,0	3,0 m0hm	4,4 m0hm
IPP04N03LA	PG-T0220-3	n-channel single	25,0	4,2 m0hm	6,7 m0hm
IPP05N03LA	PG-T0220-3	n-channel single	25,0	4,9 m0hm	8,1 m0hm
IPP06N03LA	PG-T0220-3	n-channel single	25,0	6,2 m0hm	9,9 m0hm
IPP09N03LA	PG-T0220-3	n-channel single	25,0	9,2 m0hm	15,5 m0hm
IPP11N03LA	PG-T0220-3	n-channel single	25,0	11,5 m0hm	18,5 m0hm
IPP14N03LA	PG-T0220-3	n-channel single	25,0	13,9 m0hm	23,1 m0hm
IPD031N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	3,1 m0hm	4,4 m0hm
IPD040N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	4,0 m0hm	5,9 m0hm
IPD050N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	5,0 m0hm	7,3 m0hm
IPD060N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	6,0 m0hm	9,0 m0hm
IPD075N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	7,5 m0hm	11,4 m0hm
IPD090N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	9,0 m0hm	13,5 m0hm
IPD105N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0		
IPD135N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	10,5 m0hm 13.5 m0hm	15,5 m0hm 20,5 m0hm
IPB034N03L G	PG-T0252-3 PG-T0263-3		30,0	3,4 m0hm	4,7 m0hm
		n-channel single		*	-
IPB042N03L G	PG-T0263-3	n-channel single	30,0	6,0 m0hm	4,2 m0hm
IPB055N03L G	PG-T0263-3	n-channel single	30,0	5,5 m0hm	7,8 m0hm
IPB065N03L G	PG-T0263-3	n-channel single	30,0	6,5 m0hm	9,5 m0hm
IPB080N03L G	PG-T0263-3	n-channel single	30,0	8,0 m0hm	11,9 m0hm
IPB096N03L G	PG-T0263-3	n-channel single	30,0	9,6 m0hm	14,1 m0hm
IPB147N03L G	PG-T0263-3	n-channel single	30,0	14,7 m0hm	21,7 m0hm
IPB009N03L G	PG-T0263-7	n-channel single	30,0	0,95 m0hm	1,3 m0hm
IPU039N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	3,9 m0hm	5,2 m0hm
IPU050N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	5,0 m0hm	7,3 m0hm
IPU060N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	6,0 m0hm	9,0 m0hm
IPU075N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	7,5 m0hm	11,4 m0hm
IPU090N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	9,0 m0hm	13,5 m0hm
IPU105N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	10,5 m0hm	15,5 m0hm
IPU135N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	13,5 m0hm	20,5 m0hm
IPS031N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	3,1 m0hm	4,4 m0hm
IPS040N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	4,0 m0hm	5,9 m0hm
IPS050N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	5,0 m0hm	7,3 m0hm
IPS060N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	6,0 m0hm	9,0 m0hm
IPS075N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	7,5 m0hm	11,4 m0hm
IPS090N03L G	PG-T0251-3	n-channel single	30,0	9,0 m0hm	13,5 m0hm
		n-channel single	30,0	10,5 m0hm	15,5 m0hm
IPS105N03L G	PG-T0251-3	ii ciidiiiici siiiqic			
IPS105N03L G IPS135N03L G	PG-T0251-3 PG-T0251-3	n-channel single	30,0	13,5 m0hm	20,5 m0hm

N-канальные транзисторы Infineon OptiMOS®2&3 25-40V для DC/DC-преобразователей (продолжение)

Наименование	Корпус	Тип	VDS (max), B	RDS (on) (max) (10V)	RDS (on) (max) (4.5V)
IPF050N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	5,0 m0hm	7,3 m0hm
IPF060N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	6,0 m0hm	9,0 m0hm
IPF075N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	7,5 m0hm	11,4 m0hm
IPF090N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	9,0 m0hm	13,5 m0hm
IPF105N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	10,5 m0hm	15,5 m0hm
IPF135N03L G	PG-T0252-3	n-channel single	30,0	13,5 m0hm	20,5 m0hm
BSZ035N03LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	30,0	3,5 m0hm	5,7 m0hm
BSZ050N03LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	30,0	5,0 m0hm	7,8 m0hm
BSZ058N03LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	30,0	5,8 m0hm	8,9 m0hm
BSZ088N03LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	30,0	8,8 m0hm	11,0 m0hm
BSZ100N03LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	30,0	10.0 m0hm	15,0 m0hm
BSZ130N03LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	30,0	13,0 m0hm	17,0 m0hm
BSC016N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	1,6 m0hm	2,3 m0hm
BSC020N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	2,0 m0hm	2,9 m0hm
BSC025N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	2,5 m0hm	3,6 m0hm
BSC030N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	3,0 m0hm	4,7 m0hm
BSC042N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	4,2 m0hm	6,5 m0hm
BSC050N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	5,0 m0hm	7,5 m0hm
BSC050N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	5,7 m0hm	8,5 m0hm
BSC037N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	8,0 m0hm	12,0 m0hm
BSC090N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	9,0 m0hm	13,3 m0hm
BSC100N03LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	30,0	10,0 m0hm	14,2 m0hm
BSC120N03LS G			30,0	,	,
IPP034N03L G	PG-TDSON-8	n-channel single	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,0 m0hm	16,5 m0hm
	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	3,4 m0hm	4,7 m0hm
IPP042N03L G	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	4,2 m0hm	6,0 m0hm
IPP055N03L G	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	5,5 m0hm	7,8 m0hm
IPP065N03L G	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	6,5 m0hm	9,5 m0hm
IPP080N03L G	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	8,0 m0hm	11,8 m0hm
IPP096N03L G	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	9,6 m0hm	14,1 m0hm
IPP114N03L G	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	11,4 m0hm	16,4 m0hm
IPP147N03L G	PG-T0220-3	n-channel single	30,0	14,7 m0hm	21,7 m0hm
IPD036N04L G	PG-T0252-3	n-channel single	40,0	3,6 m0hm	4,9 m0hm
IPD088N04L G	PG-T0252-3	n-channel single	40,0	8,8 m0hm	12,6 m0hm
IPD105N04L G	PG-T0252-3	n-channel single	40,0	10,5 m0hm	15,0 m0hm
IPD160N04L G	PG-T0252-3	n-channel single	40,0	16,0 m0hm	23,0 m0hm
IPD170N04N G	PG-T0252-3	n-channel single	40,0	17,0 m0hm	
IPD038N04N G	PG-T0252-3	n-channel single	40,0	3,8 m0hm	
IPB075N04L G	PG-T0263-3	n-channel single	40,0	7,5 m0hm	10,5 m0hm
IPB039N04L G	PG-T0263-3	n-channel single	40,0	3,9 m0hm	5,2 m0hm
IPB093N04L G	PG-T0263-3	n-channel single	40,0	9,3 m0hm	13,1 m0hm
IPB041N04N G	PG-T0263-3	n-channel single	40,0	4,1 m0hm	
IPB052N04N G	PG-T0263-3	n-channel single	40,0	5,2 m0hm	
IPB011N04L G	PG-T0263-7	n-channel single	40,0	1,1 m0hm	1,4 m0hm
IPB011N04N G	PG-T0263-7	n-channel single	40,0	1,1 m0hm	
BSZ040N04LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	40,0	4,0 m0hm	5,6 m0hm
BSZ097N04LS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	40,0	9,7 m0hm	14,2 m0hm
BSZ042N04NS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	40,0	4,2 m0hm	
BSZ105N04NS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	40,0	10,5 m0hm	
BSZ165N04NS G	PG-TSDSON-8	n-channel single	40,0	16,5 m0hm	
BSC035N04LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	3,5 m0hm	5,3 m0hm
BSC050N04LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	5,0 m0hm	7,2 m0hm
BSC059N04LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	5,9 m0hm	8,5 m0hm
BSC093N04LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	9,3 m0hm	13,7 m0hm
BSC019N04NS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	1,9 m0hm	
BSC030N04NS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	3,0 m0hm	
BSC054N04NS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	5,4 m0hm	
BSC018N04LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	1,8 m0hm	2,5 m0hm
BSC027N04LS G	PG-TDSON-8	n-channel single	40,0	2,7 m0hm	4,1 m0hm
			- '		-

Транзисторы Infineon CoolMOS на рабочее напряжение 500, 600, 650, 800 В

S5-1-е поколение общего применения, C3-3-е поколение со способностью выдерживать импульсный ток с более высокими амплитудами (в 1,5 раза больше) благодаря большей переходной электрической проводимости gfs (крутизна характеристики ID=f(VDS)) и более прямоугольной форме области безопасной работы; совместимость с любыми ИМС управления: меньше падение напряжения на затворе при насыщении транзистора до 5,5 В и порог включения транзистора — 3 В; выше рабочая частота за счет более малого значения времени переключения — время переключения уменьшено более, чем в 1,5 раза. CP- последнее поколение приборов с предельной эффективностью. Значительно снижено статическое сопротивление канала и увеличены допустимые токи. Высокая скорость переключения — крутизна фронта до 50 В/нс. Малый заряд затвора и лучший характеристический коэффициент качества RDSon*QG среди аналогичных мировых образцов.

RDS (on) мОм	Ток 25°C, A	S0T-223	TO-252 (D-PAK)	T0-251 (I-PAK)	T0-263 (D2-PAK)	TO-220	TO-220 FullPAK	TO-262 (I2-PAK)	T0-247
6000	0,8	SPN01N60C3	SPD01N60C3	SPS01N60C3 SPU01N60C3					
3000	1,8	SPN02N60S5 SPN02N60C3	SPD02N60S5 SPD02N60C3	SPU02N60S5 SPU02N60C3 SPS02N60C3	SPB02N60S5 SPB02N60C3	SPP02N60S5 SPP02N60C3			
2700	2					SPP02N80C3			
1400	4		SPD04N80C3			SPP04N80C3	SPA04N80C3		
1400	3,2	SPN03N60S5 SPN03N60C3	SPD03N60S5 SPD03N60C3	SPU03N60C3 SPS03N60C3 SPU03N60S5	SPB03N60S5 SPB03N60C3	SPP03N60S5 SPP03N60C3	SPA03N60C3		
950	4,5	SPN04N60S5	SPD04N60S5 SPD04N60C3	SPU04N60S5 SPS04N60C3 SPU04N60C3	SPB04N60S5 SPB04N60C3	SPP04N60S5 SPP04N60C3	SPA04N60C3		
950	6		SPD06N80C3			SPP06N80C3	SPA06N80C3		
600	7,3		SPD07N60S5 SPD07N60C3	SPU07N60S5 SPU07N60C3	SPB07N60S5 SPB07N60C3	SPP07N60S5 SPP07N60C3	SPA07N60C3	SPI07N60S5 SPI07N60C3	SPW07N60CFD
600	8					SPP08N80C3	SPA08N80C3	SPI08N50C3 SPI08N80C3	
520			IPD50R520CP	IPS50R520CP		IPP50R520CP	IPA50R520CP		
380	11					SPP11N80C3	SPA11N80C3	SPI11N60C3 SPI11N60CFD SPI11N60S5	SPW11N80C3 SPW11N60S5 SPW11N60CFD
399			IPD50R399CP			IPP50R399CP	IPA50R399CP	IPI50R399CP	IPW50R399CP
385	9		IPD60R385CP		IPB60R385CP	IPP60R385CP	IPA60R385CP	IPI60R385CP	IPW60R385CP
380	11				SPB11N60S5 SPB11N60C3	SPP11N60S5 SPP11N60C3	SPA11N60C3	SPI11N60S5 SPI11N60C3 SPI12N50C3 SPI11N65C3	SPW11N60S5 SPW11N60C3 SPW12N50C3
350	10					IPP50R350CP	IPA50R350CP	IPI50R350CP	IPW50R350CP
280	15					SPP15N60C3	SPA15N60C3	SPI15N60C3 SPI15N60CFD	SPW15N60C3 SPW15N60CFD SPW16N50C3
299	11				IPB50R299CP	IPP60R299CP IPP50R299CP	IPA60R299CP IPA50R299CP	IPI60R299CP	IPW60R299CP IPW50R299CP
290	17				SPB17N80C3	SPP17N80C3	SPA17N80C3		SPW17N80C3
250	12				IPB50R250CP	IPP50R250CP	IPA50R250CP	IPI60R250CP	IPW60R250CP
199	16				IPB60R199CP IPB50R199CP	IPP60R199CP IPP50R199CP	IPA60R199CP IPA50R199CP	IPI60R199CP	IPW60R199CP IPW50R199CP
190	20				SPB20N60S5 SPB20N60C3	SPP20N60S5 SPP20N60C3 SPP20N65C3	SPA20N60C3 SPA20N65C3	SPI20N65C3 SPI20N60C3 SPI20N60CFD SPI21N50C3	SPW20N60S5 SPW20N60C3 SPW20N60CFD SPW21N50C3
165	24				IPB60R165CP	IPP60R165CP	IPA60R165CP	IPI60R165CP	IPW60R165CP SPW24N60C3 SPW24N60CFD
140					IPB50R140CP	IPP50R140CP	IPA50R140CP		IPW50R140CP
125	25					IPP60R125CP	IPA60R125CP IPA50R125CP	IPI60R125CP	IPW60R125CP
100	35								SPW35N60CFD SPW35N60C3 SPW32N50C3

Транзисторы Infineon CoolMOS на рабочее напряжение 500, 600, 650, 800 В (продолжение)

RDS (on) м0м	Ток 25°С, А	S0T-223	T0-252 (D-PAK)	T0-251 (I-PAK)	T0-263 (D2-PAK)	T0-220	TO-220 FullPAK	T0-262 (I2-PAK)	T0-247
99	31				IPB60R099CP	IPP60R099CP		IPI60R099CP	IPW60R099CP
70	47								SPW47N65C3 SPW47N60S5 SPW47N60C3 SPW47N60CFD IPW60R075CP SPW52N50C3
45	60								IPW60R045CP

Диоды IR-Vishay для корректоров коэффициента мощности

Наименование	Корпус	Исполнение	Rth(JC)	VRRM(V) (min)	IF (AV) (A)	VFM (V)	trr(ns) (max)	IFSM 60Hz (A)	IR (uA)	IRRM (A)
15ETH06	TO-220AC					2,1	35			
15ETH06-1PBF	TO-262		1,3			2.2	29	120		
15ETH06FP	TO-220 FullPak					2,2	51			
15ETH06PBF	TO-220AC					2,1	35			
15ETH06SPBF	D2-Pak (UltraFast)	Discrete	1,3	600	15	2,2	29	120		
15ETX06	TO-220AC					1,8	18			
15ETX06-1PBF	TO-262		1,3			3,2	22	170	50	2,4
15ETX06PBF	TO-220AC					1,8	18			
15ETX06SPBF	D2-Pak (UltraFast)		1,3			3,2	22	170	50	2,4
30EPH06PBF	TO-247 (2 LEAD)	Discrete	0,9	600	30	2,1	40	325	250	N/A
30ETH06	TO-220AC									
30ETH06-1PBF	TO-262	Discrete	1,1			2,6	31	200	50	3,5
30ETH06PBF	TO-220AC	Discrete				2,1	40			
30ETH06SPBF	D2-Pak (UltraFast)		1,1			2,6	31	200	50	3,5
8ETH06	TO-220AC					2,1	30			
8ETH06-1PBF	TO-262		2			2,4	25]	50	2,4
8ETH06PBF	TO-220AC					2,1	30			
8ETH06SPBF	D2-Pak (UltraFast)	D:t-	2	/00		2,4	25		50	2,4
8ETX06	TO-220AC	Discrete		600	8		16]		
8ETX06-1PBF	TO-262		2			3	17	110	50	2,3
8ETX06PBF	TO-220AC					3	16			
8ETX06SPBF	D2-Pak (UltraFast)		2				17	110	50	2,3

Диоды NXP для корректоров коэффициента мощности

Наименование	Корпус	Исполнение	VRRM(V) (min)	IF (AV) (A)	VFM (V)	trr(ns) (max)
BYC10-600	SOT78	ĺ			1.0	
BYC10B-600	S0T404				1,8	
BYC10X-600	S0D113				1,32	
BYC5-600	SOT78				4.75	
BYC5B-600	S0T404		600	15	1.75	19
BYC5X-600	S0D113				1.4	
BYC8-600	SOT78	5			1,8	
BYC8B-600	S0T404	Discrete			1.85	
BYC8X-600	S0D113				1.43	
BYT79-500	SOT78		500	14	1,05	60
BYV29-600	SOD59			9	1,11	60
BYV29B-600	S0T404		400	9	1,11	60
BYV34-600	SOT78		600	20	1,16	60
BYV34X-600	SOT186A			20	1,16	60

Диоды Infineon для корректоров коэффициента мощности на основе карбида кремния (sic)

Наименование	Корпус	IF (max), A	IF, SM (max), A	VF (typ), B	IR (max), мА	QC (typ), nC
IDT02S60C	PG-T0220-2	2,0	11,5	1,7	150,0	3,2
IDT03S60C	PG-T0220-2	3,0	16.0	1,7	300,0	5,0
IDT04S60C	PG-T0220-2	4,0	32,0	2,0	50,0	8,0
IDD04S60C	PG-T0252-3	4,0	32,0	1,7	50,0	8,0
IDT05S60C	PG-T0220-2	5,0	42,0	2,0	70,0	12,0
IDT06S60C	PG-T0220-2	6,0	49,0	2,0	80,0	15,0
IDT08S60C	PG-T0220-2	8,0	59,0	2,0	100,0	19,0
IDT10S60C	PG-T0220-2	10,0	84,0	2,0	140,0	24,0
IDT12S60C	PG-T0220-2	12,0	98,0	2,0	160,0	30,0
IDT16S60C	PG-T0220-2	16,0	118,0	2,0	200,0	38,0
SDT02S60	P-T0220-2	2,0	4,1	1,8	100,0	4,6
SDD04S60	P-T0252-3	4,0	12,5	1,7	200,0	13,0
SDT04S60	PG-T0220-2	4,0	12,5	1,7	200,0	13,0
SDT05S60	PG-T0220-2	5,0	18,5	1,5	200,0	14,0
SDT06S60	PG-T0220-2	6,0	21,5	1,5	200,0	21,0
SDB06S60	PG-T0220-3	6,0	21,5	1,5	200,0	21,0
SDT08S60	PG-T0220-2	8,0	26,0	1,5	300,0	24,0
SDT10S60	PG-T0220-2	10,0	31,0	1,5	350,0	29,0
SDT12S60	PG-T0220-2	12,0	36,0	1,5	400,0	30,0

Микросхемы управления AC/DC источником питания со встроенным ключом CoolSet Infineon

прибор третьего поколения — функция Jitter (эффект качания частоты преобразования ±5%, позволяет снизить уровень помех в сеть). частота преобразования 100 кГц (В — 67 кГц) — порядковый номер

Наименование	Корпус	VDS (max), B	ID (max), A	RDS (on) (typ), Ом	Pout (85-265VAC)	Pin(230VAC ±15%)	f (sw)
ICE3A0565Z	PG-DIP-7	650,0	0,5	4,7	12W	25W	100khz
ICE3A2065Z	PG-DIP-7	650,0	2,0	0,92	28W	57W	100khz
ICE3A0365	PG-DIP-8	650,0	0,3	6,45	10mW	22W	100khz
ICE3B1565	PG-DIP-8	650,0	1,5	1,7	20W	42W	67khz
ICE3B2065	PG-DIP-8	650,0	2,0	0,92	28W	57W	67khz
ICE3B2565	PG-DIP-8	650,0	2,5	0,65	33W	68W	67khz
ICE3B0365J	PG-DIP-8	650,0	0,3	6,45	10W	22W	67khz±5%
ICE3B0565J	PG-DIP-8	650,0	0,5	4,7	12W	25W	67khz±5%
ICE3B1565J	PG-DIP-8	650,0	1,5	1,7	20W	42W	67khz±5%
ICE3A1065L	PG-DIP-8	650,0	1,0	2,95	16W	32W	100khz
ICE3A1565L	PG-DIP-8	650,0	1,5	1,7	20W	42W	100khz
ICE3B0365L	PG-DIP-8	650,0	0,3	6,45	10W	22W	67khz
ICE3A1065LJ	PG-DIP-8	650,0	1,0	2,95	16W	32W	100khz±5%
ICE3A0565	PG-DIP-8	650,0	0,5	4,7	12W	25W	100khz
ICE3A1065	PG-DIP-8	650,0	1,0	2,95	16W	32W	100khz
ICE3A1565	PG-DIP-8	650,0	1,5	1,7	20W	42W	100khz
ICE3A2065	PG-DIP-8	650,0	2,0	0,92	28W	57W	100khz
ICE3A2565	PG-DIP-8	650,0	2,5	0,65	33W	68W	100khz
ICE3B0365	PG-DIP-8	650,0	0,3	6,45	10W	22W	67khz
ICE3B0565	PG-DIP-8	650,0	0,5	4,7	12W	25W	67khz
ICE3B1065	PG-DIP-8	650,0	1,0	2,95	16W	32W	67khz
ICE3BR4765J	PG-DIP-8	650,0	0,5	4,7	10W	22W	67khz±5%
ICE3B0365JG	PG-DS0-16/12	650,0	0,3	6,4	10W	22W	67khz±5%
ICE3B0565JG	PG-DS0-16/12	650,0	0,5	4,7	12W	25W	67khz±5%
ICE3A2065P	PG-T0220-6	650,0	2,0	3,0	50W	57W	100khz
ICE3B2065P	PG-T0220-6	650,0	2,0	3,0	50W	57W	67khz
ICE3B3065P	PG-T0220-6	650,0	3,0	2,1	62W	128W	67khz
ICE3B3565P	PG-T0220-6	650,0	3,5	1,55	83W	170W	67khz
ICE3B5065P	PG-T0220-6	650,0	5.0	0,95	105W	220W	67khz
ICE3B5565P	PG-T0220-6	650,0	5,5	0,79	120W	240W	67khz
ICE3A3065P	PG-T0220-6	650,0	3,0	2,1	62W	128W	100khz
ICE3A3565P	PG-T0220-6	650,0	3,5	1,55	83W	170W	100khz
ICE3A5065P	PG-T0220-6	650,0	5,0	0,95	105W	220W	100khz
ICE3A5565P	PG-T0220-6	650,0	5,5	0,79	120W	240W	100khz

Микросхемы управления AC/DC Infineon

QR- квазирезонансный Flyback, PWM — ШИМ-управление, PWM+PFC CCM — ШИМ- управление + управление KKM.

Продукт	Тип управления	Корпус	Применение	Выход	Напряжение питания мин,, В	Напряжение питания макс,, В	Макс, ток потребления, мА
TDA16846	QR	PG-DIP-14	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	8,0	16,0	8,0
TDA16847	QR	P-DIP-14	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	8,0	16,0	8,0
TDA4605-2	QR	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	7,5	15,5	12,0
TDA4605-3	QR	P-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	7,5	15,5	14,0
ICE1QS01	QR	P-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	11,0	25,0	3,6
ICE2QS01	QR	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	11,0	27,0	3,6
ICE1QS01G	QR	P-DSO-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	9,0	20,0	12,5
ICE2AS01	PWM	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	8,5	21,0	8,0
ICE2BS01	PWM	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	8,5	21,0	7,5
ICE3DS01L	PWM	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	8,5	20,0	8,7
ICE3AS02	PWM	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Drier	8,5	20,0	8,5
ICE3BS02	PWM	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	8,5	20,0	8,0
ICE3BS02L	PWM	PG-DIP-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	8,5	20,0	8,0
TDA4916GG	PWM	P-DSO-24	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	9,0	15,0	9,0
ICE2AS01G	PWM	PG-DSO-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	8,5	21,0	8,0
ICE2BS01G	PWM	PG-DSO-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	8,5	21,0	7,5
ICE3DS01LG	PWM	PG-DSO-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	8,5	20,0	8,7
ICE3AS02G	PWM	PG-DSO-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	8,5	20,0	8,5
ICE3BS02G	PWM	PG-DSO-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	8,5	20,0	8,0
ICE3BS03LJG	PWM	PG-DSO-8	Off-Line SMPS	MOSFET Gate Driver	10,5	26,0	2,5
TDA16888	PWM+PFC CCM	PG-DIP-20	Off-Line SMPS	PWM+PFC Gate Driver	11,0	19,0	50,0
TDA16888G	PWM+PFC CCM	P-DS0-20	Off-Line SMPS	PWM+PFC Gate Driver	11,0	19,0	50,0

Микросхемы управления DC/DC Vishay

Серия прибо- ров	Описание	Мин, входное напряж, источника питания, В	Макс, входное напряж, источника питания, В	Мин, напряж, микро- схемы, В	Макс, напряж, микро- схемы, В	Опор- ное напря- жение, В	Частота преобразо- вания	Корпус
Si9110								PDIP-14
6:0444	Высоковольтный ШИМ-контроллер	10	120	9,5	13,5	4	1000	S0-14 PDIP-14
Si9111								S0-14
C:0110	D	0	00	0.5	10.5	,	1000	PDIP-14
Si9112	Высоковольтный ШИМ-контроллер	9	80	9,5	13,5	4	1000	S0-14
Si9113	Высоковольтный ШИМ-контроллер с управлением по току для линий ISDN	23,5	200	10	14	1,3	500	SO-14
Si9114A	Высокочастотный ШИМ-контроллер	15	200	9,5	16.5	4	500	PDIP-14
317 I 14A		13	200	7,5	10,5	4	300	S0-14
Si9118	ШИМ-контроллер с программируемой макси- мальной скважностью для телекоммуникаци-	10	200	10	16.5	/1	500	SO-16
Si9119	онного оборудования	10	200	10	16,5	4	500	
Si9120	Универсальный высоковольтный ШИМ-контроллер	15	450	9,5	13,5	4	1000	PDIP-16
								S0-16
Si9122	Полумостовой котроллер для DC/DC со встро- енным драйвером и выходом для управления	12	72	10	13.2	3.3	500	MLP65-20 PPAK
017122	синхронным выпрямителем	12	, -		10,2	0,0	000	TSSOP-20
C:0100A	Полумостовой котроллер для DC/DC со встро-	20	7.5	10.5	10.0	2.2	F00	MLP65-20 PPAK
Si9122A	енным драйвером и выходом для управления синхронным выпрямителем	28	75	10,5	13,2	3,3	500	TSSOP-20
	Полумостовой котроллер для DC/DC со встро-							MLP65-20
Si9122E	енным драйвером и выходом для управления	36	75	10,5	13,2	3,3	500	PPAK
	синхронным выпрямителем							TSSOP-20

Микросхемы управления DC/DC Vishay (продолжение)

Серия прибо- ров	Описание	Мин, входное напряж, источника питания, В	Макс, входное напряж, источника питания, В	Мин, напряж, микро- схемы, В	Макс, напряж, микро- схемы, В	Опор- ное напря- жение, В	Частота преобразо- вания	Корпус
SiP11203 SiP11204	Драйвер для управления синхронным выпря- мителем с функцием защиты от перенапря- жения, со встроенным усилителем ошибки и	5,5	13	5,5	13	1,225		MLP44-16 PPAK
SiP2800	опорным стабилизатором							S0-8
								TSS0P-8 S0-8
SiP2801		6				5		TSSOP-8
SiP2802	Маломощный ШИМ-контроллер с управлением		10	10	15			SO-8 TSSOP-8
SiP2803	в токовом режиме	5	12	12	15	4		SO-8 TSSOP-8
SiP2804		J				5		S0-8
		6	_					TSSOP-8 S0-8
SiP2805		5				4		TSSOP-8
Si9165	Понижающий/повышающий преобразователь с синхронным выпрямлением 600 мА	2,7	6			1,3		TSSOP-20
Si9167	Понижающий преобразователь с синхронным выпрямлением 600 мА (для зарядки литиевых аккумуляторов)	5	10			1,3		TSSOP-20
Si9169	Понижающий/повышающий преобразователь с синхронным выпрямлением 1 А	2,7	6			1,3		TSSOP-20
Si9172	Понижающий преобразователь для зарядки литиевых аккумуляторов	2,7	6			1,2		MSOP-10
Si9174	Высокоэффективный понижающий преобразователь с синхронным выпрямителем с цифро-	2,6	6			0,4		MS0P-10
31/1/4	вым регулированием выходного напряжения (для зарядки литиевых аккумуляторов)	2,7	0			0,4		MLP33-10
Si9175	Высокоэффективный понижающий преобразователь с синхронным выпрямителем с регулированием выходного напряжения (для зарядки литиевых аккумуляторов)	2,6	6			1,3		MLP33-10
Si9176	Высокоэффективный понижающий преобразователь с синхронным выпрямителем с регулированием выходного напряжения (для зарядки литиевых аккумуляторов)	2,6	6			1,3		MLP33-10
Si9177	Понижающий преобразователь 200 мА	2,7	6			1,2		MLP33-10
SiP12101	Высокоэффективный понижающий преобразователь с синхронным выпрямителем с регулированием выходного напряжения (для зарядки литиевых аккумуляторов)	2,6	6			1,3	2000	MSOP-10
SiP1759	Инвертирующий преобразователь	1,6	5,5			1,235	1500	MSOP-10
Si9140	Контроллер для понижающего преобразовате- ля с выходом на синхронный выпрямитель	3	6,5			1,5		S0-16 TSS0P-16
Si9145	Низковольтный ШИМ-контроллер	2,7	7			1,5		S0-16 TSS0P-16
Si9150	Контроллер для понижающего преобразовате- ля с выходом на синхронный выпрямитель	6	16,5			2,5		SO-14
Si9166	Контроллер для управления понижающим/по- вышающим прербразователем	2,7	6			1,3		TSSOP-16
Si9168	Контроллер для понижающего/повышающего преобразователя с выходом на синхронный выпрямитель (для зарядки литиевых аккумуляторов)	5	10			1,3		TSSOP-16
SiP12201	Контроллер для понижающего/повышающего преобразователя с выходом на синхронный выпрямитель	4,2	26			0,6	500	MLP33-10
SiP12201A	Контроллер для понижающего/повышающего преобразователя с выходом на синхронный выпрямитель	4,2	26				500	MLP33-10
SiP12202	Контроллер для понижающего/повышающего преобразователя с выходом на синхронный выпрямитель	2,7	5,5			0,6	500	MLP33-10
SiP12205	Контроллер для понижающего/повышающего преобразователя с выходом на синхронный выпрямитель	5	26			0,6	300	MLP33-10 PPAK

Трансформаторы Wurth Elektronik для построения DC/DC-конвертеров серии WE-FLEX

ER11/5

Продукт	Индуктивность базовой обмотки, мк Гн	Номинальный ток Ток насыщения базовой обмотки, А базовой обмотки, А			Индуктивность рассеяния базовой обмотки, мкГн	
749196101	198,6	0,55	0,01	344	0,21	
749196111	27,4	0,55	0,22	344	0,21	
749196121	14,7	0,55	0,54	344	0,21	
749196131	10,9	0,55	0,73	344	0,21	
749196141	8.5	0.55	0.96	344	0.21	

749 196 101 — без зазора для понижающей топологии или push-pull преобразователя. 749 196 111; 749 196 121; 749 196 131 и 749 196 141 — с зазором для обратноходовой топологии преобразователя.

ER14.5/6

Продукт	Индуктивность базовой обмотки, мк Гн	Номинальный ток Ток насыщения базовой обмотки, А базовой обмотки, А (Сопротивление базовой обмотки,мОм	Индуктивность рассеяния базовой обмотки, мкГн	
749196201	140	0,95	0,02	159	0,17	
749196211	21,6	0,95	0,36	159	0,17	
749196221	11,6	0,95	0,84	159	0,17	
749196231	8,3	0,95	1,20	159	0,17	
749196241	6,6	0,95	1,55	159	0,17	

749 196 201— без зазора для понижающих прямоходовых и push-pull преобразователей. 749 196 211; 749 196 221; 749 196 231 и 749 196 241— с зазором для обратноходовой топологии преобразователя.

EFD15

Продукт	Индуктивность базовой обмотки, мк Гн	Номинальный ток базовой обмотки, А	Ток насыщения базовой обмотки, А	Сопротивление базовой обмотки,мОм	Индуктивность рассеяния базовой обмотки, мкГн	
749196301	153,8	0,97	0,02	140	0,13	
749196311	749196311 23,3 0,97		0,33	140	0,13	
749196321	14,2	0,97	0,63	140	0,13	
Продукт	Индуктивность базовой обмотки, мк Гн	Номинальный ток базовой обмотки, А	Ток насыщения базовой обмотки, А	Сопротивление базовой обмотки,мОм	Индуктивность рассеяния базовой обмотки, мкГн	
749196331	9,3	0,97	1,09	140	0,13	
749196341	7,9	0,97	1,33	140	0,13	

749 196 301 — без зазора для понижающих прямоходовых и push-pull преобразователей.

749 196 311; 749 196 321; 749 196 331 and 749 196 341 — с зазором для обратноходовой топологии преобразователя.

EFD20

Продукт	Индуктивность базовой обмотки, мк Гн	Номинальный ток Ток насыщения базовой обмотки, А базовой обмотки,		Сопротивление базовой обмотки,мОм	Индуктивность рассеяния базовой обмотки, мкГн	
749196500	87,1	1,91	0,03	30	0,18	
749196510	9,9	1,91	1,17	30	0,18	
749196520	5,3	1,91	2,53	30	0,18	
749196530	4,3	1,91	2,91	30	0,18	
749196540	3,4	1,91	4,18	30	0,18	
749196501	196	1,70	0,02	71,1	0,24	
749196511	22,3	1,70	0,49	71,1	0,24	
749196521	12,0	1,70	1,73	71,1	0,24	
749196531	749196531 9,7		2,20	71,1	0,24	
749196541	7,6	1,70	2,46	71,1	0,24	

749 196 500 and 749 196 501 — без зазора для понижающих прямоходовых и push-pull преобразователей. 749 196 510; 749 196 520; 749 196 530; 749 196 540; 749 196 511; 749 196 521; 749 196 531 and 749 196 541 — с зазором для обратноходовой топологии преобразователя.

Трансформаторы Wurth Elektronik для построения Flyback DC/DC-конвертеров серии WE-PoE и WE-PoE Plus

ER11/5

Наименование	Индуктивность первичной обмотки, мкГн	Индуктивность рассеяния, мкГн	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Выходная мощность, Вт
749119133	400	4	3,3	3×0,4	4
749119150	400	4	5,0	3×0,27	4

ER14.5/6

Наименование	Индуктивность первичной обмотки, мкГн	Индуктивность рассеяния, мкГн	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Выходная мощность, Вт
749119218	210	4,5	1,8	3×1,3	7
749119233	210	2,5	3,3	0,7/1,4	7
749119250	210	2,5	5,0	3×0,47	7
7491192912	210	2,5	12/5/3,3	0,58	7

EFD15

Наименование Индуктивность первичной обмотки, мкГн		Индуктивность рассеяния, мкГн	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Выходная мощность, Вт	
749119318	120	2,5	1,8	3×2,4	13	
749119333	120	3,5	3,3	3×1,35	13	
749119350	120	2,5	5,0	3×0,9	13	
7491193912	120	1,5	12/5/3,3	1,2	13	

EP13

Наименование Индуктивность первичной обмотки,		Индуктивность рассеяния, мкГн	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Выходная мощность, Вт					
749119933	127	3,5	3,3	2×2	13					
7491199331	127	3,5	3,3	2×2	13					
749119950	127	1,3	5,0	2×1,3	13					
7491199501	127	2,5	5,0	2×1,3	13					
7491199112	127	1,3	12	2×0,55	13					
7491199212	127	2,3	12	2× 0,55	13					

EFD20

Наимено- вание	Индуктив- ность пер- вичн. обмотки	Коэфф. трансфор- мации	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Напряжение вспомогательной обмотки, В	Сопротивление первичной обмотки, мОм		Сопротивление вспомогательной обмотки, мОм
749119433	42	11:1:3,3	3,3	9	11	99	3,2	220
749119450	65	7:1:3	5	6	15	116	4	230
7491194501	42	7:1:2.25	5	6	12	84	5	225
7491194912	42	3:1:1	12	2,5	12	61	18	180

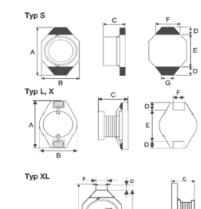
Трансформаторы Wurth Elektronik для построения Flyback AC/DC-преобразователей серии WE-UNIT

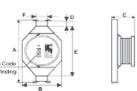
Наименова- ние	Выходная мощность, Вт	Индуктивность первичной обмотки	Коэффициент трансформа- ции	Сопротивле- ние первичной обмотки, Ом	Сопротивле- ние вторич- ной обмотки	Сопротивление вспомогатель- ной обмотки, Ом	рассеяния,	Напряжение изоляции, кВг
749118105	3	2,8	18,9 : 1	11	50	-	280	4
7491181012	3	2,8	8,1 : 1	11	290	-	220	4
7491181024	3	2,8	4:1	11	1200	-	245	4
749118115	3	2,8	18,9 : 1	8	50	-	175	4
7491181112	3	2,8	8,1 : 1	8	290	-	175	4
7491181124	3	2,8	4:1	8	1200	-	172	4
749118205	9	0,9	19:1:1	4,3	26	26	175	4
7491182012	9	0,9	9,5:1:1	4,3	75	85	146	4
7491182024	9	0,9	4,4 : 1	4,25	210	-	145	4
749118215	9	0,9	19:1:1	4,25	28	28	120	4
7491182112	9	0,9	9,5:1:1	4,25	94	102	112	4
7491182124	9	0,9	4,4 : 1	4,25	155	-	100	4

Дроссели Wurth Elektronik для построения маломощных DC/DC-преобразователей серии WE-PD4



Тип	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)	Е (мм)	F (мм)	G (мм)
S	6,6	4,45	2,92	1,0	4,32	3,05	1,27
L	12,7	10,0	5,0	2,4	7,6	2,0	-
XL	22,0	15,0	7,0	2,3	15,0	8,0	-
X	18,54	15,24	7,11	12,7	13,15	2,54	2,54





s

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Типовое сопро- тивление, м0м	Макс. сопротив- ление, мОм	Номинальный ток, А	Ток насыще- ния, А	Кол-во в упаковке
7445501	1,0	± 20	17,0	50,0	2,90	2,90	500
74455015	1,5	± 20	20,0	50,0	2,80	2,60	500
74455022	2,2	± 20	28,0	70,0	2,40	2,30	500
74455033	3,3	± 20	44,0	80,0	2,00	2,00	500
74455047	4,7	± 20	63,0	90,0	1,50	1,50	500
74455068	6,8	± 20	92,0	130,0	1,40	1,20	500
7445510	10	± 20	121,0	160,0	1,20	1,10	500
74455115	15	± 20	176,0	230,0	1,10	0,90	500
74455122	22	± 20	255,0	370,0	0,80	0,70	500
74455133	33	± 20	362,0	510,0	0,60	0,58	500
74455147	47	± 20	556,0	640,0	0,50	0,50	500
74455168	68	± 20	790,0	860,0	0,40	0,40	500
7445520	100	± 20	1080,0	1270,0	0,30	0,31	500
74455215	150	± 20	1450,0	2000,0	0,25	0,27	500
74455222	220	± 20	2580,0	3110,0	0,20	0,22	500
74455233	330	± 20	4150,0	5000,0	0,16	0,18	500
74455247	470	± 20	5580,0	6800,0	0,16	0,15	500
7445530	1000	± 20	11500,0	1380,0	0,07	0,10	500

серия WE-PD4 (продолжение)

L

Наименование	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Типовое сопро- тивление, мОм	Макс. сопротив- ление, мОм	Номинальный ток, А	Ток насыще- ния, А	Кол-во в упаковке
7445601	1,0	± 20	4,1	7,0	8,60	14,25	600
74456015	1,5	± 20	5,8	9,0	7,20	10,70	600
74456022	2,2	± 20	7,0	11,0	6,50	10,20	600
74456025	2,5	± 20	8,9	12,0	5,80	10,00	600
74456033	3,3	± 20	10,7	15,0	5,30	7,00	600
74456047	4,7	± 20	14,6	19,0	5,00	6,00	600
74456056	5,6	± 20	24,4	32,0	4,00	6,00	600
74456068	6,8	± 20	26,0	34,0	3,80	5,10	600
7445610	10,0	± 20	34,9	45,0	3,30	5,00	600
74456115	15,0	± 20	43,2	60,0	2,90	3,60	600
74456122	22,0	± 20	71,0	95,0	2,60	3,10	600
74456133	33,0	± 10	94,0	120,0	2,30	2,60	600
74456147	47,0	± 10	142,1	190,0	1,80	2,14	600
74456168	68,0	± 10	187,0	240,0	1,60	1,70	600
7445620	100,0	± 10	253,0	330,0	1,40	1,50	600
74456215	150,0	± 10	447,6	590,0	1,00	1,20	600
74456222	220,0	± 10	601,0	780,0	0,90	1,10	600
74456233	330,0	± 10	893,0	1150,0	0,70	0,80	600
74456247	470,0	± 10	1315,0	1700,0	0,60	0,65	600
74456268	680,0	± 10	1942,0	2600,0	0,50	0,55	600
7445630	1000,0	± 10	2940,0	3900,0	0,40	0,52	600
74456322	2200,0	± 10	6264,0	8200,0	0,25	0,26	600
74456347	4700,0	± 10	13295,0	17000,0	0,20	0,20	600
74456382	8200,0	± 10	28000,0	35000,0	0,11	0,17	600
7445640	10000,0	± 10	29880,0	39000,0	0,10	0,15	600

ΧL

Наименование	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Типовое сопро- тивление, мОм	Макс. сопротив-	Номинальный	Ток насыще- ния, А	Кол-во
74457006		. 20	· ·	ление, мОм	ток, А	ния, A 36.0	в упаковке 250
	0,47	± 20	1,3	1,6	18,0	, .	
74457008	0,8	± 20	2,3	2,8	16,0	35,0	250
74457010	1,0	± 20	3,1	3,6	15,0	32,0	250
74457012	1,2	± 20	3,2	3,8	15,0	30,0	250
74457018	1,8	± 20	4,5	5,4	13,0	25,0	250
74457027	2,7	± 20	7,0	8,4	10,0	20,0	250
74457033	3,3	± 20	7,7	9,2	9,0	17,0	250
74457047	4,7	± 20	8,8	11,0	8,5	15,0	250
74457056	5,6	± 20	12,4	15,0	7,8	14,0	250
74457068	6,8	± 20	14,1	17,0	7,5	12,0	250
74457082	8,2	± 20	15,5	19,0	7,0	11,0	250
7445710	10,0	± 20	17,2	21,0	6,5	10,0	250
74457112	12,0	± 15	23,6	28,0	5,5	9,5	250
74457115	15,0	± 15	28,8	35,0	5,0	9,0	250
74457118	18,0	± 15	33,0	40,0	4,6	8,0	250
74457122	22,0	± 15	39,3	47,0	4,0	6,5	250
74457127	27,0	± 15	43,5	52,0	3,8	6,0	250
74457133	33,0	± 15	58,4	70,0	3,4	5,5	250
74457139	39,0	± 10	65,0	78,0	3,2	5,2	250
74457147	47,0	± 10	91,1	109,0	2,8	5,0	250
74457156	56,0	± 10	96,5	116,0	2,6	4,5	250
74457168	68,0	± 10	112,0	134,0	2,4	4,0	250
74457182	82,0	± 10	144,0	173,0	2,2	3,5	250
7445720	100,0	± 10	168,0	202,0	2,0	3,0	250
74457212	120,0	± 10	196,0	235,0	1,6	3,0	250
74457215	150,0	± 10	223,0	268,0	1,5	2,6	250
74457218	180,0	± 10	256,0	307,0	1,3	2,5	250
74457222	220,0	± 10	323,0	388,0	1,2	2,4	250
74457227	270,0	± 10	399,0	479,0	1,1	2,2	250

серия WE-PD4 (продолжение)

Наименование	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Типовое сопро- тивление, мОм	Макс. сопротив- ление, мОм	Номинальный ток, А	Ток насыще- ния, А	Кол-во в упаковке
74457233	330,0	± 10	470,0	564,0	1,0	1,9	250
74457239	390,0	± 10	558,0	670,0	0,90	1,7	250
74457247	470,0	± 10	674,0	809,0	0,82	1,4	250
74457256	560,0	± 10	855,0	1026,0	0,78	1,3	250
74457268	680,0	± 10	1002,0	1200,0	0,72	1,2	250
74457282	820,0	± 10	1172,0	1400,0	0,64	1,1	250
74457230	1000,0	± 10	1506,0	1800,0	0,56	1,0	250

Наименование	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Типовое сопро- тивление, мОм	Макс. сопротив- ление, мОм	Номинальный ток, А	Ток насыще- ния, А	Кол-во в упаковке
74458001	1,0	± 20	5,0	9,0	8,60	25,00	300
74458002	2,2	± 20	8,0	14,0	7,10	20,25	300
74458003	3,3	± 20	10,0	18,0	6,20	15,75	300
74458005	5,6	± 20	12,0	20,0	5,30	13,10	300
74458010	10	± 20	21,0	31,0	4,30	10,00	300
74458115	15	± 20	30,0	36,0	4,00	8,00	300
74458122	22	± 20	43,0	47,0	3,50	7,00	300
74458133	33	± 20	60,0	66,0	3,00	5,50	300
74458147	47	± 20	76,0	86,0	2,60	4,50	300
74458168	68	± 20	110,0	130,0	2,30	3,60	300
7445820	100	± 20	141,0	190,0	1,80	3,40	300
74458215	150	± 20	210,0	250,0	1,50	2,70	300
74458220	220	± 20	326,0	380,0	1,20	2,40	300
74458233	330	± 20	431,0	560,0	1,00	1,90	300
74458247	470	± 20	633,0	850,0	0,82	1,60	300
74458268	680	± 20	954,0	1100,0	0,72	1,30	300
7445830	1000	± 20	1370,0	1800,0	0,56	1,10	300

серия WE-PD3



Е (мм)

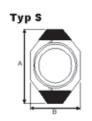
4,32

7,6

7,6

12,7

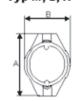
98	98



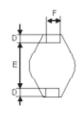




Typ M, L, X







Тип

S

М

L

Χ

А (мм)

6,6

12,7

12,7

18,54

В (мм)

4,45

10,3

10,0

15,24

С (мм) D (мм)

1,0

2,4

2,4

2,54

2,92

2,7

4,9

7,62

5							
Наимено- вание	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7445101	1,0	± 20	0,014	0,040	3,0	1,62	500
74451015	1,5	± 20	0,018	0,045	2,80	1,13	500
74451022	2,2	± 20	0,021	0,050	1,80	1,08	500
74451033	3,3	± 20	0,025	0,055	1,60	0,77	500
74451039	3,9	± 20	0,040	0,057	1,50	0,77	500
74451047	4,7	± 20	0,045	0,060	1,40	0,72	500
74451068	6,8	± 20	0,055	0,065	1,20	0,50	500
7445110	10,0	± 20	0,056	0,075	1,00	0,45	500
74451115	15,0	± 20	0,075	0,090	0,80	0,27	500
74451122	22,0	± 20	0,090	0,110	0,70	0,16	500

F (мм)

3,05

2,5

2,0

2,54

G (мм)

1,27

серия WE-PD3 (продолжение)

Наимено- вание	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
74451133	33,0	± 20	0,114	0,190	0,60	0,15	500
74451147	47,0	± 20	0,160	0,230	0,50	0,14	500
74451168	68,0	± 20	0,221	0,290	0,40	0,12	500
7445120	100,0	± 20	0,393	0,480	0,30	0,09	500
74451215	150,0	± 20	0,410	0,590	0,26	0,05	500
74451222	220,0	± 20	0,580	0,770	0,22	0,08	500
74451233	330,0	± 20	1,000	1,400	0,20	0,02	500
74451247	470,0	± 20	1,700	1,800	0,19	0,02	500
74451268	680,0	± 20	1,9500	2,200	0,18	0,02	500
7445130	1000,0	± 20	2,950	3,400	0,15	0,02	500

М

Наимено- вание	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7445301	1,5	± 20	0,029	0,038	3,00	6,30	1000
7445302	2,2	± 20	0,037	0,045	2,76	6,00	1000
74453031	3,3	± 20	0,052	0,062	2,20	5,40	1000
7445303	3,9	± 20	0,058	0,070	2,10	4,20	1000
7445304	4,7	± 20	0,065	0,078	1,90	3,60	1000
74453010	10,0	± 20	0,117	0,145	1,24	2,90	1000
74453112	12,0	± 20	0,160	0,185	1,10	2,70	1000
74453115	15,0	± 20	0,170	0,200	1,00	2,30	1000
74453122	22,0	± 20	0,248	0,300	0,80	1,90	1000
74453133	33,0	± 20	0,371	0,450	0,70	1,40	1000
74453147	47,0	± 20	0,481	0,650	0,60	1,30	1000
74453156	56,0	± 20	0,552	0,680	0,52	1,20	1000
74453168	68,0	± 20	0,620	0,800	0,48	1,10	1000
74453182	82,0	± 20	1,030	1,200	0,42	0,90	1000
7445320	100,0	± 20	1,164	1,400	0,40	0,70	1000

L

Наимено- вание	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7445402	2,2	± 20	0,023	0,027	3,80	6,80	600
7445403	3,3	± 20	0,026	0,030	2,90	5,90	600
7445404	4,7	± 20	0,034	0,040	2,70	4,70	600
74454068	6,8	± 20	0,041	0,055	2,20	4,10	600
74454010	10,0	± 20	0,048	0,065	2,00	3,20	600
74454115	15,0	± 20	0,064	0,085	1,70	3,00	600
74454122	22,0	± 15	0,076	0,100	1,40	2,30	600
74454133	33,0	± 15	0,127	0,160	1,20	1,80	600
74454147	47,0	± 15	0,158	0,190	1,00	1,40	600
74454168	68,0	± 15	0,285	0,340	0,82	1,35	600
7445420	100,0	± 10	0,373	0,420	0,68	1,10	600
74454215	150,0	± 10	0,456	0,520	0,55	0,80	600
74454220	220,0	± 10	0,683	0,800	0,45	0,70	600
74454233	330,0	± 10	1,044	1,200	0,35	0,60	600
74454247	470,0	± 10	1,350	1,600	0,30	0,50	600
74454268	680,0	± 10	1,940	2,300	0,26	0,40	600
7445430	1000,0	± 10	2,750	3,200	0,22	0,35	600

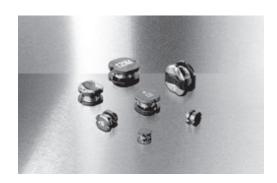
Χ

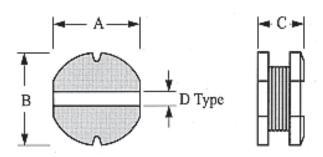
^							
Наимено- вание	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
74459010	10,0	± 20	0,023	0,040	3,90	8,00	300
74459115	15,0	± 20	0,030	0,048	3,50	7,00	300
74459122	22,0	± 20	0,048	0,059	3,40	6,00	300
74459133	33,0	± 20	0,071	0,075	2,90	5,00	300
74459147	47,0	± 20	0,085	0,097	2,80	4,00	300
74459168	68,0	± 20	0,105	0,138	2,20	3,00	300
7445920	100,0	± 20	0,151	0,207	1,70	2,40	300

серия WE-PD3 (продолжение)

Наимено- вание	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
74459215	150,0	± 20	0,209	0,293	1,30	2,10	300
74459222	220,0	± 20	0,311	0,470	1,20	1,90	300
74459233	330,0	± 20	0,457	0,780	0,90	1,10	300
74459247	470,0	± 20	0,661	1,080	0,80	1,10	300
74459268	680,0	± 20	1,059	1,400	0,70	0,96	300
7445930	1000,0	± 20	1,427	2,010	0,60	0,80	300

серия WE-PD2





Тип	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)
Typ MS	5,2	5,8	2,0	2,0
Typ S	4,0	4,5	3,2	1,0
Тур М	5,2	5,8	4,5	2,0
Typ L	7,0	7,8	5,0	3,0
Typ XL	9,0	10,0	5,4	3,5

MS

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
74477450012	0,12	± 20	2,50	3,50	10,0	14,0	2000
74477450027	0,27	± 20	4,40	5,30	8,20	9,50	2000
74477450056	0,56	± 20	7,80	9,50	6,50	6,50	2000
74477450082	0,82	± 20	12,0	14,0	5,40	5,80	2000
7447745012	1,20	± 20	17,0	21,0	4,80	4,60	2000
7447745017	1,70	± 20	23,0	27,0	4,00	3,60	2000
7447745022	2,20	± 20	30,0	36,0	3,60	3,50	2000
7447745033	3,30	± 20	41,0	49,0	3,00	3,00	2000
7447745039	3,90	± 20	47,0	54,0	2,80	2,60	2000
7447745047	4,70	± 20	57,0	65,0	2,50	2,40	2000
7447745056	5,60	± 20	70,0	78,0	2,30	2,10	2000
7447745062	6,20	± 20	80,0	90,0	2,10	2,00	2000
7447745076	7,60	± 20	95,0	105,0	1,90	1,80	2000
7447745100	10,0	± 20	120,0	130,0	1,70	1,60	2000
7447745330	33,0	± 20	480,0	520,0	0,90	0,90	2000

S

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7447730	1,0	± 20	14,00	49,00	4,00	5,72	1500
744773014	1,4	± 20	22,00	56,00	3,40	5,04	1500
744773018	1,8	± 20	28,00	64,00	2,70	3,60	1500
744773022	2,2	± 20	34,00	71,00	2,50	3,38	1500
744773027	2,7	± 20	39,00	79,00	2,25	2,97	1500
744773033	3,3	± 20	41,00	86,00	2,00	2,88	1500
744773039	3,9	± 20	54,00	94,00	1,88	2,57	1500
744773047	4,7	± 20	59,00	110,00	1,82	2,46	1500
744773056	5,6	± 20	69,00	126,00	1,58	2,43	1500
744773068	6,8	± 20	76,00	131,00	1,54	2,10	1500

серия WE-PD2 (продолжение)

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
744773082	8,2	± 20	116,00	146,00	1,50	1,80	1500
74477310	10,0	± 20	118,00	182,00	1,45	1,74	1500
744773112	12,0	± 20	156,00	210,00	1,28	1,62	1500
744773115	15,0	± 20	204,00	235,00	1,20	1,46	1500
744773118	18,0	± 20	225,00	338,00	1,10	1,29	1500
744773122	22,0	± 20	261,00	370,00	1,00	1,22	1500
744773127	27,0	± 20	328,00	522,00	0,94	1,00	1500
744773133	33,0	± 10	370,00	540,00	0,86	0,90	1500
744773139	39,0	± 10	418,00	587,00	0,77	0,87	1500
744773147	47,0	± 10	523,00	844,00	0,68	0,77	1500
744773156	56,0	± 10	714,00	937,00	0,64	0,75	1500
744773168	68,0	± 10	754,00	1117,00	0,56	0,68	1500

М

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
744774022	2,2	± 20	26,00	41,00	4,60	8,20	1500
744774027	2,7	± 20	32,00	45,00	4,00	8,00	1500
744774047	4,7	± 20	56,00	71,00	3,00	5,50	1500
744774068	6,8	± 20	71,00	82,00	2,40	5,00	1500
74477410	10,0	± 20	78,00	100,00	2,20	2,16	1500
744774112	12,0	± 20	82,00	110,00	2,00	1,94	1500
744774115	15,0	± 20	89,00	140,00	1,53	1,90	1500
744774118	18,0	± 20	104,00	150,00	1,45	1,69	1500
744774122	22,0	± 20	109,00	180,00	1,28	1,53	1500
744774127	27,0	± 20	133,00	200,00	1,19	1,40	1500
744774133	33,0	± 15	150,00	230,00	1,09	1,17	1500
744774139	39,0	± 15	215,00	320,00	0,94	1,10	1500
744774147	47,0	± 15	260,00	370,00	0,86	1,00	1500
744774156	56,0	± 10	298,00	420,00	0,77	0,90	1500
744774168	68,0	± 10	313,00	460,00	0,64	0,86	1500
744774182	82,0	± 10	475,00	600,00	0,60	0,72	1500
74477420	100,0	± 10	510,00	650,00	0,57	0,68	1500
744774212	120,0	± 10	660,00	930,00	0,49	0,63	1500
744774215	150,0	± 10	720,00	1100,00	0,46	0,54	1500
744774218	180,0	± 10	850,00	1380,00	0,42	0,50	1500
744774222	220,0	± 10	945,00	1570,00	0,42	0,47	1500

L

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
74477510	10,0	± 10	44,00	70,00	2,30	2,95	500
744775112	12,0	± 10	42,00	80,00	2,18	2,20	500
744775115	15,0	± 10	44,00	90,00	1,93	2,23	500
744775118	18,0	± 10	53,00	100,00	1,89	2,14	500
744775122	22,0	± 10	65,00	110,00	1,76	1,81	500
744775127	27,0	± 10	74,00	120,00	1,48	1,62	500
744775133	33,0	± 10	88,00	130,00	1,35	1,47	500
744775139	39,0	± 10	116,00	160,00	1,25	1,33	500
744775147	47,0	± 10	134,00	180,00	1,17	1,24	500
744775156	56,0	± 10	189,00	240,00	1,04	1,14	500
744775168	68,0	± 10	218,00	280,00	0,99	1,05	500
744775182	82,0	± 10	248,00	370,00	0,90	0,95	500
74477520	100,0	± 10	208,00	430,00	0,77	0,86	500
744775210	120,0	± 10	308,00	470,00	0,67	0,81	500
744775215	150,0	± 10	467,00	640,00	0,60	0,71	500
744775218	180,0	± 10	574,00	710,00	0,55	0,57	500
744775222	220,0	± 10	614,00	960,00	0,51	0,56	500
744775227	270,0	± 10	699,00	1110,00	0,47	0,51	500
744775233	330,0	± 10	810,00	1260,00	0,43	0,48	500
744775239	390,0	± 10	1151,00	1770,00	0,38	0,43	500
744775247	470,0	± 10	1370,00	1960,00	0,36	0,38	500

серия WE-PD2 (продолжение)

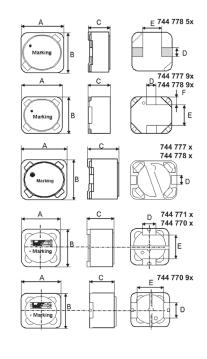
XL

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
74477610	10,0	± 20	28,00	60,00	2,98	3,24	500
744776112	12,0	± 20	33,00	70,00	2,72	3,15	500
744776115	15,0	± 20	34,00	80,00	2,47	2,88	500
744776118	18,0	± 20	43,00	90,00	2,36	2,43	500
744776122	22,0	± 20	51,00	100,00	2,04	2,07	500
744776127	27,0	± 20	63,00	110,00	1,95	1,98	500
744776133	33,0	± 20	83,00	120,00	1,78	1,89	500
744776139	39,0	± 20	98,00	140,00	1,62	1,80	500
744776147	47,0	± 10	95,00	170,00	1,45	1,62	500
744776156	56,0	± 10	112,00	190,00	1,36	1,53	500
744776168	68,0	± 10	138,00	220,00	1,19	1,49	500
744776182	82,0	± 10	150,00	250,00	1,11	1,17	500
74477620	100,0	± 10	200,00	350,00	1,02	1,10	500
744776212	120,0	± 10	243,00	400,00	0,94	0,99	500
744776215	150,0	± 10	300,00	470,00	0,81	0,90	500
744776218	180,0	± 10	320,00	630,00	0,76	0,78	500
744776222	220,0	± 10	451,00	730,00	0,67	0,77	500
744776227	270,0	± 10	500,00	970,00	0,62	0,68	500
744776233	330,0	± 10	750,00	1150,00	0,52	0,59	500
744776239	390,0	± 10	794,00	1300,00	0,49	0,54	500
744776247	470,0	± 10	969,00	1480,00	0,44	0,50	500
744776256	560,0	± 10	1047,00	1900,00	0,39	0,47	500
744776268	680,0	± 10	1245,00	2250,00	0,36	0,43	500
744776282	820,0	± 10	1420,00	2550,00	0,32	0,41	500

серия WE-PD



Тип	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)	Е (мм)	
XS	5,9	6,2	3,3	1,5	2,8	-
S (new)	7,3	7,3	3,2	1,5	4,0	1,5
M (new)	7,3	7,3	4,5	1,5	4,0	1,5
S	7,3	7,3	3,2	2,0	-	-
М	7,3	7,3	4,5	2,0	-	-
L	12,0	12,0	6,0	5,0	8,0	-
XL	12,0	12,0	8,0	5,0	8,0	-
XXL	12,0	12,0	10,0	5,0	7,6	-



XS

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7447785001	1,0	± 25	31,00	39,00	3,50	4,50	500
7447785002	2,2	± 25	43,00	54,00	2,90	3,30	500
7447785004	4,7	± 25	60,00	78,00	2,20	2,50	500
744778510	10,0	± 25	100,00	125,00	1,90	1,60	500
7447785122	22,0	± 25	210,00	250,00	1,35	1,10	500
7447785147	47,0	± 25	500,00	600,00	0,85	0,74	500
744778520	100,0	± 25	950,00	1060,00	0,65	0,50	50

серия WE-PD (продолжение)

S

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7447789001	1,0	± 20	10,00	12,00	5,37	6,40	1000
7447789002	2,2	± 20	19,00	20,00	4,02	4,80	1000
7447789003	3,3	± 20	24,00	30,00	3,42	4,20	1000
7447789004	4,7	± 20	33,00	35,00	2,90	3,90	1000
7447789006	6,8	± 20	44,00	44,00	2,50	2,75	1000
744778910	10,0	± 20	64,00	72,00	1,83	2,20	1000
7447789112	12,0	± 20	76,00	98,00	1,73	1,90	1000
7447789115	15,0	± 20	100,00	130,00	1,51	1,75	1000
7447789118	18,0	± 20	114,00	140,00	1,41	1,70	1000
7447789122	22,0	± 20	119,00	190,00	1,38	1,40	1000
7447789127	27,0	± 20	130,00	210,00	1,27	1,35	1000
7447789133	33,0	± 20	153,00	240,00	1,22	1,15	1000
7447789139	39,0	± 20	209,00	320,00	1,03	1,10	1000
7447789147	47,0	± 20	315,00	360,00	0,85	1,00	1000
7447789156	56,0	± 20	335,00	470,00	0,84	0,90	1000
7447789168	68,0	± 20	427,00	520,00	0,74	0,84	1000
7447789182	82,0	± 20	470,00	690,00	0,69	0,78	1000
744778920	100,0	± 20	585,00	790,00	0,62	0,76	1000
7447789212	120,0	± 20	563,00	890,00	0,60	0,68	1000
7447789215	150,0	± 20	720,00	1270,00	0,56	0,53	1000
7447789218	180,0	± 20	960,00	1450,00	0,49	0,50	1000
7447789222	220,0	± 20	1350,00	1650,00	0,43	0,42	1000
7447789270	270,0	± 20	1470,00	2310,00	0,40	0,39	1000
7447789233	330,0	± 20	2280,00	2620,00	0,32	0,35	1000
7447789239	390,0	± 20	2490,00	2940,00	0,30	0,34	1000
744778924	470,0	± 20	2600,00	4180,00	0,30	0,31	1000
744778925	560,0	± 20	3000,00	4670,00	0,27	0,30	1000
744778926	680,0	± 20	4500,00	5730,00	0,22	0,22	1000
744778928	820,0	± 20	4990,00	6540,00	0,21	0,20	1000
744778930	1000,0	± 20	5570,00	9440,00	0,20	0,18	1000

М

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7447779001	1,0	± 20	10,00	11,00	5,30	9,50	1000
74477790015	1,5	± 20	15,00	18,00	4,30	7,30	1000
7447779002	2,2	± 20	16,00	20,00	4,20	6,00	1000
7447779003	3,3	± 20	26,00	30,00	3,30	4,50	1000
7447779004	4,7	± 20	28,00	32,00	3,16	4,40	1000
7447779006	6,8	± 20	33,00	35,00	2,91	3,30	1000
744777910	10,0	± 20	45,00	49,00	2,00	2,60	1000
7447779112	12,0	± 20	50,00	58,00	1,82	2,40	1000
7447779115	15,0	± 20	70,00	81,00	1,60	2,20	1000
7447779118	18,0	± 20	80,00	91,00	1,50	2,05	1000
7447779122	22,0	± 20	90,00	110,00	1,41	1,70	1000
7447779127	27,0	± 20	120,00	150,00	1,24	1,55	1000
7447779133	33,0	± 20	140,00	170,00	1,13	1,40	1000
7447779139	39,0	± 20	145,00	230,00	1,11	1,23	1000
7447779147	47,0	± 20	190,00	260,00	1,03	1,10	1000
7447779156	56,0	± 20	228,00	350,00	0,93	1,05	1000
7447779168	68,0	± 20	239,00	380,00	0,87	0,95	1000
7447779182	82,0	± 20	250,00	430,00	0,84	0,90	1000
744777920	100,0	± 20	290,00	610,00	0,79	0,75	1000
7447779212	120,0	± 20	396,00	660,00	0,67	0,70	1000
7447779215	150,0	± 20	529,00	880,00	0,52	0,63	1000
7447779218	180,0	± 20	603,00	980,00	0,51	0,56	1000
7447779222	220,0	± 20	920,00	1170,00	0,44	0,54	1000
7447779270	270,0	± 20	1090,00	1640,00	0,43	0,48	1000
7447779233	330,0	± 20	1150,00	1860,00	0,39	0,45	1000
7447779239	390,0	± 20	1400,00	2850,00	0,38	0,42	1000

серия WE-PD (продолжение)

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
744777924	470,0	± 20	1600,00	3010,00	0,29	0,34	1000
744777925	560,0	± 20	1720,00	3620,00	0,28	0,31	1000
744777926	680,0	± 20	2600,00	4630,00	0,23	0,28	1000
744777928	820,0	± 20	2960,00	5200,00	0,21	0,26	1000
744777930	1000,0	± 20	3270,00	6000,00	0,20	0,25	1000

S

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
744778001	1,0	± 20	9,00	12,00	5,37	6,40	1000
744778002	2,2	± 20	14,00	20,00	4,02	4,80	1000
744778004	4,7	± 20	42,00	60,00	2,32	4,20	1000
74477810	10,0	± 20	68,00	72,00	1,83	2,20	1000
744778112	12,0	± 20	76,00	98.00	1,73	2,15	1000
744778115	15,0	± 20	100,00	130,00	1,51	1,75	1000
744778118	18,0	± 20	114,00	140,00	1,41	1,70	1000
744778122	22,0	± 20	119,00	190,00	1,38	1,40	1000
744778127	27,0	± 20	140,00	210,00	1,27	1,30	1000
744778133	33,0	± 20	153,00	240,00	1,22	1,15	1000
744778139	39,0	± 20	214,00	320,00	1,03	1,10	1000
744778147	47,0	± 20	315,00	360,00	0,85	1,00	1000
744778156	56,0	± 20	322,00	470,00	0,84	0,88	1000
744778168	68,0	± 20	417,00	520,00	0,74	0,84	1000
744778182	82,0	± 20	479,00	690,00	0,69	0,78	1000
74477820	100,0	± 20	585,00	790,00	0,62	0,76	1000
744778212	120,0	± 20	634,00	890,00	0,60	0,68	1000
744778215	150,0	± 20	720,00	1270,00	0,56	0,53	1000
744778218	180,0	± 20	960,00	1450,00	0,49	0,50	1000
744778222	220,0	± 20	1220,00	1650,00	0,43	0,42	1000
744778270	270,0	± 20	1440,00	2310,00	0,40	0,39	1000
744778233	330,0	± 20	2280,00	2620,00	0,32	0,35	1000
744778239	390,0	± 20	2490,00	2940,00	0,30	0,34	1000
74477824	470,0	± 20	2600,00	4180,00	0,30	0,31	1000
74477825	560,0	± 20	3000,00	4670,00	0,27	0,30	1000
74477826	680,0	± 20	4500,00	5730,00	0,22	0,22	1000
74477828	820,0	± 20	5070,00	6500,00	0,21	0,20	1000
74477830	1000,0	± 20	5570,00	9440,00	0,20	0,18	1000

М

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
744777001	1,00	+40 /-20	8,40	10,00	8,00	9,00	1000
744777002	2,20	± 20	13,00	20,00	6,00	6,50	1000
744777003	3,30	± 20	25,00	30,00	5,00	4,60	1000
744777004	4,70	± 20	40,00	25,00	4,00	4,00	1000
74477710	10,0	± 20	45,00	49,00	2,00	2,60	1000
744777112	12,0	± 20	54,00	58,00	1,82	2,40	1000
744777115	15,0	± 20	70,00	81,00	1,60	2,20	1000
744777118	18,0	± 20	80,00	91,00	1,50	2,05	1000
744777122	22,0	± 20	90,00	110,00	1,41	1,70	1000
744777127	27,0	± 20	117,20	150,00	1,24	1,55	1000
744777133	33,0	± 20	140,00	170,00	1,13	1,40	1000
744777139	39,0	± 20	145,00	230,00	1,11	1,23	1000
744777147	47,0	± 20	170,00	260,00	1,03	1,10	1000
744777156	56,0	± 20	207,00	350,00	0,93	1,05	1000
744777168	68,0	± 20	239,00	380,00	0,87	0,95	1000
744777182	82,0	± 20	257,00	430,00	0,84	0,90	1000
74477720	100,0	± 20	290,00	610,00	0,79	0,75	1000
744777212	120,0	± 20	400,00	660,00	0,67	0,70	1000
744777215	150,0	± 20	660,00	880,00	0,52	0,63	1000
744777218	180,0	± 20	680,00	980,00	0,51	0,56	1000

серия WE-PD (продолжение)

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
744777222	220,0	± 20	920,00	1170,00	0,44	0,54	1000
744777270	270,0	± 20	970,00	1640,00	0,43	0,48	1000
744777233	330,0	± 20	1150,00	1860,00	0,39	0,45	1000
744777239	390,0	± 20	1250,00	2850,00	0,38	0,42	1000
74477724	470,0	± 20	1600,00	3010,00	0,29	0,34	1000
74477725	560,0	± 20	1720,00	3620,00	0,28	0,31	1000
74477726	680,0	± 20	2600,00	4630,00	0,23	0,28	1000
74477728	820,0	± 20	3000,00	5200,00	0,21	0,26	1000
74477730	1000,0	± 20	3270,00	6000,00	0,20	0,25	1000

ı

Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
744771001	1,50	± 20	4,00	6,00	10,50	11,50	500
744771002	2,20	± 20	5,00	8,00	10,00	11,00	500
744771003	3,50	± 20	5,00	8,00	9,25	9,00	500
744771004	4,70	± 20	8,00	11,00	8,25	8,00	500
744771008	8,20	± 20	14,00	20,00	6,25	6,25	500
74477110	10,0	± 20	21,00	25,00	4,09	5,60	500
744771112	12,0	± 20	23,00	27,00	3,91	4,85	500
744771115	15,0	± 20	25,00	30,00	3,75	4,55	500
744771118	18,0	± 20	29,00	34,00	3,48	4,30	500
744771122	22,0	± 20	31,00	36,00	3,37	3,77	500
744771127	27,0	± 20	40,00	51,00	2,97	3,55	500
744771133	33,0	± 20	49,00	57,00	2,68	3,00	500
744771139	39,0	± 20	57,00	68,00	2,49	2,74	500
744771147	47,0	± 20	72,00	75,00	2,21	2,60	500
744771156	56,0	± 20	87,00	110,00	2,01	2,35	500
744771168	68,0	± 20	96,00	120,00	1,91	2,19	500
744771182	82,0	± 20	129,00	140,00	1,65	1,88	500
74477120	100,0	± 20	150,00	160,00	1,53	1,70	500
744771212	120,0	± 20	159,00	170,00	1,30	1,56	500
744771215	150,0	± 20	185,00	230,00	1,21	1,43	500
744771218	180,0	± 20	242,00	290,00	1,06	1,24	500
744771220	220,0	± 20	290,00	400,00	0,96	1,20	500
744771270	270,0	± 20	338,00	460,00	0,89	1,00	500
744771233	330,0	± 20	442,00	510,00	0,78	0,97	500
744771239	390,0	± 20	590,00	690,00	0,68	0,85	500
74477124	470,0	± 20	660,00	770,00	0,64	0,80	500
74477125	560,0	± 20	690,00	860,00	0,62	0,70	500
74477126	680,0	± 20	880,00	1200,00	0,55	0,68	500
74477128	820,0	± 20	1025,00	1340,00	0,51	0,60	500
74477130	1000,0	± 20	1430,00	1530,00	0,43	0,50	500

серия WE-PD (продолжение)

XL

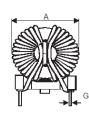
Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
74477009	0,47	+20/-25	2,90	3,00	23,50	26,40	500
74477001	1,2	+40/-20	5,00	7,00	12,00	16,60	500
74477002	2,4	+40/-20	9,00	12,00	10,10	14,30	500
74477003	3,5	+40/-20	11,00	14,00	8,90	9,60	500
74477004	4,7	+40/-20	12,00	16,00	8,50	9,30	500
74477006	6,1	+40/-20	15,00	18,00	7,60	8,60	500
74477007	7,6	+40/-20	16,00	20,00	7,40	8,00	500
74477010	10,0	± 20	19,00	22,00	6,20	6,60	500
744770112	12,0	± 20	21,00	24,00	5,90	6,30	500
744770115	15,0	± 20	24,00	27,00	5,00	6,00	500
744770118	18,0	± 20	32,00	39,00	4,20	5,40	500
744770122	22,0	± 20	33,00	43,00	4,10	5,00	500
744770127	27,0	± 20	35,00	46,00	3,70	3,80	500
744770133	33,0	± 20	47,00	64,00	3,20	3,60	500
744770139	39,0	± 20	53,00	72,90	3,00	3,50	500
744770147	47,0	± 20	76,00	100,00	2,70	3,00	500
744770156	56,0	± 20	85,00	110,00	2,40	2,90	500
744770168	68,0	± 20	90,00	140,00	2,30	2,50	500
74477020	100,0	± 20	102,00	220,00	2,20	2,40	500
744770222	220,0	± 20	247,00	390,00	1,30	1,49	500
744770233	330,0	± 20	349,00	640,00	1,10	1,10	500
744770247	470,0	± 20	496,00	980,00	0,90	0,90	500
744770256	560,0	± 20	593,00	1070,00	0,80	0,90	500
744770268	680,0	± 20	840,00	1460,00	0,70	0,80	500
744770282	820,0	± 20	936,00	1640,00	0,60	0,80	500
74477030	1000,0	± 20	1040,00	1820,00	0,60	0,70	500

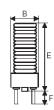
XXL

XXL							
Наименова- ние	Индуктивность, мкГн	Точность, %	Сопротивление типовое, Ом	Сопротивление макс., Ом	Номинальный ток, А	Ток насыщения, А	Кол-во в упаковке
7447709001	1,0	± 20	3,86	5,60	13,00	25,00	250
7447709002	2,2	± 20	4,94	6,00	11,50	20,00	250
7447709003	3,5	± 20	5,90	8,50	11,00	16,50	250
7447709004	4,7	± 20	7,42	11,00	9,30	13,00	250
7447709006	6,8	± 20	9,10	14,00	8,40	12,80	250
7447709100	10,0	± 20	12,94	21,00	7,10	10,50	250
7447709150	15,0	± 20	20,75	26,00	6,50	8,00	250
7447709220	22,0	± 20	23,30	28,00	5,30	6,50	250
7447709330	33,0	± 20	36,80	45,00	4,20	5,50	250
7447709470	47,0	± 20	45,93	60,00	3,80	4,50	250
7447709680	68,0	± 20	68,64	88,50	3,20	3,60	250
7447709101	100,0	± 20	100,00	110,00	2,50	3,10	250
7447709151	150,0	± 20	151,00	200,00	2,10	2,70	250
7447709221	220,0	± 20	193,00	300,00	1,80	2,20	250
7447709271	270,0	± 20	248,00	330,00	1,60	2,10	250
7447709331	330,0	± 20	363,00	430,00	1,50	1,70	250
7447709471	470,0	± 20	437,00	560,00	1,40	1,50	250

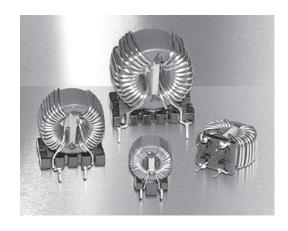
Дроссели для подавления помех Wurth Elektronik

Тип	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)	Е (мм)	F (мм)	G (мм)
XS	15,0	7,5	10,0	4,5	18,0	2,5	0,7
S	17,5	13,0	7,7	5,0	22,0	3,0	0,7
М	23,0	17,0	7,5	10,7	28,0	3,0	0,7
L	27,5	18,5	10,0	12,0	33,0	5,0	1,0
XL	30,0	21,0	25,0	15,0	35,0	5,0	1,0





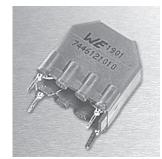


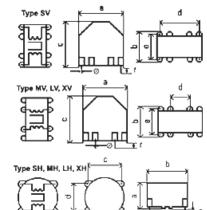


Наименование	Индуктивность, мГн	Сопротивление по постоянному току, мОм	Допустимый ток, А						
		XS							
744821201	1,0	45	2,0						
744821240	4,0	140	1,5						
744821150	5,0	200	1,0						
744821110	10,0	350	0,7						
744821120	20,0	1000	0,5						
744821039	39,0	3000	0,3						
		S							
744822301	1,0	35	3,0						
744822222	2,2	70	2,0						
744822233	3,3	120	1,5						
744822110	10,0	360	1,0						
744822120	20,0	540	0,5						
	M								
744823601	1,0	10	6,0						
744823422	2,2	30	4,0						
744823333	3,3	60	2,5						
744823305	5,0	95	2,5						
744823210	10,0	125	2,0						
744823220	20,0	270	1,5						
		L							
744824101	1,0	7	10,0						
744824622	2,2	20	6,0						
744824433	3,3	35	4,0						
744824405	5,0	50	4,0						
744824407	7,0	80	3,5						
744824310	10,0	105	3,0						
744824220	20,0	220	2,0						
	'	XL							
7448251201	1,0	9	12,0						
7448258022	2,2	14	8,0						
7448256033	3,3	25	6,0						
744825605	5,0	45	6,0						
744825510	10,0	55	5,0						
744825320	20,0	160	3,0						

Дроссели для подавления помех Wurth Elektronik (продолжение)

Тип	А (мм)	В (мм)	С (мм)	D (мм)	Е (мм)	
612 / SV	18,5	13,5	20,5	15,5	10,0	0,6
622 / MV	23,5	16,0	25,5	10,0	12,5	0,6
632 / LV	26,5	18,5	30,5	12,5	15,0	0,6
662 / SH	13,0	18,0	15,0	10,0	-	0,6
672 / MH	14,5	23,0	20,0	12,5	-	0,6
682 / LH	17,0	28,5	25,2	15,1	-	0,6
692 / XH	20,0	33,0	30,2	20,1	-	0,8
642 / XV	32,5	21,5	35,5	12,5	17,5	0,8





Наименование	Индуктивность, мГн	Допустимый ток, А	Сопротивление по постоянному току, мОм						
	612	/ SV							
74461240004	0,4	3,6	0,02						
7446122001	1,0	2,0	0,06						
7446122003	3,3	1,5	0,15						
7446121007	6,8	1,0	0,30						
7446121010	10,0	0,7	0,55						
7446120027	27,0	0,4	1,20						
7446120039	39,0	0,4	1,70						
7446120047	47,0	0,3	2,60						
	622 / MV								
74462250007	0,7	4,7	0,02						
7446223001	1,0	3,0	0,04						
7446222002	2,2	2,0	0,06						
7446222004	4,2	2,0	0,12						
7446221010	10,0	1,3	0,25						
7446221012	12,0	1,2	0,28						
7446221027	27,0	0,6	0,70						
7446220047	47,0	0,4	1,60						
	632	/ LV							
7446326002	1,8	6,0	0,023						
7446323003	2,7	3,0	0,060						
7446323004	4,0	3,0	0,070						
7446322007	6,8	1,9	0,160						
7446322010	10,0	1,9	0,180						
7446321027	27,0	1,0	0,640						
7446321033	33,0	0,8	0,850						
7446321050	50,0	0,6	1,200						

	662 / SH								
74466240007	0,7	4,0	0,027						
7446622001	1,0	2,0	0,060						
7446622002	2,2	2,0	0,095						
7446622003	3,3	1,5	0,150						
7446621007	6,8	1,0	0,300						
7446621010	10,0	0,7	0,550						
7446620015	15,0	0,5	0,830						
7446620027	27,0	0,4	1,200						
7446620039	39,0	0,4	1,700						
	672	/ MH							
7446723001	1,2	3,0	0,04						
7446722002	2,2	2,0	0,06						
7446722004	4,2	1,9	0,12						
7446721010	10,0	1,3	0,25						

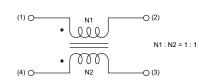
Дроссели для подавления помех Wurth Elektronik (продолжение)

Наименование	Индуктивность, мГн	Допустимый ток, А	Сопротивление по постоянному току, мОм			
7446721027	27,0	0,6	0,70			
7446720047	47,0	0,4	1,60			
	682	/ LH				
7446823003	2,7	3,0	0,06			
7446823006	5,6	2,4	0,10			
7446822006	5,6	2,0	0,16			
7446821027	27,0	1,0	0,64			
	692	/ XH				
7446926002	1,8	6,0	0,030			
7446924003	3,3	4,0	0,065			
7446921027	27,0	1,2	0,400			
	642 / XV					
7446424002	2,2	4,3	0,038			
7446424003	3,3	4,0	0,065			
7446422007	6,8	2,5	0,120			

Дроссели для подавления помех Murata

Мигата также выпускает помехоподавляющие фильтры для подавления помех импульсных источников питания — серии PLA10, PLY10, PLY17. Серии PLY10 и PLY17 обладают повышенной индуктивностью рассеяния, что позволяет эффективно подавлять дифференциальную составляющую помехи.

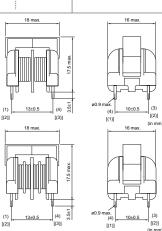
Наименование продукта	Исполнение	Диапазон подавления помех	Применение
	PLA10 FK0B	10x 100x 1M 10M 100M 1G	Подавление синфазных помех в диапазоне до 10МГц
	PLH10		Подавление синфазных помех в диапазоне до 100МГц
	PLY10		Подавление синфазной и дифференциальной помехи до 10МГц
	PLY17		Подавление синфазной и дифференциальной помехи в широком диапазоне частот





тандартный тип намотки





Дроссели для подавления помех Murata (продолжение)

Стандартный тип намотки

Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLA10AN1522R0R2	1,5	2,0	300	100
PLA10AN1321R7R2	1,8	1,7	300	100
PLA10AN2221RSR2	2,2	1,5	300	100
PLA10AN3021R3R2	3,0	1,3	300	100
PLA10AN3521R2R2	3,5	1,2	300	100
PLA10AN5521R0R2	5,5	1,0	300	100
PLA10AN7420R3R2	7,4	0,8	300	100
PLA10AN1030R7R2	10,0	0,7	300	100
PLA10AN1230R6R2	12,0	0,6	300	100
PLA10AN2030R5R2	20,0	0,5	300	100
PLA10AN3030R4R2	30,0	0,4	300	100
PLA10AN4330R3R2	43,0	0,3	300	100

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

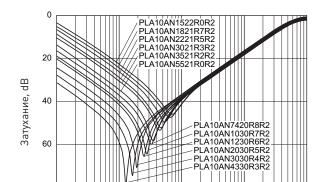
Секционная намотка

Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLA10AN9012R0D2	0,9	2,0	300	100
PLA10AN1321R7D2	1,3	1,7	300	100
PLA10AN1S21R5D2	1,3	1,5	300	100
PLA10AN2021R3D2	2,0	1,3	300	100
PLA10AN3621R0D2	3,6	1,0	300	100
PLA10AN7720R7D2	7,7	0,7	300	100
PLA10AN1330R5D2	13,0	0,5	300	100
PLA10AN2230R4D2	22,0	0,4	300	100
PLA10AN3630R3D2	36,0	0,3	300	100

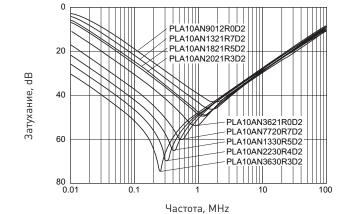
Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Стандартный тип намотки

Характеристики помех подавления



Частота, МНz



Секционная намотка

Дроссели для подавления помех Murata (продолжение)

Стандартный тип намотки

••• 1				
Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLA10AS1522R0R2	1,5	2,0	250	100
PLA10AS1321R7R2	1,8	1,7	250	100
PLA10AS2221R6R2	2,2	1,5	250	100
PLA10AS3021R3R2	3,0	1,3	250	100
PLA10AS3521R2R2	3,5	1,2	250	100
PLA10AS5521R0R2	5,5	1,0	250	100
PLA10AS7420R8R2	7,4	0,8	250	100
PLA10AS1030R7R2	10,0	0,7	250	100
PLA10AS123QR6R2	12,0	0,6	250	100
PLA10AS2030R5R2	20,0	0,5	250	100
PLA10AS3030R4R2	30,0	0,4	250	100
PLA10AS4330R3R2	43,0	0,3	250	100

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °С. Допустимый перегрев обмоток: 60 °С (при номинальном токе).

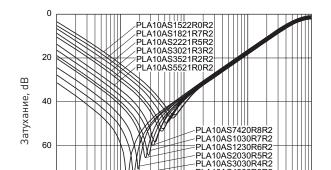
Секционная намотка

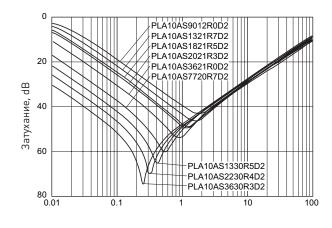
Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLA10AS9012R0D2	0,9	2,0	250	100
PLA10AS1321R7D2	1,3	1,7	250	100
PLA10AS1821RSD2	1,8	1,5	250	100
PLA10AS2021R3D2	2,0	1,3	250	100
PLA10AS3621R0D2	3,6	1,0	250	100
PLA10AS7720R7D2	7,7	0,7	250	100
PLA10AS1330RSD2	13,0	0,5	250	100
PLA10AS2230R4D2	22,0	0,4	250	100
PLA10AS3630R3D2	36,0	0,3	250	100

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Стандартный тип намотки

Характеристики помех подавления



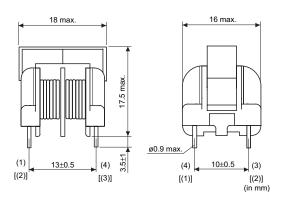


Секционная намотка

Частота, MHz Частота, MHz

Дроссели для подавления помех Murata (продолжение)





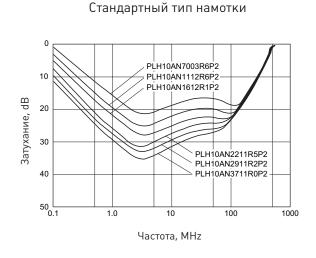
Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLH10AN7Q03R6P2	70	3,6	300	100
PLH10AN1112R6P2	110	2,6	300	100
PLH10AN1S12R1P2	160	2,1	300	100
PLH10AN2211R5P2	220	1,5	300	100
PLH10AN2911R2P2	290	1,2	300	100
PLH10AN3711R0P2	370	1,0	300	100

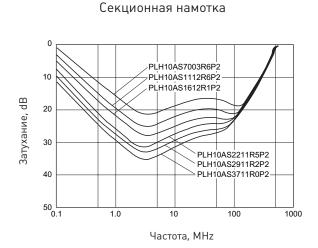
Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLH10AS7003R6P2	70	3,6	250	100
PLH10AS1112R6P2	110	2,6	250	100
PLH10AS1612R1P2	160	2,1	250	100
PLH10AS2211R5P2	220	1,5	250	100
PLH10AS2911R2P2	290	1,2	250	100
PLH10AS3711R0P2	370	1,0	250	100

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Характеристики помех подавления





Дроссели для подавления помех Murata (продолжение)



Стандартный тип намотки

Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLY10AN9012R0R2	0,9	65	2,0	300
PLY10AN1121R8R2	1,1	90	1,8	300
PLY10AN1521R6R2	1,5	110	1,6	300
PLY10AN2121R4R2	2,1	150	1,4	300
PLY1QAN2821R2R2	2,8	190	1,2	300
PLY10AN4321R0R2	4,3	300	1,0	300
PLY10AN6220R8R2	6,2	400	0,8	300
PLY10AN8720R7R2	3,7	530	0,7	300
PLY10AN9920R6R2	9,9	690	0,6	300
PLY10ANU30R5R2	14,0	1000	0,5	300

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Секционная намотка

Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLY10AN7012R0D2	0,7	50	2,0	300
PLY10AN1121R7D2	1,1	65	1,7	300
PLY10ANU21R4D2	1,4	110	1,4	300
PLY10AN2321R2D2	2,3	160	1,2	300
PLY10AN3521R0D2	3,5	240	1,0	300
PLY10AN4420R8D2	4,4	320	0,8	300
PLY10AN8720R7D2	8,7	500	0,7	300
PLY10AN9720R6D2	9,7	670	0,6	300
PLY10AN1130R5D2	11,0	640	0,5	300
PLY10AN2430R4D2	24,0	1800	0,4	300

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Стандартный тип намотки

Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLY10AS9012R0R2	0,9	65	2,0	300
PLY10AS1121R8R2	1,1	90	1,8	300
PLY10AS1521R6R2	1,5	110	1,6	300
PLY10AS2121R4R2	2,1	150	1,4	300
PLY10AS2821R2R2	2,8	190	1,2	300
PLY10AS4321R0R2	4,3	300	1,0	300
PLY10AS6220R8R2	6,2	400	0,8	300
PLY10AS8720R7R2	8,7	530	0,7	300
PLY10AS9920R6R2	9,9	690	0,6	300
PLY10AS1430R5R2	14,0	1000	0,5	300

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °С. Допустимый перегрев обмоток: 60 °С (при номинальном токе).

Дроссели для подавления помех Murata (продолжение)

Секционная намотка

Наименование	Мин. индуктивность обмотки, мГн	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм
PLY10AS7012R0D2	0,7	50	2,0	300
PLY10AS1121R7D2	1,1	65	1,7	300
PLY10AS1421R4D2	1,4	110	1,4	300
PLY10AS2321R2D2	2,3	160	1,2	300
PLY10AS3521R0D2	3,5	240	1,0	300
PLY10AS4420R8D2	4,4	320	0,8	300
PLY10AS8720R7D2	8,7	500	0,7	300
PLY10AS9720R6D2	9,7	670	0,6	300
PLY10AS1130R5D2	11,0	840	0,5	300
PLY10AS2430R4D2	24,0	1800	0,4	300

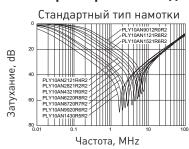
Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

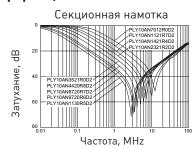
Характеристика подавления синфазной помехи



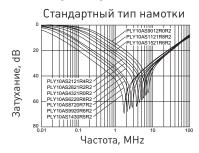


Характеристика подавления дифференциальной помехи





Характеристика подавления дифференциальной помехи





Характеристика подавления синфазной помехи



Дроссели для подавления помех Murata (продолжение)



Тип А

Наименование	Индуктивность обмотки, мГн	Дифференц. индуктивность	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В~
PLY17BN4912R4A2	0,49	18	2,4	300
PLY17BN9612R0A2	0,96	36	2,0	300
PLY17BN1023R0A2	1,0	36	3,0	300
PLY17BN1121R8A2	1,1	44	1,8	300
PLY17BN1721RSA2	1,7	67	1,5	300
PLY17BN2921R2A2	2,9	110	1,2	300
PLY17BN3721R0A2	3,7	140	1,0	300
PLY17BN5620R8A2	5,6	210	0,8	300
PLY17BN7820R7A2	7,8	290	0,7	300
PLY17BN9320R6A2	9,3	350	0,6	300

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Тип В

Наименование	Индуктивность обмотки, мГн	Дифференц. индуктивность	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В~
PLY17BN4912R4B2	0,49	24	2,4	300
PLY17BN9612R0B2	0,96	47	2,0	300
PLY17BN1023R0B2	1,0	47	3,0	300
PLY17BN1121R8B2	1,1	58	1,8	300
PLY17BN1721RSB2	1,7	88	1,5	300
PLY17BN2921R2B2	2,9	140	1,2	300
PLY17BN3721R0B2	3,7	180	1,0	300
PLY17BN5620R8B2	5,6	280	0,8	300
PLY17BN7820R7B2	7,8	390	0,7	300
PLY17BN9320R6B2	9,3	460	0,6	300

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

Тип А

Наименование	Индуктивность обмотки, мГн	Дифференц. индуктивность	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В~
PLY17BS4912R4A2	0,49	18	2,4	250
PLY17BS9612R0A2	0,96	35	2,0	250
PLY17BS1023R0A2	1,0	36	3,0	250
PLY17BS1121R8A2	1,1	44	1,8	250
PLY17BS1721R5A2	1,7	67	1,5	250
PLY17BS2921R2A2	2,9	110	1,2	250
PLY17BS3721R0A2	3,7	140	1,0	250
PLY17BSS620R8A2	5,6	210	0,8	250
PLY17BS7B20R7A2	7,8	290	0,7	250
PLY17BS9320R6A2	9,3	350	0,6	250

Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

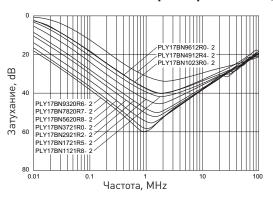
Дроссели для подавления помех Murata (продолжение)

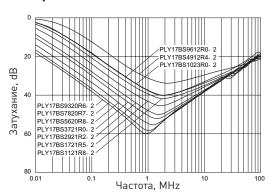
Тип В

Наименование	Индуктивность обмотки, мГн	Дифференц. индуктивность	Допустимый ток, А	Допустимое напряжение, В~
PLY17BS4912R4B2	0,49	24	2,4	250
PLY17BS9612R0B2	0,96	47	2,0	250
PLY17BS1023R0B2	1,0	47	3,0	250
PLY17BS1121R8B2	1,1	58	1,8	250
PLY17BS1721RSB2	1,7	88	1,5	250
PLY17BS2921R2B2	2,9	140	1,2	250
PLY17BS3721R0B2	3,7	180	1,0	250
PLY17BSS620R3B2	5,6	280	0,8	250
PLY17BS7B20R7B2	7,8	390	0,7	250
PLY17BS9320R6B2	9,3	460	0,6	250

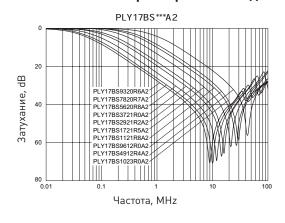
Диапазон рабочих температур: от -25 до 120 °C. Допустимый перегрев обмоток: 60 °C (при номинальном токе).

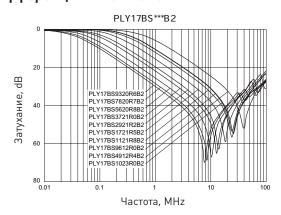
Характеристика подавления синфазной помехи



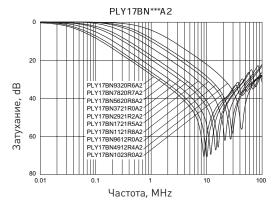


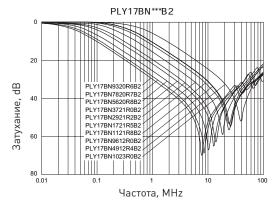
Характеристика подавления дифференциальной помехи





Характеристика подавления дифференциальной помехи





Оптопары Vishay

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	напряж	ое макс, , коллек- иттер, В	Особен- ности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
	DIP-6,		10 20					10 20			
4N25/4N26/4N27/ 4N28	Option 6 SMD-6, Option 7 SMD-6, Option 9	5300				60					UL, VDE
4N25V/4N25GV/ 4N35V/4N35GV	DIP-6	5300	100 20			60		20			UL, BSI, VDE, Nordic
	DIP-6		100 20					100 20			
4N35/4N36/4N37/ 4N38	DIP-6, Option 6 SMD-6, Option 7 SMD-6, Option 9	5300				60				10/10	UL, VDE
CNY117	DIP-6	5300	100 160 40 63	200 320 80 125		60	70	100 160 40 63	110 °C Specification		UL, CSA, VDE
CNY117F	DIP-6	5300	100 160 40 63	200 320 80 125		60	70	100 160 40 63	110 °C Specification		UL, VDE
	DIP-6		100 160 40 63	200 320 80 125				100 160 40 63			
CNY17	DIP-6, Option 6	5300				60	70	100 160 40 63 100			UL, BSI, VDE, Nordic
	SMD-6, Option 7							160 40 63 100			
	SMD-6, Option 9							160 40 63			
	DIP-6		100 160 40 63	200 320 80 125				100 160 40 63			
CNY17F	DIP-6, Option 6	5300				60	70	100 160 40 63			UL, BSI, VDE, Nordic
	SMD-6, Option 7							100 160 40 63			INDIUIC
	SMD-6, Option 9							100 160 40 63			
CNY17G-1 CNY17G-2 CNY17G-3 CNY17G-4	DIP-6	3750	40	80 125 200 320		60	32	40 63 100 160	Standard	11,0/7,0	UL, BSI, VDE, Nordic

		Изоляция,	Мин,	Макс,	Мин,	Макс,		ое макс,		Время	Стандарт
Наименование	Корпус	В~	коэфф, пе- редачи, %	коэфф, пе- редачи, %	ток, мА	ток, мА	напряж тор/эм	, коллек- иттер, В	Особенности	вкл,/время выкл,, мкс	
CNY64			реда ил ло	реда ил ло	1117	1-17-1	100,511	Птер, Б		Donoth Hite	Пости
CNY64A											
CNY64B											
CNY65	4 pin	8.2	50	300		75	32	50	Standard	5,0/3,0	UL, VDE
CNY65A											,
CNY65B											
CNY66											
CNY74-2H	DIP-8	F000	Ε0.	/00		/0	70	F0	C+	/ 0/5 0	III CC A
CNY74-4H	DIP-16	5000	50	600		60	70	50	Standard	6,0/5,0	UL, CSA
CNY75A								63			
CNY75B								100			
CNY75C	DIP-6	3750				60	90	160	Standard		UL, BSI, VDE,
CNY75GA	DIP-6	3/50	15			60	90	15	Standard		Nordic
CNY75GB								100			
CNY75GC								160			
CQY80N/CQY80NG	DIP-6	3750				60				11/7,0	UL, BSI, VDE,
			10					10		, ., .	Nordic
	DIP-6		20					20			
	5 0		30					30			
			50					50			
H11A1/H11A2/H11A3/ H11A4/H11A5	DIP-6,	5300				60				3/3	UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
HTTA4/HTTA5	Option 6										VDE, Noraic
	SMD-6, Option 7										
	SMD-6,										
	Option 9										
	DIP-6										
H11D1/H11D2/H11D3/	SMD-6, Option 7	5300				60				5/6	UL, BSI, VDE,
H11D4	SMD-6, Option 9	1									Nordic
IL1	DIP-6										
161	DIP-6,	5300	20	300	10	60	50	20	Standard		UL, VDE
IL1-X006	Option 6	3300	20	300	10		30	20	Standard		OL, VDL
IL1205AT	<u>'</u>		40	80				40			
IL1206AT	SOIC-8	4000	63	125	-	60	70	63	110 °C	3,0/3,0	UL, CSA, VDE
IL1207AT	3010 0	4000	100	200	-	00	/ 0	100	Specification	3,0/3,0	OL, COA, VDL
			100					100			
IL1208AT	515 /			320							
IL2	DIP-6										
IL2-X006	DIP-6,	F000			10	/ 0	70	100	6		
	Option 6	5300			10	60	70	100	Standard		UL, VDE
IL2-X009	SMD-6, Option 9										
11.001	Орион 7										
IL201	515 (4.5					4.5			
IL202	DIP-6		15					15			
IL203		F000			10	/ 0	70		6		
IL203-X007	SMD-6,	5300			10	60	70		Standard		UL, VDE
	Option 7	-	225	450				225			
IL203-X009	SMD-6, Option 9										
	•		100	200				100			
IL205AT/206AT/207AT/			100	320	1			100			
208AT	SOIC-8	4000	40	80	-	60	70	40			UL, CSA, VDE
			63	125	1			63	1		
IL211AT	SOIC-8	4000	20	143		60	30	20	Standard		UL, VDE
	301C-0	4000				00	30		Stanualu		OL, VDE
IL212AT			50					50			
IL213AT			100					100			
IL215AT			20					20			
I	SOIC-8	4000	50			60	30	50	Standard		UL, VDE
IL216AT											
IL216AT IL217AT			100					100			

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	напряж,	ое макс, коллек- иттер, В	Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
IL5	DIP-6		рода п., то	рода, то							
IL5-X009	SMD-6, Option 9	5300			10	60	70	50	Standard		UL, VDE
IL74	DIP-6										III DCI CCA
IL74-X006	DIP-6, Option 6		12,5		16	60	20	12,5	Standard		UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
ILCT6	DIP-8										
ILCT6-X007	SMD-8, Option 7	5300	20		10		30	20	Standard		UL, BSI, CSA, VDE
ILCT6-X009	SMD-8, Option 9										
ILD1	DIP-8		20	300			50				111
ILD1-X007	SMD-8, Option 7 SMD-8,	5300			10	60		20	Standard		UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
	Option 9		/0	00				/0			
ILD1205T	SOIC-8	4000	40 63	80 125				63	110 °C		UL, CSA, VDE
ILD12061	5010-8	4000	100	200				100	Specification		UL, CSA, VDE
ILD12071			40	80				40			
ILD1615-2	_		40	00				63	440.00		LII DOLOGA
ILD1615-3	DIP-8	5300			10	60	70	100	110 °C Specification	3,0/2,3	UL, BSI, CSA, VDE
ILD1615-4								160			
ILD2	DIP-8										
ILD2-X006	DIP-8, Option 6	_									
ILD2-X007	SMD-8, Option 7	5300			10	60	70	100	Standard		UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
ILD2-X009	SMD-8, Option 9										
			100	200				100			
ILD205T/206T/207T/			100					100			
211T/213T/217T	SOIC-8	4000	20				70	20			UL, CSA, VDE
			40	80				40			
			63	125				63			
ILD5	DIP-8	E200			10	/0	70	EO	Chandand		UL, BSI, CSA,
ILD5-X009	SMD-8, Option 9	5300			10	60	70	50	Standard		VĎE, Nordic
ILD610-1	DIP-8							40	_		
ILD610-2		-		105				/ 2			
ILD610-2X007	SMD-8, Option 7			125				63			
ILD610-3	DIP-8										
ILD610-3X006	DIP-8, Option 6	5300		200				100	Standard		UL, BSI, CSA, VDE
ILD610-3X009	SMD-8, Option 9										
ILD610-4	DIP-8										
ILD610-4X009	SMD-8, Option 9			320				160			

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	напряж,	ое макс, коллек- иттер, В	Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
ILD615-1	DIP-8		13					13			
ILD615-1X007	SMD-8, Option 7							40			
ILD615-2	DIP-8	-							-		
ILD615-2X006	DIP-8, Option 6							63			
ILD615-2X009	SMD-8, Option 9										
ILD615-3	DIP-8	-							-		
ILD615-3X006	DIP-8, Option 6	5300			10	60	70		Standard		UL, BSI, CSA, VDE
ILD615-3X007	SMD-8, Option 7							100			
ILD615-3X009	SMD-8, Option 9										
ILD615-4	DIP-8										
ILD615-4X006	DIP-8, Option 6							160			
ILD615-4X009	SMD-8, Option 9										
ILD621	DIP-8		50	600							
ILD621-X006		-									
ILD621-X007	SMD-8, Option 7							50			UL, BSI, VDE,
ILD621-X009	SMD-8, Option 9				1,0	60			Standard		Nordic
ILD621GB	DIP-8	_									
ILD621GB-X007	SMD-8, Option 7						400	100			
ILD74	DIP-8										
ILD74-X006	DIP-8, Option 6										UL, BSI, CSA,
ILD74-X007	SMD-8, Option 7		12,5		16	60	20	12,5	Standard		VDE, Nordic
ILD74-X009	SMD-8, Option 9										
ILQ1	DIP-16		20	300							III DCI CCA
ILQ1-X009	SMD-16, Option 9	5300			10	60	50	20	Standard		UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
ILQ1615-1			40	80				40			
ILQ1615-2	DIP-16	5300			10	60	70	63	110 €C	3,0/ 2,3	UL, BSI, CSA,
ILQ1615-3	DIF-10	3300			10	00	/0	100	Specification	2,3	VDE
ILQ1615-4								160			
ILQ2 ILQ2-X009	DIP-16 SMD-16,	5300			10	60	70	100	Standard		UL, BSI, CSA,
	Option 9	- 3300			10		70		Standard		VDE, Nordic
ILQ5	DIP-16		10					50			
ILQ615-1 ILQ615-1X009	DIP-16 SMD-16,	_	13					13 40			
ILQ615-2	Option 9 DIP-16	_							-		
ILQ615-2X007	SMD-16,	-						63			
ILQ615-3	Option 7 DIP-16	-							-		
ILQ615-3X006	DIP-16, Option 6	5300			10	60	70	100	Standard		UL, BSI, CSA, VDE
ILQ615-3X009	SMD-16, Option 9	-									
ILQ615-4	DIP-16	-							-		
ILQ615-4X007	SMD-16, Option 7	-						160			
ILQ615-4X009	SMD-16, Option 9	-						100			

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	напряж,	ое макс, коллек- иттер, В	Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
ILQ621	DIP-16		50	600							
ILQ621-X006	SMD-16,										
ILQ621-X007	Option 7							50			
ILQ621-X009	SMD-16, Option 9										
ILQ621GB					1,0	60			Standard		UL, BSI, VDE,
ILQ621GB-X006	DIP-16				,						Nordic
ILQ621GB-X007	SMD-16, Option 7						500	100			
ILQ621GB-X009	SMD-16, Option 9										
ILQ74	DIP-16										UL, BSI, CSA,
ILQ74-X009	SMD-16, Option 9		12,5		16	60	20	12,5	Standard		VDE, Nordic
K3010P/K3010PG Series	DIP-6	3750				80					UL, BSI, VDE, Nordic
K814P	DIP-4	5000	20	300		60	70	20	Standard	6,0/5,0	UL, CSA
K817P			50	600				50	-		
K817P1				80				40	-		
K817P2				125	-			63	-		
K817P3 K817P4	-			200 320				100	-		
K817P4	DIP-4	5000		150		60	70	50	Standard	6,0/5,0	UL, CSA
K817P6				300				100	-		
K817P7	-			160				80	1		
K817P8				260				130	1		
K817P9				400				200	1		
K824P	DIP-8	5000				60	70	20	Standard	6,0/5,0	UL, CSA
K827PH	DIP-8	5000		600		60	70	50	Standard	6,0/5,0	UL, CSA
K844P	DIP-16	5000		/00		60	70 70	20 50	Standard	6,0/5,0	UL, CSA
K847PH MCT5210	DIP-16	5000	70	600		60	/0	70	Standard	6,0/5,0	UL, CSA
MCT5211	DIP-6		70					70	-		
MCT5211-X007	SMD-6, Option 7	5300			3,0	40	30	110	Standard		UL, BSI, CSA, VDE
MCT5211-X009	SMD-6, Option 9										
MCT6	DIP-8										
MCT6-X007	SMD-8,	E200	20		10		20	20	Ctondond		UL, BSI, CSA,
	Option 7	5300	20		10		30	20	Standard		VDE
MCT6-X009	SMD-8, Option 9										
MCT62H MCT6H	DIP-8	5000	50			60	70	100 50	Standard	6,0/5,0	UL
M0C8101	DIP-6						30				
MOC8101-X006	DIP-6,										
	Option 6 SMD-6,		50	80				50			
MOC8101-X007	Option 7		30	00				30			
MOC8101-X009	SMD-6,	-									
	Option 9								-		
MOC8102	DIP-6	-									
MOC8102-X006	DIP-6, Option 6										
MOC0102 V007	SMD-6,	1		117				73			
MOC8102-X007	Option 7	5300			10	60			Standard	3,0/2,3	UL, BSI, CSA,
MOC8102-X009	SMD-6, Option 9	3300			10	00			Stanuaru	3,0/2,3	VDE
M0C8103	DIP-6			173	-		30	108	-		
MOC8104								-			
MOC8104-X006 MOC8104-X009	SMD-6,			256			160	160			
MOC8105	Option 9 DIP-6	-			-		30		+		
MOC8105-X006	DIP-6, Option 6	-		133				65			
MOC8105-X009	SMD-6, Option 9						65				

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	напряж,	ое макс, , коллек- иттер, В	Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
MOC8111	DIP-6										
MOC8111-X006	DIP-6, Opt. 6		20					20			
MOC8111-X007	SMD-6, Option 7										
M0C8112	DIP-6	5300			10	60	30		Standard		UL, BSI, CSA, VDE
MOC8112-X006	DIP-6, Opt. 6										VDL
MOC8112-X007	SMD-6, Option 7							50			
MOC8112-X009	SMD-6, Option 9										
SFH1617A-1			40	80				40			
SFH1617A-2	DIP-4	5300		125		60		63	110 °C	3,0/2,3	UL, CSA, VDE
SFH1617A-3		0000		200				100	Specification	0,0/2,0	OL, CSA, VBL
SFH1617A-4				320				160			
SFH1690AT/BT/CT/ ABT	SOP-4	3750				50	70	100 50	110 °C Specification	5,0/3,0	UL, CSA, VDE
SFH600-0	DIP-6										
SFH600-0X007	SMD-6, Option 7		40	80				40			
SFH600-1	DIP-6										
SFH600-1X007	SMD-6, Option 7			125				63			
SFH600-1X009	SMD-6, Option 9	F200							Chandand		UL, BSI, CSA,
SFH600-2	DIP-6	5300							Standard		VDE
SFH600-2X006 SFH600-2X007	SMD-6, Option 7			200				100			
SFH600-3	DIP-6								_		
SFH600-3X006	DIP-6,0pt. 6			000				4.0			
SFH600-3X007	SMD-6, Option 7			320				160			
SFH601-1	DIP-6										
SFH601-1X006	DIP-6, Option 6										
SFH601-1X007	SMD-6, Option 7		40	80				40			
SFH601-1X009	SMD-6, Option 9										
SFH601-2	DIP-6								-		
SFH601-2X006	DIP-6, Option 6										
SFH601-2X007	SMD-6, Option 7			125				63			
SFH601-2X009	SMD-6, Option 9	F200							Chand		UL, BSI, CSA,
SFH601-3	DIP-6	5300							Standard		VDE
SFH601-3X006	DIP-6, Option 6										
SFH601-3X007	SMD-6, Option 7			200				100			
SFH601-3X009	SMD-6, Option 9										
SFH601-4	DIP-6										
SFH601-4X006	DIP-6, Option 6										
SFH601-4X007	SMD-6, Option 7			320				160			
SFH601-4X009	SMD-6, Option 9										

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	напряж.	ое макс, коллек- иттер, В	Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
SFH608-2	DIP-6										
SFH608-2-X006	DIP-6, Option 6										
SFH608-2-X007	SMD-6, Option 7							63			
SFH608-2-X009	SMD-6, Option 9										
SFH608-3	DIP-6			200							
SFH608-3-X006	DIP-6, Option 6							100			
SFH608-3-X007	SMD-6, Option 7	5300				50			Standard	8,0/7,5	UL, BSI, CSA, VDE
SFH608-4	DIP-6			320							
SFH608-4-X006	DIP-6, Option 6							160			
SFH608-4-X007	SMD-6, Option 7										
SFH608-5	DIP-6			500							
SFH608-5-X007	SMD-6, Option 7							250			
SFH6106-1			40	80				40			
SFH6106-2				125				63	-		
SFH6106-3	SMD-4			200				100			
SFH6106-4				320				160			
SFH6106-5T				500				250			
SFH610A-1	DID (40	80							
SFH610A-1X006	DIP-4							40			
SFH610A-1X018T	SMD-4										
SFH610A-2		5300		125		60		63	Standard		UL, BSI, CSA, VDE
SFH610A-2X006								0.5			
SFH610A-3	DIP-4			200							
SFH610A-3X006								100			
SFH610A-3X007	SMD-4										
SFH610A-4				320							
SFH610A-4X006	DIP-4							160			
SFH610A-5				500				250	1		

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	Обратное мак напряж, колле тор/эмиттер,	к- Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
SFH6156-1			40	80			40			
SFH6156-2	SMD-4			125			63			
SFH6156-3	_ 3.45 4			200			100			
SFH6156-4	515 (_		320			160			
SFH615A-1	DIP-4	_	40	80						
SFH615A-1X006	DIP-4, Option 6						40			
	SMD-4,	-					40			
SFH615A-1X007	Option 7									
SFH615A-2	DIP-4	-		125	-			_		
	DIP-4,	_		123	-					
SFH615A-2X006	Option 6									
0511/454 01/005	SMD-4,						63			
SFH615A-2X007	Option 7									
CELL/4EA 0V000	SMD-4,	1								
SFH615A-2X009	Option 9									
SFH615A-3	DIP-4	5300		200]	60		Standard	3,0/2,3	UL, VDE
CEU/154 3V00/	DIP-4,	3300			1	00		Statiualu	3,0/2,3	OL, VDE
SFH615A-3X006	Option 6									
SFH615A-3X007	SMD-4,									
3F11013A-3X007	Option 7						100			
SFH615A-3X008	SMD-4,									
51 110 1071 07000	Option 8									
SFH615A-3X009	SMD-4,									
	Option 9	-		000				_		
SFH615A-4	DIP-4	-		320	-					
SFH615A-4X006	DIP-4,									
	Option 6	-								
SFH615A-4X007	SMD-4,						160			
	Option 7 SMD-4,	-					160			
SFH615A-4X008	Option 8									
	SMD-4,	-								
SFH615A-4X009	Option 9									
SFH617A-1	97									
SFH617A-1X006							40			
SFH617A-1X000	DIP-4							\dashv		
SFH617A-2X006	\dashv						63			
SFH617A-2X009	SMD-4	-								
SFH617A-3		F000				/ 0		110 °C	0.0/0.0	LIL CCA VDE
SFH617A-3X006	DIP-4	5300				60	100	Specification	3,0/2,3	UL, CSA, VDE
	SMD-4	-					100			
SFH617A-3X007	SMD-4	-						\dashv		
SFH617A-4							1,10			
SFH617A-4X006	DIP-4						160			
SFH6186-2			63	125			63			
SFH6186-3				200			100			
SFH6186-4	SMD-4			320	1		160			
	\dashv			500	-		250	_		
SFH6186-5		_			-			_		
SFH618A-2	DIP-4		63	125			63			
SFH618A-3	DII 4			200						
CELL/404 0V00/	DIP-4,				1					
SFH618A-3X006	Option 6						100			
	SMD-4,	5300				60		Standard	6,0/5,5	UL, CSA, VDE
SFH618A-3X007	Option 7	3300				00		Statiualu	0,0/3,3	OL, CSA, VDE
SFH618A-4	DIP-4	-		320	1					
31 110 10A-4		-		320	-		160			
SFH618A-4X006	DIP-4,						100			
CELL/404 5	Option 6	-		F00	-			_		
SFH618A-5	DIP-4	_		500						
SFH618A-5X006	DIP-4,									
51 110 10A-0A000	Option 6						250			
SFH618A-5X007	SMD-4, Option 7									
SFH636	DIP-6									
	DIP-6,	+								
SFH636-X006	Option 6									
		5300			16	25	19	Standard		UL, VDE
SFH636-X007	SMD-6,									
	Option 7	-								
SFH636-X009	SMD-6									

Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	Обратное макс, напряж, коллек- тор/эмиттер, В		Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
SFH640-1	DIP-6		40	80				40			
SFH640-2	SMD-6,	-		125		60		63			
SFH640-2X007	Option 7 DIP-6 SMD-6, Option 7 SMD-6, Option 9			120	10						III DCI CCA
SFH640-3		5300/7500		200			300		Standard	5,0/6,0	UL, BSI, CSA, VDE
SFH640-3X007		-						100			VDL
SFH640-3X009											
SFH690ABT SFH690AT	SOP-4		50	300				50	Standard	5,0/3,0	UL, BSI, CSA
SFH690BT		3750				50		100			
SFH690CT SFH690DT								200			
SFH6916	SMD-16 SOP-16	3750	50		5,0 5,0	50		50	Standard		UL
SFH6942A	301 10				0,0						
SFH6942AT		1768						78	Standard	3/3,1	UL, CSA
SFH6943A-2			+					63			
SFH6943A-3	SMD	1768		320				100	- Standard	3/3,1	UL, CSA
SFH6943A-4	55			500	1			160	Statiualu		
TCDT1100				- 555				1.50			
TCDT1100G			40					40		11,0/7,0	UL, BSI, VDE Nordic
TCDT1101											
TCDT1101G				80							
TCDT1102	DIP-6	3750			1	60	32		Standard		
TCDT1102G				125				63			
TCDT1103									-		
TCDT1103G				200				100			
TCDT1110											
	DIP-6	3750	100			60	70	100	Standard	15,0/15,0	UL, BSI, VDE, Nordic
TCDT1110G											rvoruic
TCDT1120		3750	10			60	90	10	- Standard		UL, BSI, VDE, Nordic
TCDT1120G											
TCDT1122								63			
TCDT1122G	DIP-6										
TCDT1123								100			
TCDT1123G											
TCDT1124								160			
TCDT1124G											
TCET1100	_	5000	13	600				13 50	Standard	6,0/5,0	UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
			13	- 000		60	70	13			
TCET1100G				600				50			
			13					13			
CET1101								40			
TCET1101G	DIP-4		13					13			
								40			
TCET1102 TCET1102G								63			
TCET1103											
TCET1103G								100			
TCET1104								1/0			
TCET1104G				150	-			160			
TCET1105								50			
TCET1105G											
TCET1106								100			
TCET1106G TCET1107											
TCET1107				160				80			
TCET11076				_	-						
TCET1108G				260				130			
TCET1109				/00				000			
TCET1109G				400				200			

Security	Наименование	Корпус	Изоляция, В~	Мин, коэфф, пе- редачи, %	Макс, коэфф, пе- редачи, %	Мин, ток, мА	Макс, ток, мА	напряж	ое макс, , коллек- иттер, В	Особенности	Время вкл,/время выкл,, мкс	Стандарт безопас- ности
TCET1110/TCET11106 DIP-4 5000 22 34 500 400 22 34 50 50 50 50 600 50 600 50 600 50 600 50 600 50 600 50 600 50 600 50 600 50 600 60					300							
TCET1110/TCET11106 DIP-4 S000 22 34 Specification S000 S6 S0 S6 S6 S6 S6	TCET1110/TCET1110G											
TCET1110/TCET11106 DIP-4 5000										-		
					400					440.00		
SO 150 50 50 50 50 56 56 56		DIP-4	5000				60			110 °C Specification	6/5	UL, BSI, VDE, Nordic
Su					150							
SOUTH SOUT				50					50			
TCET12001				56					56			
TCET1200/ TCET12000												
TCET1200/ TCET12006/TCET2200 DIP-4 5000 DIP-4 5000 DIP-5 DIP-8 5000 DIP-8 5000 5000 600 1000 600 600 600									_			
TCET1200/ TCET1200	TCET1200/		5000				60				6,0/5,0	
TCET1200/ TCET1200G/TCET2200												UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
TCET1200G/TCET2200 TCET1200G/TCET2200 DIP-8 DIP-8						-						
TCET2100 DIP-8 S00 600 S0 600 S0 50 600 TCET4100 DIP-16 S000 S0 S00 S0 Standard 6,0/5,0 UL, E VDE		DIP-4		00	125							
DIP-8 S0 600 S0 600 S0 Standard 6,0/5,0 UL VDE	TCE11200G/TCE12200											
DIP-8									40			
TCET2100									50			
TCET2100 DIP-8 TCET4100 DIP-16												
TCLT1100	TCFT0400			50	600				50			50. 00.
TCLT110 Series SOP-4 5000	TCFT4100		5000	50	600		60	70	50	Standard	6,0/5,0	UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
TCLT110 Series	10214100	Bii 10		400	200				100			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
TCLT110 Series	TCLT10 Series	SOP-4	5000	100			60		100	6/5		UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
TCLT110 Series				130	260						6/5	
SOP-16 S				200					200			
Sop-16 S				50					50			
CLT1100				Γ/	600				F/			
SMD-5 SMD-					125							
TCLT1100												
TCLT1103	TCLT1100											
TCLT1105	TCLT1102		5000				60		70 63 100 50 100 80			
SMD-5 SMD-		SMD-5								Standard	6,0/5,0	UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
TCLT1108 TCLT1109 260 400 130 200 100 100 100 100 TCLT1110 Series SOP-6 5000 100 100 130 160 130 160 130 160 130 160 100 100 100 100 100 100 6,0/5,0 UL, EVDE VDE VDE VDE VDE 40 Specification 6,0/5,0 UL, EVDE VDE VDE 40 Specification 6,0/5,0 UL, EVDE VDE VDE VDE 40 Specification 6,0/5,0 UL, EVDE 40 40 40 Specification 6,0/5,0 UL, EVDE 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 <td< td=""><td>TCLT1106</td><td></td><td>300</td><td>70</td></td<>	TCLT1106				300			70				
TCLT1109 TCLT1110 Series SOP-6 SOP-16 SOP-												
TCLT1110 Series SOP-6 SOP-6 SOP-16	TCI T1108											
TCLT1110 Series SOP-6 5000				100								
TCLT1110 Series SOP-6 5000	TCLT1110 Series	SOP-6	5000	100	300		60		100	110 °C Specification	6,0/5,0	UL, BSI, CSA, VDE, Nordic
TCLT1110 Series SOP-6 5000 200 400 40 80 40 80 50 60 50 600 50 600 50 600 50 600 600												
SOP-16 SUUU 40 80 50 50 50 50 50 50 5												
SOP-16 Sopering and provided by the state of the state												
SOP-16 SOP-16 SO				40					40			
SOP-16 63 125 63 80 100 300 100 50 600 100 200 100				50					50			
SOP-16 80 160 80 100 50 50 100 50 100 100 100 100 100 1				63					63			
SOP-16 100 300 100 50 50 100 100												
50 600	TCMT11 Series/ TCMT410, Series	COD 47										
		SOP-16	3750	50	600		60		50		6/5	UL, CSA, VDE
				100	200				100			
					300							
TCNT11 Carrier /									130			
TCMT410. Series 3730 160 320 60 160 673 61, 6												
				200					200	-		
50 150 50				50					50			
63 125 63				63					63			
80 160 80												

Список рекомендуемой литературы

- 1. Кучеров Д.П., Куприянов А.А. Современные источники питания ПК и периферии. Полное руководство.
- 2. Мэк Р. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению.
 - 3. Браун М. Источники питания. Расчёт и конструирование.
- 4. Семенов Б. Силовая электроника: от простого к сложному. Импульсные источники электропитания. Перспективная элементная база. Основы инженерного проектирования. Практические конструкции.
 - 5. Гейтенко Е. Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчеты.
 - 6. Рязанов М.Г. Импульсные источники питания телевизоров.
 - 7. Готтлиб И. Источники питания. Инверторы. Конверторы. Линейные и импульсные стабилизаторы.
 - 8. Янковский С. Импульсные источники питания телевизоров.